

دانشگاه صنعتی شهرود

دانشکده فیزیک

پایان نامه کارشناسی ارشد
فیزیک حالت جامد

عنوان:

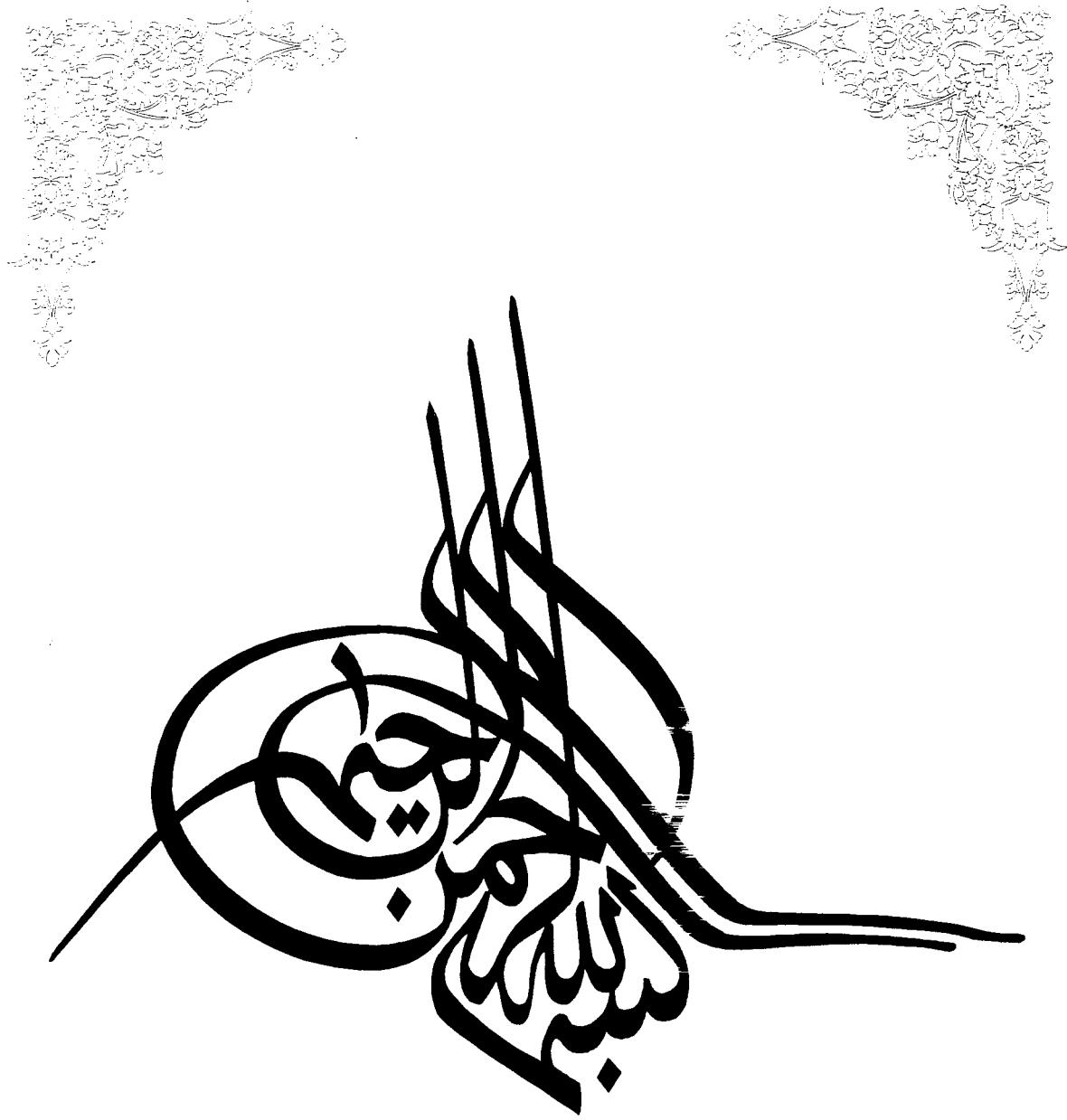
مطالعه تئوری پراکندگی پرتو X تشدید یافته

دانشجو :

عبدالله محمدی تبار

اساتید راهنما:
دکتر محمد ابراهیم قاضی
دکتر هادی عربشاهی

تیر ماه ۱۳۸۴



تقدیم به پدر و مادرم

و به تمام کسانی که به واسطه سخن حضرت امیر

(هر کس که به من کلمه ای بیاموزد، مرا بنده خود ساخته)

تا واپسین روز مفتخر به بندگی آنان هستم.

۱ - ۱ مقدمه

پرتو X در سال ۱۸۹۵ به وسیله رونتگن فیزیکدان آلمانی کشف شد واز آنجا که ماهیتش در آن زمان ناشناخته بود بدین نام خوانده شد. این پرتوها برخلاف نور معمولی نامرئی هستند. اما مسیر مستقیمی را می پیمایند و فیلم عکاسی را مانند نور مرئی متاثر می کنند. از سوی دیگر از نور با نفوذتر بوده و به آسانی از بدن انسان، چوب، قطعات نسبتاً ضخیم فلزی و دیگر اشیاء کدر عبور می کنند. فیزیکدان ها و چنینی سهندسان علاقمند به مطالعه ساختار درونی اجسام، پرتوهای X را بکار گرفتند. با قراردادن لامپ پرتو X در یک سوی جسم و فیلم عکاسی در سوی دیگر، می توان تصویری سایه مانند و یا پرتو نثار به دست آورد، بخش هایی از جسم با چگالی کمتر، نسبت به بخش هایی با چگالی بیشتر مقدار بیشتری از تابش X را عبور می دهند. بدین وسیله نقطه شکست در استخوانی شکسته و یا محل ترکی در یک فلز قالب گیری شده مشخص می شود.

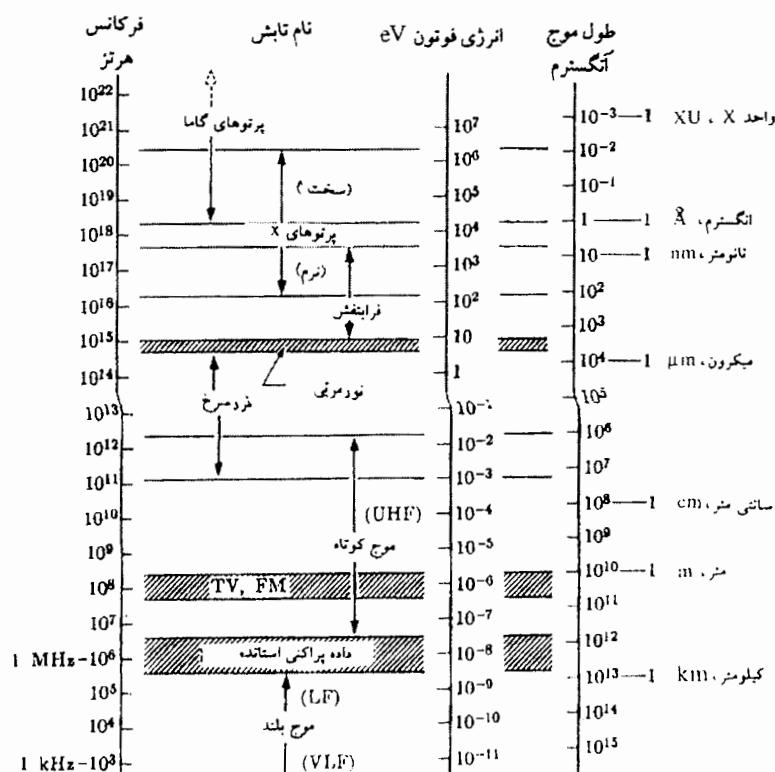
ماهیت کامل پرتوهای X تا سال ۱۹۱۲ مشخص نبود. در این سال، پدیده پراش پرتو X در بلورها کشف شد، و همزمان با این کشف، ماهیت موجی پرتوهای X به اثبات رسید از این رو، روش جدیدی برای بررسی ساختار ماده فراهم شد.

۱ - ۲ تابش الکترومغناطیسی

امروزه می داییم که پرتوهای γ ، تابش الکترومغناطیسی با ماهیتی کاملاً همانند نور مرئی، اما با طول موجی بسیار کوتاهتر از آن هستند. واحد اندازه کیمی در ناحیه پرتو γ ، انکسترم، (10^{-12}) برابر با

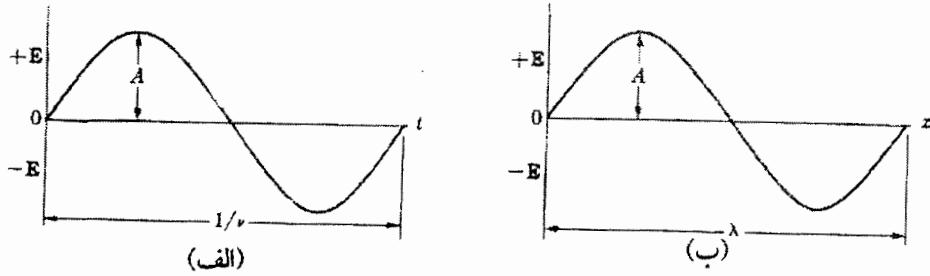
$10^{-8} \text{ cm}^2/\text{Å}^2$ است و پرتوهای X بکار رفته در پراش، تقریباً طول موج هایی در گستره $\text{Å}^{0.5}$ تا $\text{Å}^{2.5}$ است.

دارند، در حالی که طول موج نور مرئی در محدوده $\text{Å}^{4500-7000}$ است. پرتوهای X ناحیه ای میان پرتوهای گاما و فرابنفش را در طیف کامل الکترومغناطیسی اشغال می کنند (شکل ۱-۱). فرض کنید باریکه ای تکفام از پرتوهای X با طول موج مشخص در جهت محور x شکل ۱-۱ حرکت می کند. آنگاه با این موج، یک میدان الکتریکی E در جهت z ، و یک میدان مغناطیسی H در جهت Z (عمود بر راستای انتشار) همراه است. اگر هنگامی که موج در حرکت است، میدان الکتریکی



شکل ۱-۱: طیف الکترومغناطیسی. مرز میان نواحی بالا اختباری است، زیرا حدود دقیق بالایی و پایینی رانمی توان مشخص نموده [۱].

محدود به صفحه ۲۰ باشد. گفته می شود که موج، قطبی صفحه ای است. (در یک موج کاملاً غیر قطبی، بردار میدان الکتریکی E و در نتیجه بردار میدان مغناطیسی H می توانند تمام جهت ها



شکل ۱-۳: تغییرات E ، (الف) با t در مقدار ثابت x و (ب) با x در مقدار ثابت t .

۱-۳ طیف ویژه

اتمی را با هسته ای مرکزی در نظر بگیرید که پیرامون آن را الکترونها در پوسته های گوناگون فرا گرفته اند (شکل ۱-۴). نشانه های M, L, K در رابطه با عدد کوانتمی $n=1, 2, 3, \dots$ هستند. اگر یکی از الکترون هایی که هدف را بمباران می کنند، از انرژی جنبشی کافی برخوردار باشد، می تواند الکترونی را از پوسته K خارج کرده و اتم را در یک حالت برانگیخته با انرژی بالاتر قرار دهد. بی درنگ یکی از الکترون های بیرونی تر در مکان خالی پوسته K قرار می گیرد، و در این فرایند با گسیل انرژی، اتم را دوباره به حالت عادی انرژی خود برمی گرداند. انرژی گسیل شده، به صورت تابشی با طول موج معین است که در واقع تابش ویژه K خواهد بود.

مکان خالی پوسته K ممکن است با الکترونی از هر یک از پوسته های بیرونی تر پر شود، بدین ترتیب به رشته ای از خطوط K ، برای مثال خطوط K_{α} و K_{β} منجر شود که به ترتیب ناشی از پرشدن مکان خالی پوسته با الکترونی از پوسته های L و یا M خواهد بود. مکان خالی لایه K را ممکن است از پوسته L و یا از پوسته M پر کرد. بد کونه ای که یکی از اتم های هدف می تواند تابش K_{α} و اتم مجاور با آن تابش K_{β} را منتشر کند، اما پرشدن مکان خالی K با الکترون L محتمل تر از الکترون M است و در نتیجه خط K_{α} از خط K_{β} شدیدتر است.

خطوط ویژه یوتوا، بد وسیله دبلیو. اچ، برگ کشف شد و اچ. جی. موزلی^۱ آن را تنظیم کرد. موزلی،

^۱ W.H.Bragg & H.G.Moseley

۱-۴ جذب

در ک بیشتر از انتقال های الکترونی که در اتم ها رخ می دهد را نه تنها از تأثیر متقابل الکترونها و اتمها، بلکه از تأثیر متقابل پرتوهای X و اتم ها نیز می توان دریافت. هنگامی که پرتوهای X وارد هر نوع ماده ای شوند (شکل ۱-۵)، بخشی از آنها عبور و بخشی جذب می شوند. آزمایش نشان می دهد که کاهش کسری در شدت I باریکه پرتو X هنگام عبور از ماده همگن، با فاصله پیموده شده x به صورت دیفرانسیلی متناسب است:

$$-\frac{dI}{I} = \mu dx \quad (3-1)$$

که در آن ثابت تنااسب μ ضریب جذب خطی خوانده می شود و به ماده مورد مطالعه، چگالی آن، و طول موج پرتوهای X بستگی دارد. انتگرال گیری از معادله (۳-۱) می دهد:

$$I_x = I_0 e^{-\mu x} \quad (3-1)$$

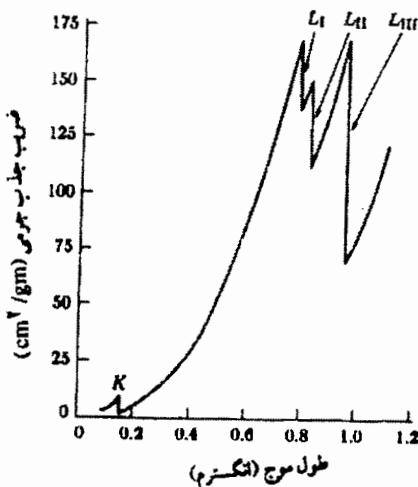
که در آن I_0 شدت باریکه فرودی پرتو X و I_x شدت باریکه عبوری پس از گذشتن از ضخامت x است. ضریب جذب خطی μ متناسب با چگالی ρ است و بدان معنی است که کمیت $\frac{\mu}{\rho}$ برای یک ماده ثابت بوده و مستقل از حالت فیزیکی آن (جامد، مایع، گاز) است. این کمیت را ضریب جذب جرمی می نامند و کمیتی است که معمولاً مقادیر آن برای مواد مختلف معلوم است. در این صورت معادله (۳-۱) را می توان به صورت زیر نوشت:

$$I_x = I_0 e^{-\left(\frac{\mu}{\rho}\right) \mu x} \quad (4-1)$$

کاهی لازم است ضریب جذب جرمی ماده ای، با بیش از یک عنصر را بدانیم: اگر ماده مخلوطی مکانیکی، محلول و یا ترکیب شیمیایی، و یا به صورت حالت جامد، مایع، و یا گاز باشد، ضریب جذب جرمی آن به سادگی میانگین توزین شده ضرایب جذب جرمی عنصر سازنده آن است. اگر μ_1, μ_2, \dots کسرهای وزنی عنصر 1 و $2, \dots$ در ماده، و ρ_1, ρ_2, \dots ضرایب جذب جرمی

کنیم که بجز برای عناصر بسیار سبک، این پدیده فقط کسر کوچکی از جذب کل را تشکیل می‌دهد. جذب واقعی از انتقال‌های الکترونی درون اتم ایجاد می‌شود و بهتر است از دیدگاه نظریه کوانتمی تابشی مورد بررسی قرار گیرد. درست همان‌گونه که الکترونی با انرژی کافی می‌تواند یک الکترون K را برای مثال، از یک اتم خارج کند و باعث گسیل تابش ویژه K شود، یک کوانتم فرودی از پرتوهای X نیز به شرط آن که از همان مقدار کمینه انرژی $\hbar\omega$ برخوردار باشد، توانایی چنین فرایندی را خواهد داشت. در این حالت، الکترون خارج شده را فوتو الکترون و تابش ویژه ایجاد شده را تابش فلورسانس می‌نامند. تابش فلورسانس در تمام جهات و دقیقاً با همان طول موج تابش ویژه ناشی از بمباران الکترونی هدف فلزی انجام می‌شود. (عملای، یک اتم، همان تابش K را بدون در نظر گرفتن چگونگی بوجود آمدن مکان خالی پوسته K در آغاز، گسیل می‌کند). این پدیده همانند پرتو X است که از اثر فوتو الکتریک در ناحیه فرا بنفس طیف ایجاد می‌شود.

اگر منحنی جذب نیکل، α برای طول موج‌های بیشتر از $2/4\text{\AA}$ ، یعنی فراتر از میزان شکل ۱-۶ رسم کنیم، ناپیوستگی‌های تیز دیگری یافت می‌شوند. این ناپیوستگی‌ها لبه‌های جذب L ، M ، N و... هستند، در واقع سه لبه L نزدیک به هم (L_{III}, L_{II}, L_I)، پنج لبه M نزدیک به هم و غیره، مطابق شکل (شکل ۱-۷) وجود خواهند داشت. هریک از این ناپیوستگی‌ها طول موج باریکه فرودی را نشان می‌دهد که کوانتا‌های آن درست دارای انرژی کافی برای خارج سازی یک الکترون K ، M ، N و مانند آنها از اتم است. برای مثال، شاخه سمت راست منحنی ۱-۶، میان لبه‌های جذب K و L قرار می‌گیرد، در این ناحیه از طول موج، پرتوهای X فرودی دارای انرژی کافی برای خارج کردن الکترون-های M, L و مانند آنها از نیکل هستند، اما انرژی کافی برای خارج کردن الکترون‌های K را ندارند. طول موج‌های لبد جذب با عدد اتمی جذب کننده، با کمی تفاوت، اما بد همان کوند تغییر می‌کنند که طول موج‌های گسیلی ویژه تغییر می‌کنند، یعنی بر اساس قانون موزلی، مقادیر اندازه گیری شده لبه‌های جذب را می‌توان برای ساختن یک نمودار تراز-انرژی اتم بکار برد که به نوبه خود می‌تواند در محاسبه طول موج‌های خط ویژه مفید باشد. برای مثال، اگر انرژی



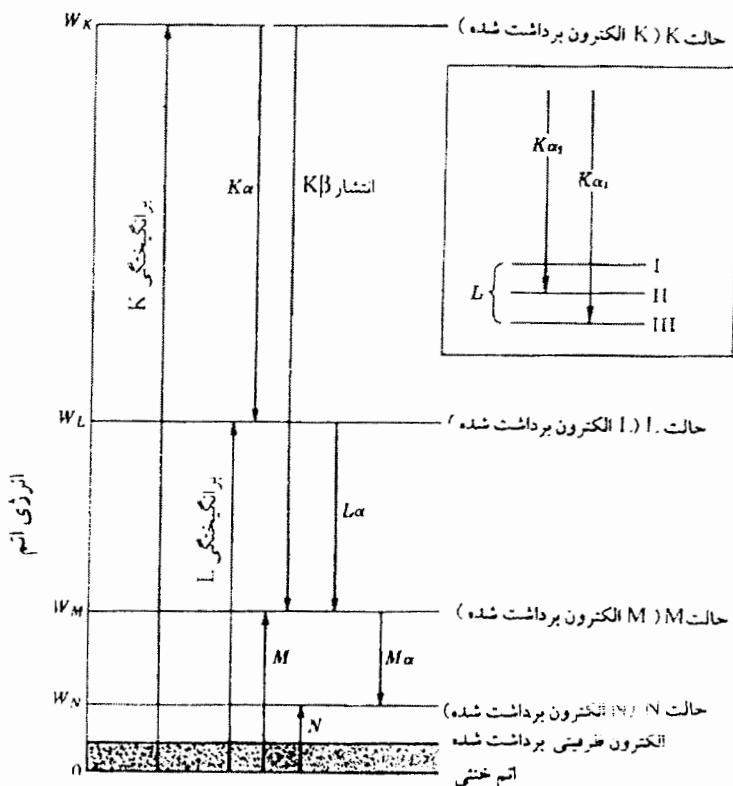
شکل ۱ - ۷: ضرایب جذب سرب که لبه های جذب K و L را نشان می دهد [۱]

atom خنثی، صفر باشد، بنابراین انرژی یک atom یونیزه، کمیت مثبتی است، زیرا برای دور ساختن الکترون از هسته با بار مثبت باید کار انجام داد. اگر یک الکترون از لایه K برداشته شود، باید کاری برابر W انجام داد و از این رو گفته می شود اتم در حالت انرژی K است. انرژی W را می توان از طول موج لبه جذب K با استفاده از معادله زیر محاسبه کرد.

$$W_K = h\nu_K = \frac{hc}{\lambda_K} \quad (7-1)$$

همین طور می توان انرژی ترازهای L ، M و مانند آنها را از طول موج های لبه های جذب L و M با محاسبه کرد و نتایج را به صورت یک نمودار تراز- انرژی برای آن اتم ترسیم کرد (شکل ۱ - ۸). گرچه این نمودار به دلیل نشان ندادن زیر ساختار تمام ترازها، ساده شده است، اما نکات مهم را نمایش می دهد. پیکان ها انتقال های اتم را نشان می دهند، و بنابراین جهت آنها درست مخالف با جهت های شکل ۱ - ۴ است که انتقال های الکترون را نشان می دهد. بدین ترتیب اگر یک الکترون از لایه K از اتمی (یا با یک الکترون فروودی و یا بد وسیله پرتو γ) برداشته شود، اتم بد حالت K برانگیخته می شود. در این صورت اگر الکترونی از تراز L بد K برای پر سازی مکان خالی

حرکت کند، این اتم ناچار به انتقال از حالت L به حالت K می‌شود. این انتقال، به گسیل تابش ویژه منجر می‌شود و بنابراین، پیکان مربوط به گسیل $K\alpha$ از حالت K به حالت L ترسیم می‌شود.



شکل ۱-۸: طرح شماتیک ترازهای انرژی اتمی. فرایندهای برانگیختگی و گسیل به وسیله پیکان نشان داده شده است. شکل بالا سمت راست، ریز ساختار حالت L را نشان می‌دهد [۱].

۱-۵ پراش:

پراش پرتو λ هنگامی رخ می‌دهد که موج حرکتی به مجموعه ای از اجسام پراکننده با فاصله منظم برخورد کند (درست همانند نور مرئی از توری)، البته با این شرط که حلول موج، موج حرکتی دارای بزرگی یکسانی همانند فاصله تکراری میان مراکز پراکننده پرتو λ باشد.

در سال ۱۹۱۲، فیزیکدان آلمانی فن لاده^۱ (۱۸۷۹-۱۹۶۰) موضوع را بررسی و بیان کرد که اگر

بلورها از اتم‌هایی با فاصله منظم تشکیل شده باشند و این اتم‌ها به عنوان مراکزی برای پراکنندگی

^۱ Von Laue

پرتوهای X باشند، و اگر پرتوهایی X امواجی الکترومغناطیس با طول موج تقریباً برابر با فاصله میان اتمی در بلورها باشند، بنابراین امکان پراش پرتوهای X از بلورها باید وجود داشته باشد. گزارش کارهای انجام شده توسط لاهه مورد توجه بسیار زیاد دو فیزیکدان انگلیسی دبلیو. اچ. برآگ^۱ و فرزندش دبلیو. ال. برآگ (۱۸۹۰-۱۹۷۱) قرار گرفت. فیزیکدان اخیر، اگر چه دانشجویی جوان در آن زمان بود (در سال ۱۹۱۲) آزمایش لاهه را به طور موفقیت آمیزی واکاوی کرده و توانست شرایط لازم برای پراش را در شکل ریاضی بسیار ساده تر از آنچه که فن لاهه بکار برد بود، بیان کند. شکل ۹-۱ یک مقطع بلوری را نشان می‌دهد، اتم‌های آن در مجموعه‌ای از صفحات موازی A ، B ، C ، D ... عمود بر صفحه تصویر و به فاصله d از یکدیگر قرار گرفته‌اند. فرض کنید باریکه‌ای از پرتوهای X کاملاً موازی و تکفام با طول موج λ بر روی این بلور با زاویه θ که به آن زاویه برآگ می‌گویند، تابیده می‌شود. پرتوهای پراکنده شده از تمامی اتم‌های موجود در صفحه اول، در جهت موازی با ۱ همفاز هستند و در تقویت باریکه پراشیده شرکت دارند. این موضوع در مورد تمام صفحات بلور به طور جداگانه صادق است و تنها موضوعی که باقی می‌ماند، پیداکردن شرط لازم برای تقویت پرتوهای پراکنده شده از اتم‌های موجود در صفحات مختلف است. برای مثال، پرتوهای ۱ و ۲ از اتم‌های K و L پراکنده می‌شوند و اختلاف مسیر پیموده شده برای پرتوهای ۱ $K1$ و ۲ $L2$ برابر است

: با

$$ML + LN = d' \sin \theta + d' \sin \theta \quad (8-1)$$

اختلاف مسیر بالا برای پرتوهای پراکنده شده از S و P در جهت نشان داده شده، نیز درست است، زیرا در این جهت اختلاف مسیری میان پرتوهای پراکنده شده از S و L و K و P وجود ندارد. پرتوهای پراکنده ۱ و ۲ بد حلوار کامل همفاز خواهند بود اگر این اختلاف مسیر، n (عدد صحیح) برابر طول موج باشد و یا اگر:

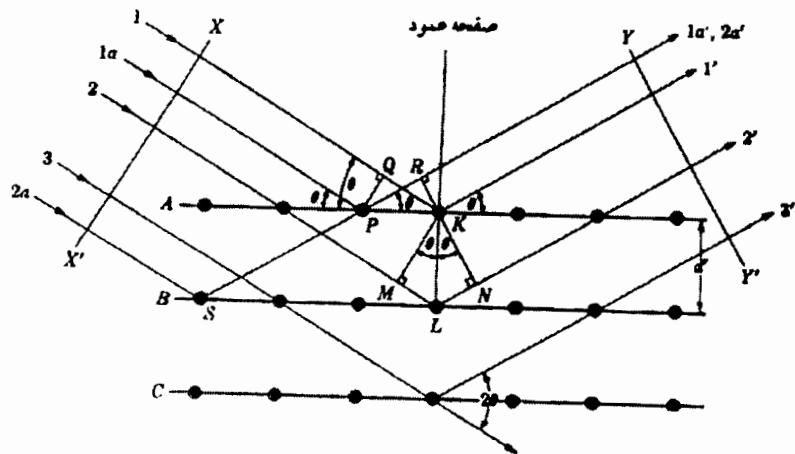
$$n\lambda = 2d' \sin \theta \quad (9-1)$$

^۱-W. H. Bragg

این رابطه را دبليو.ال. برآگ برای نخستین بار ارائه داد و به عنوان قانون برآگ شناخته می شود. اين قانون بیان کننده شرط اساسی ايجاد پراش است. n را مرتبه بازتاب می گويند.

با انتخاب $\alpha/n = \alpha'$ ، قانون برآگ را به شکل زير می نويسيم:

$$\lambda = 2\alpha \sin \theta \quad (10-1)$$



[۲]: پراش پرتوهای X از یک بلور [۲]

پراكندگی از اتم هايي که به طور اتفاقی در فضا قرار گرفته اند، مانند يك گاز تک اتمی، در تمام جهات رخ می دهد و ضعیف است. در این حالت شدت کل برابر با جمع شدت ها با يکدیگر است. در پراكندگی از اتم هايي که به طور متناوب در فضا قرار گرفته اند، مانند يك بلور كامل، تنها در جهت های معدودی که از قانون برآگ پیروی می کنند، پراكندگی قوی بوده که به آنها پراش می گويند. در این صورت دامنه ها با يکدیگر جمع می شوند و شدت کل متناسب با محدود دامنه کل می باشد. در بيشتر جهت ها، پراكندگی ها از قانون برآگ پیروی نکرده و پرتوهای پراكنده يکدیگر را از بين می برنند. موقعیت اتم ها در يك سلول واحد، شدت های باريکه های پراشیده را متاثر ساخته، اما تأثیری بر روی جهات باريکه های پراشیده ندارد. بد طور کلی، شدت باريکه پراشیده با هر تغییری در موقعیت های اتم ها، تغییر می کند. هدف اصلی، برقراری رابطه دقیق میان موقعیت های اتمی و شدت های پراشیده است. این امر به دلیل وجود متغیرهای گوناگون پیچیده است و ناچارا در این

مورد، گام به گام اقدام می کنیم. نخست چگونگی پراکندگی پرتوهای X را با یک الکترون، سپس با یک اتم، و در آخر، به وسیله تمام اتم های موجود در یک سلول واحد، بررسی خواهیم کرد.

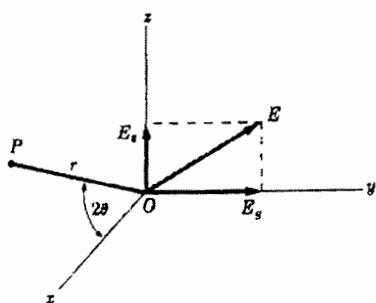
۱-۶ پراکندگی به وسیله یک الکترون

به گونه ای که در اول فصل بررسی شد باریکه پرتو X ، موجی الکترومغناطیسی با میدان الکتریکی است، که به طور سینوسی با زمان در هر نقطه از باریکه تغییر می کند. از آنجا که یک میدان الکتریکی نیرویی بر ذره ای باردار، مانند یک الکترون وارد می کند، نوسان میدان الکتریکی باریکه پرتو X که به هر الکترون وارد شود آن را به حرکت نوسانی پیرامون وضعیت تعادلی آن الکترون و می دارد. یک الکترون شتابدار موج الکترومغناطیسی گسیل می کند. الکترونی که به وسیله پرتو X به نوسان درآمده است، به طور پیوسته در طول حرکت خود شتاب می یابد و کند می شود، به این ترتیب موجی الکترومغناطیسی را گسیل می کند. از این رو، گفته می شود الکترون پرتوهای X را پراکنده می سازد. باریکه پراکنده، باریکه ای است که به آسانی به وسیله الکترون متأثر از باریکه فرودی ایجاد می شود. این باریکه پراکنده، همان طول موج و فرکانس باریکه فرودی را دارد و گفته می شود با باریکه فرودی همدوس است، زیرا رابطه ای معین میان فاز باریکه پراکنده و فاز باریکه فرودی وجود دارد که آن را تولید می کند. از آنجا که این تغییر فاز دقیقا برای تمام الکترون های موجود در یک بلور یکسان است، بنابراین تأثیری بر استنتاج معادله برآگ ارائه شده در بخش قبل ندارد. اگر چه پرتوهای X به وسیله یک الکترون در تمام جهات پراکنده می شوند، ولی همان طور که برای نخستین بار از سوی ج.ج. تامسون^۱ استخراج شد، شدت باریکه پراکنده به زاویه پراکندگی بستگی دارد. تامسون دریافت کد شدت، I ، باریکه پراکنده شده از یک الکترون مجزا با بار e و جرم m در فاصله r از الکترون، از رابطه زیر تعیین می شود:

$$I = I_0 \left(\frac{\mu_0}{4\pi} \right)^2 \left(\frac{e^4}{m^2 r^2} \right) \sin^2 \alpha = I_0 \frac{K}{r^2} \sin^2 \alpha \quad (10-1)$$

^۱ - J. J. Thomson

که در آن I_0 شدت باریکه فرودی، $\mu_0 = 4\pi \times 10^7 \text{ mkgC}^{-2}$ و K ثابت و α زاویه میان جهت پراکندگی و جهت شتاب الکترون است. فرض کنید که مسیر باریکه فرودی در جهت Ox (شکل ۱-۱۰) باشد و به الکترونی در O برخورد کند. می خواهیم شدت پراکندگی در نقطه P در صفحه xz را تعیین کنیم که در این صفحه، OP زاویه پراکندگی 2θ نسبت به باریکه فرودی می سازد.



شکل ۱-۱۰: پراکندگی همدوس پرتوهای X از تک الکترون

باریکه غیر پلاریزه‌ی فرودی، همانند باریکه‌ای که از یک لامپ پرتو X منتشر می‌شود، بردار الکتریکی E ‌ای دارد که در جیمه اتفاقی در صفحه yz واقع می‌شود. این باریکه می‌تواند به دو مؤلفه قطبی-صفحه‌ای با بردارهای الکتریکی E_z و E_y تفکیک شود که:

$$E^2 = E_y^2 + E_z^2 \quad (11-1)$$

چون جهت E کاملاً اتفاقی است، بنابراین:

$$E_y^2 = E_z^2 = \frac{1}{2} E^2 \quad (12-1)$$

شدت این دو مؤلفه باریکه فرودی با مجدور بردارهای الکتریکی آنها متناسب است، زیرا E اندازه دامنه موج را تعیین می‌کند و شدت یک موج با مجدور دامنه آن متناسب است. بنابراین

$$I_{oy} = I_{oz} = \frac{1}{2} I_o \quad (13-1)$$

مولفه‌ی باریکه فرودی، الکترون را در جهت $(1, 0, 0)$ شتاب می‌دهد. در نتیجه این مولفه، باریکه پراکنده ای را تولید خواهد کرد که شدت آن در $/r$ از معادله $(11-10)$ تعیین می‌شود:

$$I_{Py} = I_{oy} \frac{K}{r^2} \quad (14-1)$$

زیرا $\alpha = \angle yOP = \frac{\pi}{2}$ است. همچنین مولفه Z شدت از رابطه زیر تعیین می شود :

$$I_{Pz} = I_{oz} \frac{K}{r^2} \cos^2 2\theta \quad (15-1)$$

زیرا $\alpha = \frac{\pi}{2} - 2\theta$ است. کل شدت پراکنده شده در P از جمع شدت های این دو مؤلفه پراکنده به

دست می آید :

$$I_P = I_{Py} + I_{Pz} = \frac{K}{r^2} (I_{oy} + I_{oz} \cos^2 2\theta) \quad (16-1)$$

$$= \frac{K}{r^2} \left(\frac{I_o}{2} + \frac{I_o}{2} \cos^2 2\theta \right) = I_o \frac{K}{r^2} \left(\frac{1 + \cos^2 2\theta}{2} \right)$$

این معادله تامسون برای پراکندگی باریکه پرتو X از یک الکترون مجزا است. شدت باریکه پراکنده

شده، فقط بخش اندکی از شدت باریکه فرودی است، مقدار K برابر با 7.94×10^{-30} متر مربع است.

معادله بالا همچنین نشان می دهد که شدت پراکنده شده با عکس مجذور فاصله از الکترون پراکنده پرتو X کاهش می یابد. (همانگونه که انتظار می رود) و همچنین باریکه پراکنده شده در جهت جلو و عقب قوی تر از جهت عمود بر باریکه فرودی است.

معادله تامسون شدت مطلق (بر حسب ارگ بر مجذور سانتیمتر بر ثانیه) باریکه پراکنده شده را بر حسب شدت مطلق باریکه فرودی ارائه می دهد. اندازه گیری و محاسبه این دو شدت مطلق دشوار است، اما خوبیختانه برای هدف های مورد نظر ما در تمام مسائل پراشی، عملا مقادیر نسبی این شدت ها کافی است. در بیشتر موارد تمام فاکتورهای معادله (16-1) بد جز آخرین فاکتور، در طول

ازمایش ثابت بوده و می توانند حذف شوند. این آخرین فاکتور، $(1 + \cos^2 \frac{1}{2})$ ، فاکتور

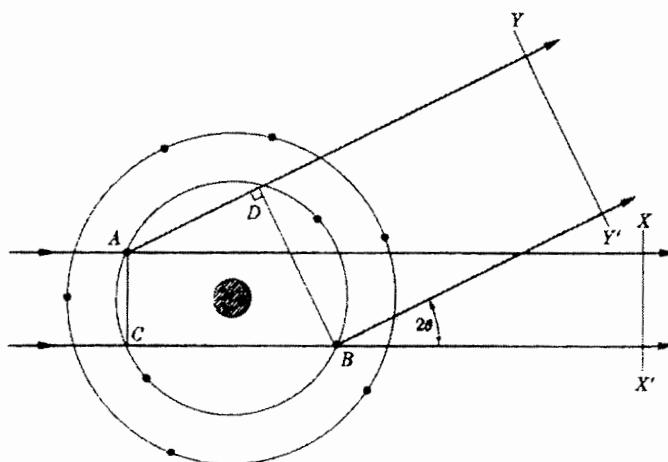
بلابری اسیون خوانده می شود.

براساس نظریه کوانتم، پراکندگی همدوس هنگامی رخ می دهد که فوتون فرودی بر اثر برخورد با الکترون به خارج پرتاپ شده و نیروی پیوندی این الکترون به اندازه ای محکم است که در اثر این برخورد، در اندازه حرکت آن هیچ گونه تغییری ایجاد نمی شود. بنابراین، فوتون پراکنده شده دارای همان انرژی و طول موجی است که پیش از برخورد داشته است.

۱-۷ پراکندگی به وسیله یک اتم

هنگامی که باریکه پرتو X به اتمی برخورد می کند، هر الکترون در اتم، بخشی از تابش را به طور همدوس بر اساس معادله تامسون پراکنده می کند. شخص ممکن است انتظار داشته باشد که هسته اتم نیز در پراکندگی همدوس شرکت داشته باشد، زیرا حامل بار است و متأثر از باریکه فرودی باید توانایی نوسان داشته باشد. به هر حال، هسته جرم بسیار زیادی نسبت به جرم الکترون دارد و نمی تواند تا گستره شایان توجهی به نوسان در آید. در واقع معادله تامسون نشان می دهد که شدت پراکندگی همدوس به $\frac{Z}{Z+1}$ می خکس با مجدور جرم ذره پراکننده متناسب است. نتیجه نهایی این است که پراکندگی همدوس از یک اتم فقط به الکترون های موجود در آن اتم مربوط است. سپس این پرسش پیش می آید: آیا موج پراکنده شده از یک اتم به آسانی مجموع امواج پراکنده شده از اجزای الکترونی آن اتم است؟ به بیانی دقیق تر، آیا اتمی با عدد اتمی Z موجی پراکنده می کند که دامنه آن Z برابر دامنه موج پراکنده شده از یک الکtron مجزا است؟ اگر پراکندگی در جهت جلو باشد ($=\theta = 0^\circ$) پاسخ مثبت است زیرا امواج پراکنده شده از تمام الکترون های اتم به این ترتیب هم‌فاز هستند و دامنه های تمام امواج پراکنده شده می توانند مستقیماً به یکدیگر افزوده شوند. این امر برای دیگر جهات پراکندگی صادق نیست. واقعیت این است که الکترون های یک اتم در نقاط کوناگونی در فضای قرار گرفته اند که تفاوت های فازی میان امواج پراکنده شده از الکترون های کوناگون را ایجاد می کنند. شکل ۱-۱۱ را در نظر بگیرید که در این شکل الکترون ها برای سادگی به صورت نقاطی نشان داده می شوند که پیرامون هسته مرکزی قرار گرفته اند. امواج پراکنده شده در جهت جلو به وسیله الکترون های 1 و 2 بر روی جبهه موجی مانند ψ دقيقاً هم فاز هستند. زیرا

هر موج فاصله یکسانی را پیش و پس از پراکندگی پیموده است. به هر حال، امواج پراکنده دیگر نشان داده شده در شکل، اختلاف مسیری برابر با $(CB-AD)$ دارند و از این رو در امتداد جبهه موجی مانند W تقریباً ناهمفاز هستند و اختلاف مسیری کمتر از یک طول موج دارند و تداخل جزئی میان امواج پراکنده شده از A و B رخ می‌دهد، در نتیجه کل دامنه موج پراکنده در این جهت کمتر از دامنه موج پراکنده شده از همان الکترون‌ها در جهت جلو است.



شکل ۱-۱۱: پراکندگی پرتو X از یک اتم

برای توضیح پراکندگی از یک اتم در یک جهت مشخص کمیت f (فاکتور پراکندگی اتمی) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این کمیت به صورت نسبت دامنه‌های زیر تعریف می‌شود:

دامنه موج پراکنده از یک اتم

$$f = \frac{\text{دامنه موج پراکنده از یک الکtron}}{\text{دامنه موج پراکنده از یک اتم}}$$

بر اساس آنچه تا کنون بیان شده است، برای هر پراکندگی اتمی در جهت جلو Z است. ولی با افزایش // امواج پراکنده شده از الکترون‌های مجزا بیشتر ناهمفاز شده و // کاهش می‌یابد. فاکتور پراکندگی اتمی به طول موج باریکه فرودی نیز وابسته است و در مقدار ثابت // با کوتاهتر شدن طول موج فاکتور پراکندگی اتمی // کمتر خواهد شد. زیرا اختلاف مسیرهای پیموده شده در رابطه با

طول موج بیشتر شده که این به تداخل بیشتر میان باریکه های پراکندگی منجر می شود. گاهی فاکتور پراکندگی گررا فاکتور ریخت نیز می گویند، زیرا این فاکتور به چگونگی پخش الکترون ها در پیرامون هسته وابسته است.

به طور خلاصه هنگامی که باریکه تکفام پرتو X به اتمی برخورد می کند، دو پدیده پراکندگی روی می دهد. الکترون های مقید، محکم به نوسان درآمده و پرتوهای X با همان طول موج باریکه فرویدی منتشرمی کنند. الکترون های پیوندی که از استحکام کمتری برخوردار هستند، بخشی از باریکه فرویدی را پراکنده کرده و در این فرایند طول موج آن را به میزان اندکی افزایش می دهند. مقدار دقیق این افزایش به زاویه پراکندگی بستگی دارد. پراکندگی نخست را پراکندگی کشسان می گویند و پراکندگی دوم را ناکشسان می گویند. هر دو نوع پراکندگی به طور همزمان و در تمام جهات رخ می دهند. اگر اتم جزئی از گروه بزرگی از اتم هایی باشد که در فضا به گونه ای منظم و تناوبی همانند اتم های منظم تناوبی موجود در بلور قرار گرفته باشد، به این ترتیب پدیده دیگری روی می دهد. تابش همدوس پراکنده شده از تمام اتم ها در جهت های معینی تقویت شده و در جهت های دیگر حذف شود و بنابراین، باریکه های پراشیده تولید می شوند. پراش در اصل پراکندگی همدوس تقویت شده است.

۱-۸ پراکندگی از سلول واحد

اکنون برای یافتن رابطه ای برای شدت باریکه پراشیده، باید به پراکندگی همدوس نه از یک اتم محزا، بلکه از تمام اتم هایی که بلور را می سازند توجه کنیم. این واقعیت که اتم ها در فضا به صورت تناوبی قرار می گیرند به معنی این است که تابش پراکنده شدیداً به جهت های معین و بیزه ای محدود می شود که اکنون به صورت مجموعه ای از باریکه های پراشیده بدان اشاره می شود. جهت های این باریکه ها از قانون برآگ تعیین می شود.

با این فرض که قانون برآگ صادق است می خواهیم شدت باریکه پراشیده از بلور را به عنوان تابعی از موضع اتمی تعیین کنیم. از انجا که بلور فقط تکرار سلول واحد بنیادی بوده، کافی است

چگونگی آرایش اتم های درون یک سلول واحد که شدت باریکه پراشیده پراشی را متأثر می سازد، مورد بررسی قرار دهیم. از نظر کیفی این اثر همانند پراکنده ای از یک اتم است که دربخش پیش مورد بحث قرار گرفت. در آن بخش دریافتیم که اختلاف های فازی در امواج پراکنده شده به وسیله الکترون ها مجزا برای هرجهت پراکنده ای بجز جهت کاملا مستقیم رخ می دهد. همچنین امواج پراکنده شده از اتم های مجزای یک سلول واحد بجز جهت جلویی لزوما همفاز نیستند و اکنون باید چگونگی رابطه میان اختلاف فاز و شیوه آرایش اتم ها را تعیین کنیم.

ساده ترین راه بررسی این موضوع تعیین اختلاف های فاز میان امواج پراکنده شده از اتمی در مبدأ و اتم دیگری است که موقعیت آن فقط در جهت X متغیر است. برای درک بهتر مطلب سلول واحد ارتوگونال را در نظر بگیرید که مقطعی از آن در شکل ۱۲-۱ نمایش داده است. اتم A در مبدأ در نظر گرفته و پراش حاصل از صفحات (۰/۰۰) را در نظر می گیریم که در این شکل به صورت خطوط پر رنگ نشان داده شده است. این بدان معنی است که قانون برآگ برای این بازتاب صادق است و $\delta_{2'1'} = MCN = 2d_{h00} \sin \theta = \lambda$ (۱۷-۱)

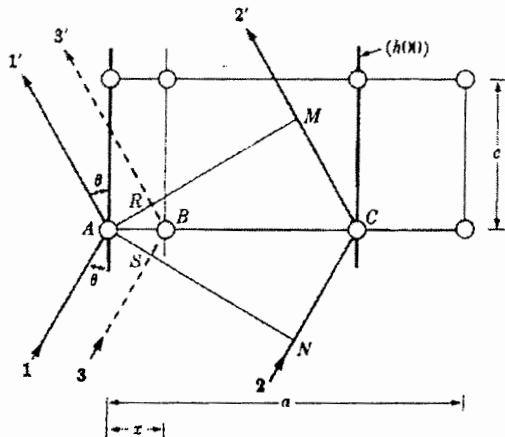
از تعریف اندیس های میلر داریم :

$$d_{h00} = AC = \frac{a}{h} \quad (18-1)$$

چگونه این بازتاب از پرتوهای $2'$ پراکنده شده در همان جهت به وسیله اتم B (که در فاصله X از A واقع است) متأثر می شود؟ توجه داشته باشید که فقط این جهت به بررسی نیاز دارد، زیرا فقط در این جهت قانون برآگ برای بازتاب (۰/۰,۰,۰) صادق است. روشن است که اختلاف فاز میان پرتو $2'$ و $1'$ (نمایش)، کمتر از λ خواهد بود و بد وسیله نسبت ساده زیر تعیین می شود:

$$\delta_{3'1'} = RBS = \frac{AB}{AC}(\lambda) = \frac{x}{\frac{a}{h}}(\lambda) \quad (19-1)$$

اختلاف های فازی می توانند بر حسب اندازه زاویه و نیز بر حسب طول موج بیان شود. دو پرتو که اختلاف مسیر انها یک موج کامل باشد، اختلاف فاز اینها 360° و یا 2π رادیان است. اگر اختلاف



شکل ۱-۱۲: اثر موقعیت اتم بر روی اختلاف فاز بین پرتوهای پراشیده

مسیر ۳ باشد، آنگاه اختلاف فاز ϕ بر حسب رادیان از رابطه زیر به دست می‌آید:

$$\phi = \frac{\delta}{\lambda} (2\pi) \quad (20-1)$$

بکارگیری اندازه گیری زاویه مناسب است، زیرا رابطه اختلاف‌های فازی را مستقل از طول موج می‌سازد، بنابراین اختلاف فاز میان سوچ پراکنده شده به وسیله اتم B و موج پراکنده شده از A در مبدأ، از رابطه زیر تعیین می‌شود:

$$\phi_{3'l'} = \frac{\delta_{3'l'}}{\lambda} (2\pi) = \frac{2\pi dhx}{a} \quad (21-1)$$

اگر موقعیت اتم B از مختصات کسری آن $\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a}$ مشخص شود، به این ترتیب اختلاف فاز عبارت است از:

$$\phi_{3'l'} = 2\pi/m \quad (22-1)$$

این استدلال می‌تواند در مورد سد بعد گسترش یابد، در شکل (۱۳-۱) اتم B دارای مختصات

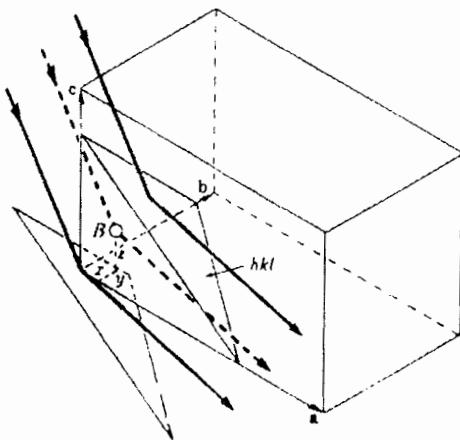
کسری $(\frac{x}{a}, \frac{y}{a}, \frac{z}{a})$ بوده که به ترتیب برابر با m/m است. لذا رابطه مهم زیر به دست می‌آید که

برای اختلاف فاز میان موج پراکنده از اتم B و موج پراکنده از اتم A در مبدأ برای بازتاب $/k/k$ است:

$$\phi = 2\pi(hu + kv + lw) \quad (23-1)$$

این رابطه عمومی است و در مورد هر شکلی از سلول واحد بکار می‌رود.

این دو موج نه تنها در فاز می‌توانند تفاوت داشته باشند، بلکه اگر اتم B و اتم مبدا گوناگون باشند در دامنه نیز تفاوت دارند. در این حالت دامنه‌های این امواج (نسبت به دامنه موج پراکنده شده، به وسیله یک تک الکترون) از مقادیر مناسب (فاکتور پراکنده‌گی اتمی) معین می‌شود. اکنون آشکار است که موضوع پراکنده‌گی از یک سلول واحد به صورت مجموعه‌ای از امواج با فاز و دامنه متفاوت برای یافتن برایند موج در می‌آید. امواج پراکنده به وسیله تمام اتم‌ها بویژه اتم مبدا باید به یکدیگر افزوده شوند. مناسب‌ترین راه انجام آن به وسیله ارائه هرموج به صورت تابع نمایی مختلط است.

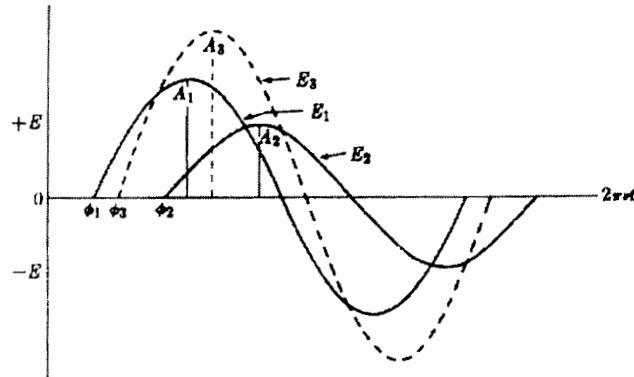


شکل ۱-۱۳: همانند شکل ۱-۱۱ در سه بعد

در شکل ۱-۱۴ دو موج بصورت خطوط ممتد نشان داده شده‌اند. این امواج تغییرات شدت میدان الکتریکی E را با زمان t برای دو پرتوی نشان می‌دهد که بر روی جبهه موج معینی در باریکه پراشیده پرتو A قرار می‌گیرند. معادله اینها را می‌توان به صورت زیر نوشت:

$$E_1 = A_1 \sin(2\pi\omega t - \phi_1) \quad E_2 = A_2 \sin(2\pi\omega t - \phi_2) \quad (24-1)$$

این امواج بسامد ν یکسانی داشته و از این رو طول موج λ یکسانی نیزدارند، اما از نظر دامنه A و فاز ϕ متفاوت هستند. منحنی نقطه چین مجموع E آنها را نشان می دهد که این منحنی نیز موجی سینوسی است، اما دامنه و فاز متفاوتی دارد.



شکل ۱-۱۴: جمع امواج سینوسی با فاز و دامنه متفاوت

امواجی که از نظر دامنه و فاز متفاوت هستند نیز می توانند با ارائه نمایش آنها به صورت بردارهایی با یکدیگر جمع سوند. در شکل (۱-۱۵) هر مولفه موج با برداری نمایش داده می شود که طول آن با دامنه موج برابر بوده و زاویه آن نسبت به محور X برابر با زاویه فاز است. سپس دامنه و فاز موج به دست آمده از جمع بردارها با استفاده از قانون متوازی الاضلاع به آسانی معین می شود از آنجا که شدت یک موج متناسب با مجدد دامنه آن است، اکنون به رابطه ای برای A^2 (مجذور مقدار مطلق بردار موج) نیاز داریم. در صورت بیان یک موج به گونه مختلط این کمیت از ضرب رابطه مختلط موج در مزدوج مختلط آن نتیجه شده که به آسانی از جایگزینی i با $-i$ به دست می آید.

بنابراین مزدوج مختلط $Ae^{i\phi}$ است، داریم:

$$\left| Ae^{i\phi} \right|^2 = Ae^{i\phi} \cdot Ae^{-i\phi} = A^2 \quad (25-1)$$

که کمیت مورد نظر است و یا با بکارگیری گونه ای دیگر از معادله (۱-۲۵) داریم:

$$A(\cos \phi + i \sin \phi) \cdot A(\cos \phi - i \sin \phi) = A^2 (\cos^2 \phi + \sin^2 \phi) = A^2 \quad (26-1)$$

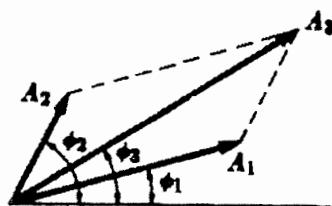
اکنون به موضوع جمع امواج پراکنده از هر یک از اتم های موجود در سلول واحد باز می گردیم.

دامنه هر موج از مقدار مناسب برای اتم پراکننده مورد نظر، و مقدار $\frac{\sin \phi}{\lambda}$ در بازتاب، تعیین

می شود. فاز هر موج از معادله (۲۳-۱) بر حسب بازتاب مورد نظر hkl و مختصات uvw اتم، داده

می شود. با استفاده از روابط پیش به این ترتیب می توان هر موج پراکنده شده را در شکل مختلط

نمایی بیان کرد.



شکل ۱-۱۵: جمع برداری امواج

$$Ae^{i\phi} = f e^{2\pi i(hu+kv+lw)} \quad (27-1)$$

به عبارت فوق که پراکندگی از تمام اتم های سلول واحد می باشد، فاکتور ساختاری می گویند.

زیرا این عامل چگونگی تأثیر آرایش اتمی (که با uvw برای هر اتم مشخص می شود) بر باریکه پراکنده شده را توضیح می دهد. فاکتور ساختاری که با علامت F مشخص می شود، از جمع ساده تمام امواج پراکنده از تک تک اتم ها با یکدیگر به دست می آید. اگر سلول واحدی دارای اتم های ۱، ۲، ۳، ... و N با مختصات کسری h_{ij}, k_{ij}, l_{ij} ، h_{ij}, k_{ij}, l_{ij} ، ... و فاکتورهای پراکندگی اتمی f_i ، f_j ، ... باشد، بنابراین فاکتور ساختاری برای بازتاب hkl از رابطه زیر تعیین می شود:

$$F = f_1 e^{2\pi i(h_{11} + k_{11} + l_{11})} + f_2 e^{2\pi i(h_{21} + k_{21} + l_{21})} + f_3 e^{2\pi i(h_{31} + k_{31} + l_{31})} + \dots \quad (28-1)$$

این معادله می تواند به صورت زیر خلاصه شود:

$$F_{hkl} = \sum_{n=1}^N f_n e^{2\pi i(h_{nn} + k_{nn} + l_{nn})} \quad (29-1)$$

که این مجموعه برای تمام N اتم سلول واحد بکار برده می شود.

به طور کلی F عددی مختلط است و بیانگر دامنه و فاز موج پراکنده شده از دسته صفحات (h,k,l) است. قدر مطلق $|F|$ دامنه موج بدست آمده را بر حسب دامنه موج پراکنده شده از یک تک الکترون ارائه می دهد. همانند فاکتور پراکنده اتمی r ، $|F|$ به صورت نسبت دامنه های زیر تعریف می شود:

دامنه موج پراکنده شده از تمام اتمهای یک سلول

$$|F| = \frac{\text{دامنه موج پراکنده شده از یک الکترون}}{\text{دامنه موج پراکنده شده از تمام اتمهای یک سلول}}$$

معادله (۱-۲۹) رابطه ای بسیار با اهمیت در بلور شناسی پرتو X است، زیرا این معادله محاسبه شدت هر بازتاب $hk\bar{l}$ را بر اساس آگاهی از موقعیت های اتمی امکان پذیر می سازد.

مراجع

- [1] “*Elements of X-ray diffraction*”, B.D.Cullity, London, Addison- Wesley publication Company, INC, (1978)
- [2] “*X-ray Diffraction*”, B.E.Warren, Dover Publication, INC, New York (1990)
- [3] “*Third-Generation Hard X-ray Synchrotron Radiation Sources*”, Dennis M.Mills, (2003)

فصل دوم

پراکندگی پرتو X ، تشدید یافته و تشدید نیافته

۱-۲ مقدمه

۲-۲ پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته

۳-۲ پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته

مراجع

۱-۲ مقدمه :

تأثیر مغناطیس بر روی پراکندگی نور از زمان کشف اثر فارادی^۱ و اثر کر^۲ در قرن ۱۹ شناخته شده است. بعدها ماکسول با بدست آوردن چهار معادله خود که به معادلات ماکسول معروف هستند نشان داد که چگونه بارها و جریان های الکتریکی، میدانهای الکتریکی و مغناطیسی تولید می کنند. این روابط همچنین وجود امواج الکترو مغناطیس و حرکت آنها در خلا با سرعت نور را توضیح می دهند. نظریه کلاسیکی پراش پرتوهای الکترو مغناطیسی نیز بر اساس معادلات ماکسول پایه ریزی شده است. در تصویر کلاسیکی حل معادلات ماکسول در محیط قطبیش پذیر طول موج امواج الکترو مغناطیسی بسیار بزرگتر از ابعاد اتمی و میدانها و چگالی بار بطور معمول بر روی حجم هایی بزرگتر از حجم اتمی هستند. بر اساس این تئوری کلاسیکی، پاسخ ماده به امواج الکترو مغناطیس به نوعی به ثابت دی الکتریک بستگی دارد. بستگی فرکانسی ثابت دی الکتریک، قطبیش بار حاصل از تاثیر یک میدان الکتریکی با فرکانس مشخص را تعیین می کند. در یک بلور، ثابت دی الکتریک یک تانسور است که تقارن آن به تقارن بلور بستگی دارد. یک میدان مغناطیسی خارجی می تواند تقارن بلور را تغییر دهد و این تغییر به صورت تغییر در ثابت دی الکتریک ظاهر می شود. اثرات مغناطیو اپتیکی وقتی دیده می شوند که بستگی ثابت دی الکتریک به میدان مغناطیسی شدید باشد. خواص مغناطیو اپتیکی شامل چرخش قطبیش نور در بازتاب (اثر کر)، چرخش قطبیش در انتقال (اثر فارادی) و یا میزان جذب که بستگی به قطبیش نور دارد.

^۱ - Faraday effect
^۲ - Kerr effect

اگر چه اثرات مغناطیو اپتیکی بخوبی شناخته شده اند ولی مشاهده آنها در منطقه پرتو X دشوار است زیرا ثابت دی الکتریک برای پرتوهای X نزدیک به واحد است و فقط نزدیک به لبه جذب می توان اثر مغناطیو اپتیکی را در ناحیه پرتو X مشاهده کرد. بررسی مطلوب رفتار پراش مغناطیسی پرتو X نیازمند استفاده از تئوری کوانتومی است.

در یک اتم، مغناطیس از اندازه حرکت زاویه ای ناشی از اسپین الکترون و اندازه حرکت اوربیتالی نشات می گیرد. بنابراین برای اوربیتال های کاملا پر، جمع برداری اسپین الکترون و اندازه حرکت اوربیتالی صفر است. لذا خاصیت مغناطیسی فقط می تواند از الکترون هایی که در اوربیتال های نیمه پر قرار دارند ناشی شود و اوربیتال های پر خاصیت مغناطیسی از خود نشان نمی دهند. در معادله غیر نسبیتی شرودینگر، اسپین با نوشتن تابع موج دو مولفه ای برای هر یک از مقادیر ممکن اسپینی $S=1/2$ یا $S=-1/2$ به نمایش در می آید. عملگرهای تاثیر گذار بر روی اندازه حرکت اسپینی و اوربیتالی با عملگرهای چرخش تابع موج در ارتباط هستند، که عملگر اوربیتالی فقط در مورد مختصات فضایی تابع موج بکار می رود و عملگر اسپینی فقط برای مختصات اسپینی کاربرد دارد. راجع به روابط حاکم در بر هم کنش پرنو --- الکترون در قسمت های بعد به تفصیل صحبت خواهیم کرد.

برای ایجاد پراکندگی مغناطیسی با پرتوهای X مکانیسم های متعددی وجود دارند. وقتی که از واژه "پراکندگی مغناطیسی" استفاده می کنیم منظور ما این است که: پراکندگی ای که به طریقی به جهت اسپین الکترون یا اندازه حرکت اوربیتالی در ماده پراکننده، بستگی داشته باشد. در مغناطیو اپتیک کلاسیکی وابستگی پراکندگی مغناطیسی به قطبش بسیار مهم است. در بسیاری از موارد پراش غیر مغناطیسی تامسون (بار الکتریکی) بر پراش مغناطیسی پرتو λ غالب و لذا پراکندگی ضعیف مغناطیسی در حضور پراکندگی تامسون قابل اندازه گیری نیست. نسبت این دو در حدود 10^0 می باشد. پراکندگی مغناطیسی اشعد λ . از ماده اطلاعات مهمی راجع به گشتاور اسپینی و اوربیتالی در واحد حجم، در حوالی مکان اتمی، و نیز راجع بد تقارن مغناطیسی بلورها بدست می دهد.

۲-۲ پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته^۱

در سال های اخیر شاهد رشد سریع استفاده از تکنیک های پراکندگی اشعه X برای مطالعه مواد مغناطیسی هستیم. این رشد سریع به علت خواص منحصر بفرد تابش سینکروترونی می باشد که شامل شار فوتونی بالا، امکان تغییر انرژی فوتون فرودی و تعیین دقیق قطبیدگی پرتو فرودی است. این خصوصیات، بررسی دقیق تر خواص مغناطیسی مواد را فراهم ساخته است. قسمت عمده پراکندگی اشعه X در ماده بعلت پراکندگی ایجاد شده توسط بارهای الکترونی است. همچنین می توان نوع دیگری از پراکندگی که به علت اسپین الکترون ها اتفاق می افتد را مشاهده کرد که بسیار ضعیف تر است و به آن پراکندگی مغناطیسی اشعه X می گویند. در پراکندگی مغناطیسی باید به محاسبه بر هم کنش بین فوتون و اسپین الکترون پرداخت. خاصیت مغناطیسی از دو قسمت عمده سرچشمه می گیرد، جریانهای اسپینی و مداری الکترون. در اوربیتال های کاملا پر از آنجا که در هر اوربیتال دو الکترون جای می گیرد، اندازه حرکت اسپینی و اوربیتالی کل برابر با صفر است. بنابراین مغناطیس شدگی تنها می تواند از الکترون های درون اوربیتال هایی که پر نیستند ناشی شود در بحث پراکندگی، پراکندگی غالب، پراکندگی غیر مغناطیسی قوی تامسون (یا پراکندگی ناشی از بار الکتریکی) است. بازتاب های مغناطیسی در پراکندگی از نمونه هایی دیده می شود که نظم مغناطیسی بطور همزمان با نظم شیمیایی منطبق نمی شود، مانند آنتی فرو مغناطیس ها. وقوع نظم آنتی فرو مغناطیس، تقارن موجود در بلور را کاهش می دهد و این سبب بزرگ شدن سلول واحد و باعث ایجاد برخی بازتاب ها^۲ در پراکندگی پرتو X می گردد. در نمونه های فرو مغناطیس و فری مغناطیس که پراش مغناطیسی بر پراش تامسون منطبق شده است، چند روش برای جداسازی سهم هر نوع پراکندگی وجود دارد. یکی از بهترین روش ها برای تمایز بین پراکندگی مغناطیسی از پراکندگی تامسون، قطبیدگی فوتون های پرتوهای فرودی و چک کردن پرتوهای پراکنده شده است.

با بهره گیری از ویژگی قطبیدگی تابش سینکروترونی، پراکندگی مغناطیسی می تواند برای مطالعه

^۱-Non-Resonance Magnetic Scattering
^۲-Superlattice Reflection

ساختار مغناطیسی مواد مورد استفاده قرار گیرد. بر هم کنش پرتو X با ماده بستگی به جهت و اندازه گشتاورهای مغناطیسی و نیز به زاویه بین قطبیدگی پرتو و گشتاور مغناطیسی ماده دارد. بر هم کنش پرتهای X با مغناطیس می تواند به دو بخش تقسیم گردد که بستگی به انرژی فوتون فروودی دارد. هنگامی که انرژی فوتون بسیار بیشتر از لبه جذب عنصر مغناطیسی باشد، منجر به پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته پرتو X می گردد. اما اگر انرژی فوتون دقیقاً برابر با لبه جذب باشد پراکندگی تشدید یافته رخ می دهد. در این بخش بطور خلاصه پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته تشریح می شود و پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته در بخش بعد توضیح داده خواهد شد.

پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته به مطالب اثبات شده قبلی توسط ژل-منل^۱ و همکارانش بر می گردد [۱] که این نظریه با استفاده از فیزیک کلاسیک و مکانیک کوانتمی توسط پلاتزمن^۲ گسترش پیدا کرد [۲]. آنها نشان دادند که در سطح مقطع پراکندگی فوتون از الکترون یک بستگی اسپینی وجود دارد (بر خلاف نظریه کلاسیکی تامسون). بر هم کنش بین فوتون و الکترون می تواند با هامیلتونی پیشنهاد شده توسط بلعم^۳ بیان گردد [۳] :

$$H = \frac{e^2}{2mc^2} \sum_i A^2(r_i) - \frac{e}{mc} \sum_i P_i \cdot A(r_i) - \frac{e\hbar}{mc} \sum_i s_i \cdot \nabla \times A(r_i) - \frac{e^2 \hbar}{2mc^2} \sum_i s_i \cdot \left(\frac{\partial A(r_i)}{\partial t} \times A(r_i) \right) \quad (1-2)$$

که جمع بر روی i تمام الکترون های درون نمونه است. A ، پتانسیل برداری مربوط به میدان الکترو-مغناطیسی در مکان r مربوط به الکترون i است. جمله اول که متناسب با ω است، مستقل از اسپین و اوربیتال بوده و جمله ای است که باعث تشدید در پراش پرتو X نمی شود و موسوم به پراکندگی تامسون (و یا پراش از بار) می باشد. جمله دوم که نسبت به ω خطی است، به گشتاور الکترون بر می گردد و در پراکندگی از گشتاور اوربیتالی شرکت دارد. این جمله همچنین در فرآیند

^۱ - Gell-Mann

^۲ - Platzman

^۳ - Blume

های جذب، انتشار و نیز پراکندگی غیرعادی^۱ سهیم است. این جمله در مخرج شامل عبارت وابسته به انرژی است و هنگامی که انرژی فوتون نزدیک به یکی از انرژی های تحریک در نمونه شود، مخرج بسیار کوچک شده و باعث تشدید پراکندگی می‌گردد. سومین و چهارمین جمله در مورد جفت شدگی اسپین-فوتون می‌باشد. دو جمله اول که بیشترین سهم را در پراکندگی دارند در معادله غیر نسبیتی شرودینگر دیده می‌شوند. جملات بعدی از اینجا ناشی می‌شوند که در هامیلتونین کلاسیکی برای بدست آوردن مقدار درست پراکندگی در حضور یک میدان الکترومغناطیسی با پتانسیل برداری A باید

$$\text{به جای اندازه حرکت الکترون } P, \text{ عبارت } P - \frac{e}{c} A \text{ جایگزین شود.}$$

سطح مقطع پراکندگی پرتو X با درنظر گرفتن برهم کنش میدان الکترومغناطیسی فوتون با چگالی مغناطیس شدگی، شامل جملاتی علاوه بر پراکندگی عادی بار می‌باشد که وابسته به تبدیل های فوریه چگالی گشتاور زاویه ای اسپینی و اوربیتالی (مداری) یعنی به ترتیب $S(Q)$ و $L(Q)$ می‌باشد. بر هم کنش تشدید نیافته بین فوتون ها و چگالی گشتاور اسپینی و اوربیتالی، بخاطر بر هم کنش نسبیتی ظاهر می‌شود. با تعیین فاکتور $S(Q)$ و $L(Q)$ که به ترتیب تبدیل های فوریه چگالی گشتاور زاویه ای اسپینی و اوربیتالی می‌باشند [۴]، مقدار پراکندگی (به ازای هر اتم) هنگامی که انرژی فوتون بسیار دور از لبه جذب است می‌تواند بدین صورت نوشته شود [۵] :

$$f_n(Q) = f_n^{charge} + f_n^{nonres}(Q, \vec{k}, \vec{k}') + f_n^{res}(\vec{k}, \vec{k}', \hbar\omega) \quad (3-2)$$

که در آن عبارت اول پراکندگی از بار یا همان پراکندگی تامسون است که به صورت زیر نوشته می‌شود .

$$f_n^{charge}(Q) = \rho_n(Q) \vec{e} \cdot \vec{e}' \quad (3-2)$$

که \vec{e} و \vec{e}' بد ترتیب بردار قطبیدگی فوتون فرودی و پراکنده می‌باشند و (Q) تبدیل فوریه چگالی بار الکتریکی اتم^{۱۱} است. خوب نکنند ای بین بردارهای قطبیدگی نشان دهنده این امر است که حالت قطبیدگی پرتو^{۱۲} به واسطه پراکندگی از بار نخواهد چرخید .

^۱ Anomalous Scattering

جمله غیر تشدیدی پراکندگی مغناطیسی می تواند به این صورت نوشته شود [۵]:

$$f^{nonres}(\mathcal{Q}) = -i \frac{\hbar\omega}{mc^2} \langle M_{nonres} \rangle = -i \frac{\hbar\omega}{mc^2} \left[\frac{1}{2} L_n(\mathcal{Q}) \cdot A + S_n(\mathcal{Q}) \cdot B \right] \quad (4-2)$$

که در آن $\langle M_{nonres} \rangle$ وابستگی مغناطیسی و $L_n(\mathcal{Q})$ و $S_n(\mathcal{Q})$ مربوط به n امین اتم است. بردارهای A و B شامل بستگی به قطبیدگی این دو بخش سهیم در پراکندگی هستند. دانستن این نکته مهم است که این دو بردار یکسان نیستند و بستگی به \mathcal{Q} (بردار یکه پراکندگی) برای این دو متفاوت است. چون این بردارها بطور کلی متفاوت هستند گشتاور اسپینی μ و گشتاور اوربیتالی μ بطور متفاوت در f^{mag} سهیم هستند و می توان از طریق آزمایشات تجربی، سهم هر کدام را محاسبه کرد. بردارهای قطبیدگی A و B بصورت زیر هستند [۵]:

$$A = \frac{K^2}{2k} \begin{pmatrix} 0 & -(\hat{k}_i + \hat{k}_f) \\ \hat{k}_i + \hat{k}_f & 2\hat{k}_i \times \hat{k}_f \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} \hat{k}_i \times \hat{k}_f & \frac{K^2}{2k^2} \hat{k}_i \\ \frac{K^2}{2k^2} \hat{k}_i & \hat{k}_i + \hat{k}_f \end{pmatrix} \quad (5-2)$$

از این روابط چند نکته اهمیت است. نکته اول اینکه وابستگی قطبیدگی ماتریس های A و B نشان می دهد که عناصر قطعی، پراکندگی $\sigma - \sigma$ و $\pi - \pi$ را بدست می دهد و عناصر غیر قطعی پراکندگی $\pi - \sigma$ و $\sigma - \pi$ را تعیین می کند. با نگاهی به این دو ماتریس می توان فهمید که پراکندگی $\sigma - \sigma$ در پراکندگی اوربیتالی وجود ندارد ولی در پراکندگی از اسپین وجود دارد. نکته دوم اینکه همان طور که رابطه (4-2) نشان می دهد، در پراکندگی پرتو ۲، گشتاورهای اسپینی و اوربیتالی هر کدام سهم جدایانه ای در پراکندگی دارند. در صورتی که در پراکندگی نوترونی چنین چیزی دیده نمی شود و سهم آنها بطور مجزا مشخص نیست. بنابراین پراکندگی پرتو X روش بسیار خوبی برای جداسازی سهم پراکندگی اسپینی و اوربیتالی است. نکته سوم اینکه پراکندگی اوربیتالی شامل حاصلضرب برداری $\mathbf{t}^e \times \mathbf{n}$ می باشد (ماتریس A را بینید) که به ترتیب بردارهای یکه قطبیدگی فوتون فروندی و پراکنده شده هستند. لذا بر خلاف پراکندگی بار و اسپین، پراکندگی اوربیتالی در کanal غیر چرخنده صفر شده و

قابل صرف نظر است [۶]. لانگراید^۱ و همکارانش از پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته اشعه X برای جدا سازی سهم اندازه حرکت اسپینی و اوربیتالی در ترکیب آنتی فرومغناطیس UAs استفاده کردند [۷]

اولین بار بلوم و گیبس^۲ پیشنهاد انجام آزمایشات پرتو X با قطبیدگی مشخص را مطرح کردند. برای آزمایشاتی با پرتوفرودی با قطبیدگی خطی، مقادیر پراکندگی مناسب‌تر است که در عباراتی بر اساس قطبیدگی خطی حالت پایه بیان شوند. برای پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته $\langle M_{nonres} \rangle$ در رابطه ۴-۲ به صورت زیر نوشته می‌شود :

$$\langle M_{nonres} \rangle = \begin{pmatrix} \langle M_{\sigma\sigma} \rangle & \langle M_{\pi\sigma} \rangle \\ \langle M_{\sigma\pi} \rangle & \langle M_{\pi\pi} \rangle \end{pmatrix} \quad (4-2)$$

در سیستم مختصات شکل ۴-۹ و π به حالت‌های قطبیدگی خطی عمود و موازی با صفحه پراکندگی بر می‌گردد. برای قطبیدگی خطی فروندی، پراکندگی σ - σ با $\langle M_{\sigma\sigma} \rangle^2$ و پراکندگی π - π با $\langle M_{\pi\pi} \rangle^2$ داده می‌شود و بطور مشابه برای بقیه عناصر ماتریس ۶-۲

نکته دیگری که لازم به ذکر است اینکه در رابطه ۴-۲ یک پیش فاکتور $\frac{\hbar\omega}{mc^2}$ وجود دارد که برای انرژی پرتو X نوعی $\hbar\omega \approx 10 \text{ keV}$ تقریباً ۱/۵۰ بار کمتر از پراکندگی بار است. باید توجه داشت که شدت پیک مغناطیسی با مجدور این فاکتور متناسب است. علاوه بر این تنها الکترون‌های مدارهای پر نشده در شدت پیک سهیم هستند. بعنوان مثال نسبت سطح مقطع پراکندگی مغناطیسی به بار برای بازتاب (۱/۲، ۱/۲، ۱/۲) در NiO در حدود 10^{-8} اندازه گیری شده است [۸]. ضمناً ضریب موهومی α در رابطه ۴-۲ نشان می‌دهد که پراکندگی مغناطیسی ۹۰ درجه با پراکندگی ناشی از بار اختلاف فاز دارد. نسبت پراکندگی تشدید نیافته به پراکندگی ناشی از بار با این رابطه مشخص می‌شود [۵] :

$$\left| \frac{f^{nonres}}{f^{charge}} \right|^2 \propto \left(\frac{m\hbar}{mc^2} \right)^2 \cdot \left| \langle S \rangle \right|^2 \cdot \left(\frac{N_m}{N} \right)^2 \quad (4-3)$$

^۱ - Langridge
^۲ - Blume and Gibbs ۱۹۸۸

که $\langle S \rangle$ مقدار چشم داشتی اسپین یک الکترون و $\frac{N_m}{N}$ نسبت الکترون های مغناطیسی (منفرد) به کل الکترون ها است. برای پرتو X با انرژی KeV ۵-۱۰ حتی در مطلوب ترین موارد، این مقدار به ندرت بزرگتر از 10^{-6} خواهد شد.

۲-۳ پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته^۱

امروزه پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته پرتو X عنوان یک روش و ابزار، استفاده بسیار زیادی برای بررسی سیستم های مغناطیسی دارد. تشدید در افزایش شدت پرتو پراکنده شده نخستین بار حدود ۱۵ سال قبل بوسیله نامیکاوا^۲ و همکارانش در لبه جذب K فرو مغناطیس Ni مشاهده شد [۹]. در لبه L_{III} فلز هولمیوم^۳ یک تقویت شدت، توسط گیبس^۴ و همکارانش مشاهده شد [۱۰]. این اولین اندازه-گیری تشدید پراکندگی مغناطیسی از یک ماده آنتی فرو مغناطیس بود. بعدها تقویت شدت پراکندگی تشدید یافته در لبه L_{III} عنصر D در لبه M_{IV} اتم UAs در ترکیب UA_2 ، در لبه انرژی M در $NpAs$ مشاهده شد [۱۱]. این افزایش در شدت از انتقال های الکترونیکی، با حساسیت به مغناطیس شدگی، که از اثرات تبادل^۵ ناشی می شود، بوجود می آید. در لبه جذب L عناصر خاکی کمیاب این افزایش ممکن است مقداری بین 10^{-4} - 10^{-6} باشد اما در لبه K فلزات واسطه این فاکتور کمتر از ۲ است [۱۲].

اخیرا تلاش بسیار زیادی برای استفاده از پراکندگی اشعه X تشدید یافته برای مطالعه نظم بار، اسپین و اوربیتال صورت گرفته است. از جمله این موارد می توان به $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ [۱۳] $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ [۱۵] $Pr_{1-x}Ca_xMnO_3$ [۱۶] (با غلظت های $x=0.4$ و 0.25) و $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ [۱۴] $Nd_{1-x}Sr_xMnO_3$ [۱۸] اشاره کرد.

با تعییر دادن انرژی فوتون تا لبه جذب یک عنصر مغناطیسی در یک بلور، همیشه تعییرات چشم گیری در سطح مقطع پراکندگی ایجاد می شود، که معمولاً این تعییرات تحت عنوان پراکندگی غیر

^۱-Resonant Scattering
^۲-Namikawa
^۳-Holmium
^۴-Gibbs
^۵-Exchange effects

عادی^۱ نام گذاری می شود و با اضافه کردن دو عبارت حقیقی و موهومی به فاکتور پراکندگی نمایش داده می شود. بستگی دو عبارت مورد ذکر باعث می شود که فاکتور پراکندگی اتمی در حوالی لبه جذب به انرژی پرتو X وابسته بوده و بطور کلی بدین صورت بیان می شود [۵]:

$$f(\mathcal{Q}, \omega) = f_0(\mathcal{Q}) + f'(\omega) + i f''(\omega) + f_{spin} \quad (8-2)$$

در این رابطه f فاکتور پراکندگی تامسون و f' و f'' به ترتیب قسمت حقیقی و موهومی فاکتور پراکندگی غیر عادی هستند. f' و f'' به ترتیب نشان دهنده سهم فرآیند جذب و انتشار اشعه X هستند. قسمت موهومی f'' می تواند به صورت مستقیم از اندازه گیری های بعمل آمده از جذب پرتو X بدست آید و سپس f' می تواند با محاسبه از رابطه زیر موسوم به رابطه کرامرز کرونینگ^۲ با قرار دادن

f'' بدست می آید:

$$f'(\omega) = \frac{2}{\pi} \int_0^{\infty} \frac{f''(\omega)}{\omega^2 - \omega_0^2} d\omega \quad (9-2)$$

محاسبه تئوری f'' کار بسیار مشکلی است اما غیر ممکن نیست. همانطور که رابطه زیر نشان می دهد:

$$f''(\omega) = \frac{mcM}{4\pi N^2 e\rho} \mu(\omega) \quad (10-2)$$

f'' با ضریب جذب خطی رابطه مستقیم دارد. در این رابطه m جرم الکترون، c سرعت نور، e بار الکترون، N عدد آووگادرو و ρ چگالی بار الکتریکی اطراف عنصر مغناطیسی در ترکیب مورداً زمایش است. از آنجایی که محاسبه f'' کار بسیار دشواری است، فیزیکدانان بیشتر تمایل به اندازه گیری f' از طریق تجربی دارند تا محاسبه تئوری با استفاده از رابطه اخیر. ضمن اینکه همانطور که دیده می شود ضریب جذب خطی μ به انرژی پرتو λ نیز بستگی دارد و این خود به دشواری کار می افزاید.

سطح مقطع پراکندگی، از طریق f' و f'' در پراکندگی تشیدید یافت وارد می شود. در حقیقت پراکندگی تشیدید یافته سهم مشارکت جمله $A = 1.02$ در رابطه 1.02 است. هنگامی که انرژی پرتو λ فرودی

^۱- Anomalous dispersion
^۲- Kramers-Kroning

در حوالی لبه جذب عنصر مغناطیسی سازنده ترکیب باشد، این پارامترها در فاکتور پراکندگی اتمی (عنصر مغناطیسی) به شدت تغییر می کند که در نهایت منجر به تغییر فاکتور ساختار خواهد شد.

مکانیسم پراکندگی تشیدید یافته بدین صورت است: فوتون جذب شده، یک الکترون را به تراز انرژی بالاتر ارتقاء می دهد. این الکترون سپس به حالت قبلی خود برگشته و در عین حال یک فوتون با انرژی مشابه همان فوتون فرودی به صورت الاستیک پراکندگی شود. برای پراکندگی براگ، این فرآیند به صورت همدوس رخ می دهد. فرآیندی از این نوع یعنی انتشار توسط بعضی حالت های میانی، نیازمند به تفسیر بوسیله مرتبه دوم تئوری اختلال است و بنابراین عمل تشیدید ناشی از عبارت وابسته به انرژی در مخرج عبارت است.

با بهره گیری از مکانیک کوانتومی رابطه پراکندگی تشیدید یافته f^{res} در رابطه ۲-۲ را می توان به فرم زیر نوشت [۵]:

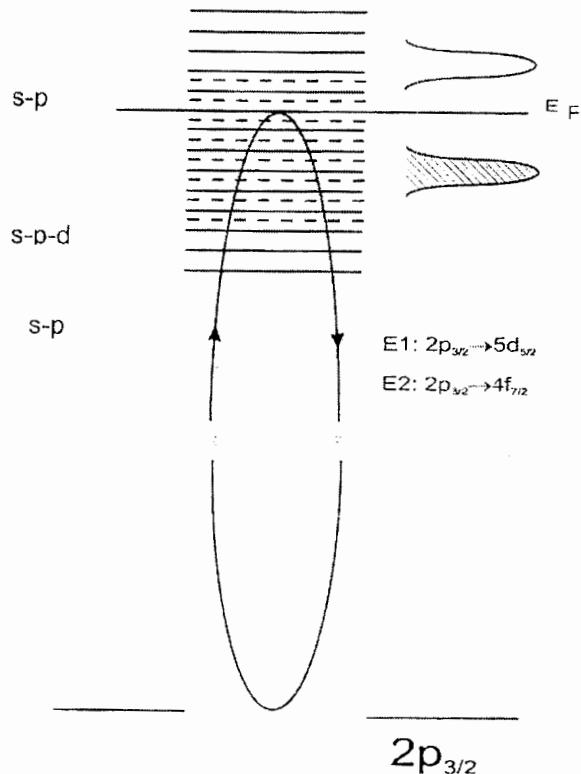
$$f^{res}(k, k', \hbar\omega) = -\frac{1}{m} \sum \frac{E_a - E_c}{\hbar\omega} \frac{\langle a | O_\lambda(k) | c \rangle \langle c | O_{\lambda'}^+(k') | a \rangle}{E_a - E_c - \hbar\omega} + \frac{1}{m} \sum \frac{E_a - E_c}{\hbar\omega} \frac{\langle a | O_{\lambda'}^+(k') | c \rangle \langle c | O_\lambda(k) | a \rangle}{E_a - E_c + \hbar\omega - i(\Gamma/2)} \quad (11-2)$$

که E_a و E_c اندیس انرژی ها و توابع موج حالت های ابتدایی و میانی سیستم هستند. Γ معکوس طول عمر حالت میانی، K و K' به ترتیب بردار موج های فوتون فرودی و پراکنده شده هستند و جرم آزاد الکترون است. عملگر $O_\lambda(k)$ بصورت زیر تعریف می شود:

$$O_\lambda(k) = \sum e^{ik \cdot \vec{r}_i} / (\vec{P}_i \cdot \vec{e}_\lambda - i\hbar \vec{e}_\lambda \cdot (\vec{k} \times \vec{S}_i)) \quad (12-2)$$

که اندیس i و λ نشان دهنده قطبیدگی فوتون فرودی و پراکنده شده، P_i و S_i اندازه حرکت و اسپین الکترون i است و اندیس i شامل تمام الکترون های واقع در اطراف اتم مورد نظر می شود. دو عبارت معادله (۱۲-۲) تمام بستگی پراکندگی به فوتون فرودی را در بر دارد. در آزمایشات پراکندگی تشیدید یافته وقتی که انرژی فوتون فرودی، $\hbar\omega$ در نزدیکی لبه جذب انتخاب می شود (یعنی $\hbar\omega = E_c - E_a$) مخرج رابطه مذکور بسیار کوچک شده و تشیدید رخ می دهد. بک دیاگرام ترازهای

انرژی و پراکندگی تشدید یافته در لبه جذب برای یک یون قلیایی خاکی را در شکل ۱-۲ مشاهده می کنید.



شکل ۱-۲: تصویر شماتیک فرایند پراکندگی تشدید یافته برای یک یون قلیایی خاکی در لبه جذب [۵]

پراکندگی پرتو X تشدید یافته به ویژگی های موضعی^۱ از قبیل ناهمسانگردی محیط اتمی یا ناهمسانگردی جهت گشتاورهای اتمی حساس است. افزایش در شدت پرتو X پراکنده شده هنگامی اتفاق می افتد که انرژی فوتون های فروودی در حوالی مقدار لازم برای خارج کردن الکترون از تراز داخلی (پایین تر) بد حالت های خالی تراز والانس باشد. محیط مکانی اتم بد شدت بر ترازهای والانس تاثیر می کذارد و بنابراین اندازه پراکندگی اتمی بد محیط اتم، گشتاور مغناطیسی اتمی و دیگر فاکتورهایی بستگی دارد که بر حالت های الکترونی تاثیر می کذارند. اگر تبهکنی الکترون ظرفیت از بین برود،

¹ - local

پذیرفتاری بلور در نزدیکی لبه جذب نا همسانگرد می شود. بنابراین ویژگی های نا همسانگردی تانسور پذیرفتاری^۱ منجر به انتشار بازتاب های مغناطیسی ممنوعه^۲ می شود. (عبارت "بازتاب های ممنوعه" به این دلیل است که این دسته از پراکندگی های پرتو X در انرژی هایی اتفاق می افتد که تئوری کلاسیک پرتو X آنها را پیش بینی نمی کند) تشدید شدت پراکندگی مغناطیسی از انتقال چند قطبی الکتریکی سرچشم می گیرد، که شامل برانگیخته شدن یک الکترون به یک تراز خالی نزدیک تراز فرمی است. تکنیک پراکندگی پرتو X تشدید یافته اطلاعاتی راجع به حالت اسپین مواد مغناطیسی به ما می دهد. تشدید قویتر وقتی اتفاق می افتد که پراکندگی شامل انتقال یک دوقطبی الکتریکی (حالت قویتر) یا چهار قطبی الکتریکی (حالت ضعیفتر) از یک تراز داخلی به یک تراز انرژی پر نشده و یا یک نوار باریک انرژی، می باشد. از این افزایش در شدت پراکندگی، برای آشکارسازی سیگنال های ضعیف استفاده می شود. پراکندگی در نزدیکی لبه جذب از جزئیات شیمیایی محیط تاثیر پذیر است. هم چنین می توان از آن برای تشخیص عناصر مغناطیسی متفاوت در یک سلول واحد و یا حالت های ظرفیت متفاوت برای یک نوع اتم، استفاده کرد. این عمل با تنظیم انرژی از یک لبه به لبه های جذب دیگر صورت می گیرد. تغییرات شیمیایی لبه جنبه تواند علت های متفاوتی داشته باشند از جمله تفاوت در پتانسیل الکترواستاتیکی هسته و ترازهای انرژی متفاوت. برای مثال در مطالعه نظم بار در منگنایت ها، از آنجا که لبه انرژی E_A مربوط به Mn^{4+} قطعاً متفاوت از لبه جذب E_A مربوط به Mn^{3+} است لذا یک نا بهنجاری در پیک شدت در نزدیکی E_A انتظار می رود که به همان پراکندگی غیر عادی نسبت داده می شود. بر خلاف پراکندگی مغناطیسی تشدید نیافته پرتو X که از جفت شدگی مغناطیسی سرچشم می گیرد، پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته می تواند، در حقیقت به علت انتقال چند قطبی الکتریکی بین یک تراز مغزی و یک تراز انرژی پر نشده و یا بین یک تراز مغزی و یک نوار انرژی (مربوط به ساختار نواری) باشد.

- Susceptibility Tensor
- Forbidden Magnetic Reflections

شدت پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته برای انتقال دو قطبی الکتریکی که معمولاً در سطح مقطع

مغناطیسی تشدید غالب است می‌تواند بدین صورت نوشته شود [۱۹]:

$$f_{res.}^{mag.}(E) = \beta \lambda / 8\pi \left\{ e'_f \cdot e_i [F_{//} + F_{/-}] - i(e'_f \times e_i) \cdot Z_j [F_{//} - F_{/-}] + (e'_f \cdot Z_j)(e_i \cdot Z_j) [2F_{/0} - F_{//} - F_{/-}] \right\} \quad (13-2)$$

که در این رابطه $E = \hbar\omega$ انرژی فوتون است و e_f و e_i بردارهای قطبیدگی ابتدایی و ثانویه پرتو X است که در روابط A و B مربوط به پراکندگی مغناطیسی تشدید یافته گنجانده شده است (رابطه ۵-۲). کمیت Z_j نشان دهنده جهت مغناطیس شدگی تعیین شده توسط گشتاور موضعی در مکان r است. ضریب F_{lm} دربردارنده عناصر ماتریسی است که حالت پایه را با ترازهای مغناطیسی تحریک یافته متناظر می‌سازد. قدرت تشدید بوسیله فاکتور F_{lm} تعیین می‌شود. اولین جمله مستقل از جهت کوانتش است و متناظر با پراکندگی عادی کلاسیکی می‌باشد و می‌تواند به عنوان تصحیح در پراکندگی ناشی از بار انگاشته شود. وابستگی قطبیدگی این عبارت بوسیله $e_i \cdot e'_f$ تعیین می‌شود و این عبارت فقط در پراکندگی $\sigma - \sigma$ و $\pi - \pi$ شرکت دارد. جمله دوم نسبت به Z خطی است و منجر به پراکندگی مغناطیسی می‌شود. وابستگی قطبیدگی این جمله بوسیله $e_i \times e'_f$ مشخص می‌شود. برای پرتو فرودی با قطبیدگی σ (که در سینکروترون چنین است) انتقال دوقطبی باعث چرخش قطبیدگی از σ به π می‌شود و این جمله نهایتاً به $Z \cdot K'$ ختم می‌شود. بنابراین اگر گشتاور مغناطیسی عمود بر صفحه پراکندگی باشد، هیچ تشدید پراکندگی مغناطیسی مشاهده نخواهد شد.

پراکندگی پرتو λ . تشدید یافته همچنین برای مطالعه نظم اوربیتالی استفاده می‌شود. پراکندگی پرتو λ . تشدید یافته نسبت به اشغال اوربیتال‌های الکترونی حساس است چرا که تقارن حالت‌های الکتریکی اشغال نشده را در حین انتقال جند قطبی‌های الکتریکی آشکار می‌سازد. تغییر در سطح مقطع پراکندگی اوربیتالی تشدید یافته با تغییر در جهت قطبی پرتو فرودی (زاویه سمتی φ) تقارن فضایی اوربیتال‌های نظم یافته را نمایان می‌سازد. متأسفانه چون در شرایط عادی الکترون‌های مغزی (الکترون‌های نزدیکتر به هسته) پراکندگی پرتو λ . را تحت کنترل خود دارند و لذا حساسیت پرتو به

توزیع الکترون های ظرفیت، معمولاً بسیار کم است. اما موراکامی^۱ و همکارانش اثبات کردند که این امکان را با استفاده از پرتو X با انرژی متناظر بر لبه K ای عنصر Mn در ترکیب $La_{1.5}Sr_{1.5}MnO_7$ می-توان فراهم ساخت [۱۲]. با تنظیم انرژی فوتون ها بر لبه جذب می توان حساسیت سطح مقطع پراکندگی اشعه X نسبت توزیع الکترون های ظرفیت را بطور فزاینده ای افزایش داد و امکان مشاهده مستقیم نظم اوربیتالی را فراهم نمود. در قسمت های بعد نشان خواهیم داد که نا همسانگردی فاکتور ساختار دلیل اصلی مشاهده بازتاب های ممنوعه و آشکار سازی نظم اوربیتالی است.

- Murakami

مراجع

- [١] M. Gell-Mann and M. L. Golberger, Physics Review ٦٦, ١٤٣٣ (١٩٥٤).
- [٢] P. M. Platzman and N. Tzoar, Physics Review B ٢, ٣٥٣٦ (١٩٧٠).
- [٣] M. Blume, Journal of Applied Physics ٥٧, ٣٦١٥ (١٩٨٥).
- [٤] M. Blume and D. Gibbs, Physical Review B ٣٧, ١٧٧٩ (١٩٨٨)
- [٥] “*Third-Generation Hard X-ray Synchrotron Radiation Sources*”. Dennis M. Mills (٢٠٠٧)
- [٦] S. W. Lovesey and S. P. Collins, X-ray Scattering and Absorption by magnetic Materials(Clarendon Press. Oxford, ١٩٩٦).
- [٧] S. Langridge, G. H. Lander, N. Bernhoeft, et al., Physical Review B ٥٥, ٦٣٩٢ (١٩٩٧).
- [٨] S. W. Lovesey and S. P. Collins, X-ray Scattering and Absorption by magnetic Materials(Clarendon Press. Oxford, ١٩٩٦).
- [٩] K. Namikawa, M. Ando, T. Nakajima, et al., Journal of the Physical Society of Japan ٥٤, ٤٠٩٩ (١٩٨٥).
- [١٠] D. Gibbs, D. R. Harshman, E. D. Isaacs, et al., Physical Review Letters ٦١, ١٢٤١ (١٩٨٨).
- [١١] D. B. McWhan, C. Vettier, E. D. Isaacs, et al., Physical Review B ٤٢, ٦٠٠٧ (١٩٩٠).
- [١٢] M. J. Cooper and W. G. Stirling, Radiation Physics and Chemistry ٥٦, ٨٥ (١٩٩٩).
- [١٣] Y. Murakami, H. Kawata, et al., Physical Review Letters ٨١, ١٩٣٢ (١٩٩٨).
- [١٤] Y. Murakami, J. P. Hill, D. Gibbs, et al., Physical Review Letters ٨١, ٥٨٢ (١٩٩٨).
- [١٥] Y. Endoh, K. Hirota, S. Ishihara, et al., Physical Review Letters ٨٢, ٤٣٢٨ (١٩٩٩).
- [١٦] J. P. H. Zimmermann M. v. Doon Gibbs, M. Blume, D. casa, B. Kimer, Y. Murakami, Y. tomioka, and Y. Tokura, Physical Review Letters ٨٣, ٤٨٧٢ (١٩٩٩).
- [١٧] K. Nakamura, T. Arima, A. Nakazawa, et al., Physical Review B-Condensed Matter ٦٠, ٢٤٢٥ (١٩٩٩).
- [١٨] D. Laundy, Radiation Physics and Chemistry ٥٦, ١٥١ (١٩٩٩).

فصل سوم:

نظم بار، اوربیتال و اسپین در منگنایت ها

۱-۳ مقدمه

۲-۳ دستاوردهای جدید - سیگی اشعه X - سینکروترون ها

۳-۳ منگنایت ها

۴-۳ نظم بار و فاكتور پراکندگی غیر عادی

۵-۳ مکانیسم های بر هم کنش در منگنایت ها

۶-۳ اعوجاج های هشت وجهی MnO

۷-۳ نظم بار (CO) و نظم اوربیتال (OO)

۸-۳ انحلال حالت نظم بار

۹-۳ تاثیر پهنهای نوار انرژی

مراجع

۱-۳ مقدمه

در سال ۱۹۸۶ الکس مولر^۱ و جرج برنورز^۲ از IBM ابر رسانای دمای بالا را در اکسیدهای مس کشف کردند [۱]. این مساله توجه پژوهش‌ها را بسوی بررسی رفتار اکسید فلزات واسطه معطوف کرد. سپس در سال ۱۹۹۳ اثر دیگری تحت عنوان مقاومت مغناطیسی شدید^۳ (CMR) در برخی از اکسیدهای فلزات واسطه مشاهده شد [۲]. مقاومت مغناطیسی یک ماده به معنای تغییر در مقاومت آن ماده تحت اعمال یک میدان مغناطیسی است. اثر مشاهده شده در این منگنزهای با ساختار پروسکایت بسیار بزرگتر از موارد مشابه در دیگر مواد بوده و عبارت CMR برای تمایز آن از هر مقاومت مغناطیسی که به هر دلیل دیگر ممکن است در مواد بوجود آید، مورد استفاده قرار گرفت. کشف این خواص باعث شد که تحقیقات وسیعی بر روی مطالعه اکسیدهای فلزات واسطه با آلایش حفره‌ای، با استفاده از تکنیک‌های مختلف شامل: پراکندگی اشعه X، پراش نوترونی و الکترونی متمرکز شود.

این آزمایشات شواهدی از وجود نظام متناوب اسپین‌ها و بارها را در دماهای پایین، در ترکیبات منگنز، نیکل و مس نشان می‌دهد. حفره‌های تزریق شده در این ترکیبات باعث ایجاد یک سری نوارهای بار^۴ می‌شود که یک حالت تناوبی به خود می‌گیرد. بررسی رفتار نوارهای بار در اکسیدهای پروسکایت به جهت کسب اطلاعات بیشتری راجع به مقاومت مغناطیسی شدید و ابر رسانای دمای بالا و

^۱ - Alex Muler

^۲ - George Bednorz

^۳ - Colossal Magnetoresistance

^۴ - charge stripe

همچنین گسترش تئوری های جدید برای توصیف رفتار مواد، که البته با تئوری های جاری نوارهای الکترونی قابل توجیه نیستند، اهمیت دارد.

اولین گام برای کشف نوارهای بار همان طور که قبل اشاره شد در ۱۹۸۶ توسط مولر برداشته شد که به بررسی ابر رسانای دمای بالا در ترکیب $La_{2-x}Ba_xCuO_4$ پرداختند. در ۱۹۹۰ بیانکوئی^۱ یک مدولاسیون بار یک بعدی در صفحات ابر رسانای CuO_2 کشف کرد [۳] که بسیار شگفت انگیز بود چرا که در آن زمان پذیرفته شده بود که برای ابر رسانایی وجود یک سری صفحات صلب گونه و یکنواخت الزامی است. این کشف یک جداسازی میکروسکوپیک و همچنین غیر یکنواختی در صفحات یک شبکه ابر رسانا را نشان داد.

در ۱۹۹۳ چن^۲ و چونگ^۳ نظم نوارهای بار را در ترکیب $La_{2-x}Sr_xNiO_4$ کشف کردند [۴] و جانسون^۴ شواهدی مبنی بر وجود دیواره های^۵ یک بعدی بین حوزه های آنتی فرو مغناطیس در پروسکایت های مس در معادیر الایش بسیار کم یافت [۵]. در ۱۹۹۵ ترانکوادا^۶ مدولاسیون های بار را در پروسکایت عایق $La_{2-x}Nd_xCuO_4$ برای آلایش حفره ای $x=1/8$ مشاهده کرد [۶] و این را به منزله وجود نظم بار و اوربیتال متناسب نشتم مشاهده شده در منگنایت ها گرفت که از خود مقاومت مغناطیسی شدید CMR نشان داده بودند و دریافت که نوارها یک جدا سازی فاز میکروسکوپیک دارند.

مطالعه فیزیک نوارهای بار دریچه جدیدی را بر روی اثر متقابل بین هیبریداسیون و بر هم کنش ها گشود. هیبریداسیون عبارت از همپوشانی توابع موج الکترون های واقع در دو مکان مختلف است. این اثر کوانتوسی اجازه می دهد که الکترون از یک اتم به اتم دیگر پریده و باعث حرکت الکترون در شبکه می شود و لذا ایجاد یک توزیع بار یکسان در ماده می نماید. بر هم کنش الکترون ها با یکدیگر و هم چنین فواصل نا یکسان بین اتم ها در یک جامد، باعث توزیع نایکنواخت الکترون ها در یک ماده می شود. بنابراین جایی که هیبریداسیون غالب باشد نتیجه رسانا و یا عایق بودن است. در حالی که اگر بر هم کنش

^۱ - Bianconi

^۲ - Chen

^۳ - Cheong

^۴ - Johnston

^۵ - Domain wall

^۶ - Tranquada

ها غالب باشند، نظم بار می تواند به وقوع بپیوندد. در حالت نظم بار الکترون ها در یک الگوی منظم چیده می شوند که ابتدا تناوب آنها در زیرلایه های شبکه متناوب می باشد. بنابراین بطور کلی، نوع بر هم کنش ها و اثرات ناشی از هیبریداسیون تعیین کننده ساختار دقیق ماده است.

بنا براین می توان گفت که شکل گیری نوارهای بار ناشی از توافق بین اثر جایگزیدگی بر هم کنش ها و اثر غیر جایگزیدگی هیبریداسیون است. در طول یک نوار چگالی بار ثابت است در حالی که عمود بر راستای یک نوار چگالی بار با یک تناوب تغییر می کند. این تناوب نوارهای بار بستگی به میزان آلایش ماده دارد. برای مثال در $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ میزان آلایش با x مشخص می شود که با $x = 1/3$ در هر سه سلول واحد یک نوار بار وجود دارد. اگر $x = 1/2$ باشد در هر دو سلول واحد یک نوار وجود دارد. اگر بدین صورت فاصله بین نوارها مضرب صحیحی از پارامترهای شبکه باشد، گفته می شود که آنها متناسب^۱ هستند و اگر چنین نباشد آنها را نا متناسب^۲ با شبکه می نامند. نوارهای بار می توانند با پراش پرتو X آشکار سازی شوند اما آنها 10^{-4} بار کوچکتر از پیک های برآگ هستند. بنابراین چشممه های با شدت بالا مورد نیازند. ضمن اینکه پیک های نظم اوربیتال و اسپین، باز 10^{-6} مرتبه کوچکتر از این مقدار هستند [۶].

نظم این نوارها در اکسیدهای پروسکایت منگنز، مس و نیکل کشف شده است. همانطور که قبل اشاره شد برخی ترکیبات مس در دمای بالا ابر رسانایی از خود نشان می دهند که می تواند رابطه ای بین این اثر و نظم بار وجود داشته باشد اما این مبحث بسیار گسترده و وسیع است و هم اکنون در دست مطالعه می باشد. اکسیدهای عناصر واسطه ای که از خود نظم بار نشان داده اند همگی یک فرمول پایه مشترک دارند که در ترکیبات مس و نیکل بصورت L_xAO_4 (که L یکی از اعضای گروه لانتانیدها و A یک عنصر واسطه است) و برای منگنایت ها بصورت L_xAO_3 می باشد. ترکیبات مس و نیکل ساختار پروسکایت چند لایه دارند^۳ در حالی که منگنایتها دارای ساختار اصلی پروسکایت هستند^۴. این مواد در این حالت عایق هستند در حالی که اکر آلایش یابند، می توانند حالت فلزی رسانا یا ابر

^۱ - Commensurate

^۲ - Incommensurate

^۳ - Layered Peroskite Structure

^۴ - Basic Proskite Structure

رسانایی به خود گیرند. این مواد می توانند با یونهای دو ظرفیتی (مثل Sr^{2+}) آلایش یابند، که ظرفیت آلاینده یکی کمتر از یون لانتانید است، نتیجه این آلایش ایجاد حفره در سیستم می باشد و حرکت آزادانه این حفره ها خاصیت فلزی را برای ماده فراهم می آورد. اثرات هیبریداسیون و بر هم کنش (که در بالا اشاره شد) بر توزیع حفره ها تاثیر گذاشته و باعث می شود که در کمتر از دمای خاص T_{co} (دمای گذار نظم بار) حفره ها در نوارهای تناوبی نظم بگیرند. در حقیقت کاهش دما، باعث کاهش انرژی حامل های بار شده، لذا هیبریداسیون کاهش می یابد و لذا نظم بارها می تواند واقع شود. اگر کاهش دما باز هم ادامه یابد، در کمتر از دمای T_{so} (دمای گذار نظم اسپین) اسپین یونها به گونه آنتی فرومغناطیس نظم می گیرد. بنابراین نظم بار در دمای بالاتری از نظم اسپین اتفاق می افتد، بعارت دیگر نظم الکتریکی^۱ قبل از نظم مغناطیسی^۲ به وقوع می پیوندد. البته لازم به ذکر است که در ترکیبات مختلف دماهای گذار متفاوت بوده و همیشه T_{SO} کمتر از T_{CO} نمی باشد.

۳-۲ دستاوردهای جدید در پراکندگی اشعه X - سینکروترون ها

تکنیک های جدید پراکندگی اشعه X برای آشکارسازی ساختار و رفتار مغناطیسی مواد، در طی ده سال اخیر توجه زیاد دانشمندان را به خود جلب کرده است و تلاش های جدی برای ادامه گسترش این تکنیک ها بخصوص افزایش شار فوتونی اشعه X بوسیله منابع سینکروترون مدرن، در حال صورت گیری است. گونه های بسیاری از مواد بوسیله آزمایشات اشعه X مورد بررسی قرار گرفته اند. شامل اکتنیدها، فلزات قلیایی خاکی و فلزات واسطه و در فرم های متفاوت مانند اجزای حجمی^۳، لایه های نازک، آلیاژها و چند لایه ها^۴ امروزه چشم انداز نقش پراکندگی پرتو X در مطالعه مغناطیسی کاملا با ۳۰ سال پیش، یعنی هنگامی که برگوین^۵ و بروول^۶ اولین نتایج پراکندگی مغناطیسی پرتو X بر روی نمونه NiO که بوسیله منبع معمولی بدست آمده بود، گزارش کردند (۱۹۷۲)، متفاوت است [۷]. بنابراین

- Electronic Ordering
 - Magnetic Ordering
 - Bulk
 - multilayer
 - Bergvrim
 - Brunel

مناسب است بگوییم که پراکندگی مغناطیسی پرتو X بخشی از فیزیک شده و مسیری را به خود اختصاص داده است.

برای مشاهده نوارهای بار سه تکنیک مورد استفاده قرار می‌گیرد: پراکندگی نوترونی، الکترونی و پراکندگی پرتو X از آنجایی که پیک‌های بار ۱۰۰۰۰ بار کوچکتر از پیک‌های برآگ هستند، برای مشاهده آنها به یک منبع با شار بالا نیاز است. لذا پرتوهای X بهترین انتخاب هستند چرا که اولاً در منابع سینکروtronی امکان دستیابی به پرتوهای X پرشدت تر از راکتورهای نوترونی وجود دارد. ثانیاً نوترون‌ها مستقیماً با نوارهای بار برهم کنش نمی‌کنند. تشید پراکندگی پرتو X ^۱ (که هنگامی اتفاق می‌افتد که انرژی پرتو X فرودی بر لبه جذب منطبق شود) حساسیت‌هایی نشان می‌دهد که مستقیماً منجر به تعیین ساختار مغناطیسی می‌شود. این بوسیله تکنیک‌های دیگر امکان پذیر نیست. تعیین دقیق قطبیدگی پرتوهای ورودی و خروجی مسیر جدیدی برای تعیین ساختار مغناطیسی باز کرده است و اجازه جداسازی چگالی مغناطیدگی اسپین و اوربیتال را در جامدات فراهم نموده است. قابلیت تمرکز پرتوها و موازی سازی شدید آنها باعث افزایش قدرت تشخیص رفتار مغناطیسی و رفتار فازی نمونه‌های کوچکی مثل لایه‌های نازک می‌شود. در عوض مزیتی که پراش نوترونی دارد این است که به شکل گیری مغناطیسی در شبکه حساس است (چرا که نوترون‌ها تکانه مغناطیسی دارند) و برای آشکارسازی ساختار مغناطیسی و رفتار فازی تک بلورها و نمونه‌های پودری بکار می‌روند. تکنیک‌های پراکندگی نوترونی و اشعه X در بسیاری زمینه‌ها یک کاربرد دارند اما در کل مکمل یکدیگرند. پراش الکترونی نیز به نظم بار حساس است اما بدلیل اثرات پراکندگی، تنها قادر به آشکارسازی لایه‌های نزدیک به سطح نمونه هستند. می‌توانیم بگوییم که انتخاب تکنیک مناسب، فقط بستگی به جزئیات مورد مطالعه بستگی دارد.

فاکتور دیگر رشد سریع استفاده از پراکندگی مغناطیسی اشعد^۲، امکان دسترسی به تابش سینکروtronی در سراسر جهان است. در دهد گذشته سد منبع تابش سینکروtronی نسل سوم شروع بکار

- resonant x-ray scattering

کرده اند شامل: مجموعه تابش سینکروترونی اروپا^۱ (*ESRF*) در فرانسه، منبع فوتون پیشرفته^۲ (*APS*) در ایالات متحده و منبع فوتونی ۸ گیگا الکترون ولتی^۳ (*spring-8*) در ژاپن. در هر یک از این سینکروترون‌ها، خط باریکه‌هایی^۴ برای مطالعه پراکندگی مغناطیسی اختصاص یافته است [۷]. یک خط باریکه که به پراکندگی مغناطیسی پرتو X اختصاص یافته باید یک محدوده ای از انرژی، کمتر از 1 keV تا بیشتر از 30 keV ، را تامین می‌کند. لذا در استفاده و مطالعه از اشعه X دو حوزه را در نظر می‌گیریم. در محدوده پرتو X نرم، $\lambda < 100\text{ \AA}$ آزمایشات پراش بر روی ساختارهای طبیعی صورت نمی‌گیرد زیرا طول موج پرتو در مقایسه با فاصله پراش دهنده‌ها بسیار زیاد است، لذا هیچ پیک برآگی در کره اوالد دیده نمی‌شود. اما در مورد ساختارهای مصنوعی با پارامترهای ساختاری بلند این محدوده قابل کاربرد برای پراش است. در محدوده پرتو X سخت، $\lambda < 1\text{ \AA}$ پراش رخ می‌دهد. آزمایشات اشعه X تشدید یافته دارای ویژگیهای زیر است :

۱- در این آزمایشات ماده باید بدرستی تمیز شود و پرتو X بر روی آن مرکز شود (کانونی شود). در بسیاری نمونه‌ها یک همانگاه مغناطیسی در مکان‌های مشابهی با پیک‌های بار در شبکه وارون پدیدار می‌شوند. تنظیم واگرایی پرتو X برای تامین انرژی مورد نیاز آزمایش نیز مهم است (یعنی سازگار کردن انرژی پرتو با انرژی لازم برای پراکندگی تشدید). تحقیق در مورد پراکندگی از حجم کوچک مانند سطوح یا میکروبولورها و حوزه‌های مغناطیسی خاص، اگر تمرکز درست بر مکان نمونه، با تجهیزات اپتیکی و یا بالنزهای پرتو X پیشرفته جدید انجام شود آسانتر است.

۲- چنین آزمایشاتی نیازمند تعیین دقیق قطبیدگی پرتو X اولیه و در اغلب موارد تعیین قطبیدگی پرتو پراکنده شده می‌باشند. نصب وسایلی چون نوسان سازهای خطی بر روی منابع سینکروترونی مدرن، پرتوهای X با درجه آزادی بالا از نظر قطبیدگی خطی تامین می‌کند. سپس با استفاده از بلورهای مسطح خاص می‌توان قطبیدگی پرتو فرودی را بطور دلخواه، به فرم بیضوی یا خطی، تنظیم

- European Synchrotron Radiation
 - Advanced Photon Source
 - Super Photon Ring 8-GeV
 - Beamline

کرد. کریستال های آنالیزور نیز می توانند برای تعیین قطبیدگی پرتو پراکنده مورد استفاده قرار گیرند .
 ۳- چنین آزمایشاتی همچنین به پراش سنج های قوی نیاز دارند تا با استفاده از آن بتوان اسکن- های دقیق در فضای وارون با وضوح انرژی بالا بدست آورد .

۳-۳ منگنایت ها^۱

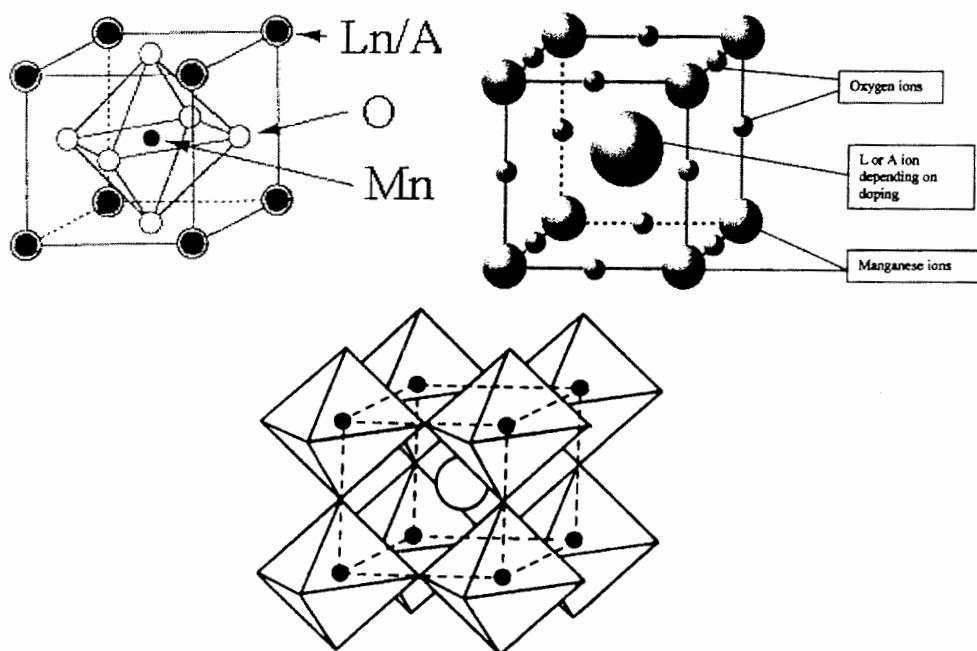
ترکیب منگنز با عناصر خاکی نادر که به منگنایت ها موسوم است به صورت کلی $Ln_{1-x}A_xMnO_3$ می باشد که Ln یکی از لانتانیدهای سه ظرفیتی مثل Sm, Eu, Y, Nd, Pr, La می باشد و A عنصر قلیایی خاکی دو ظرفیتی مثل Ca, Sr و Ba است. این ترکیبات ساختار پروسکایت دارند که در شکل ۱-۳ نشان داده شده است .

اگر چه ترکیبات مس و نیکل نیز شکل پروسکایت دارند، اما خواص الکتریکی آنها متفاوت است. به عنوان مثال در ترکیبات مس و نیکل، نوارهای بار در دو بعدی مشاهده شده، اما در منگنایت ها این نوارها سه بعدی هستند. پروسکایت ها مواد ایده آلی برای مطالعه بر روی فیزیک سیستم های الکترونی با همبستگی شدید^۲ هستند. مطالعه روی منگنایت ها از سال ۱۹۸۹ با مشاهدات تجربی مقاومت مغنا- طیسی شدید (CMR) در $Nd_{0.5}Pb_{0.5}MnO_3$ توسط کوستر^۳ و همکارانش [۸] و همچنین در $La_{2/3}Ba_{1/3}MnO_3$ توسط ون هلمولت^۴ و همکارانش آغاز شد [۹]. در منگنایت ها مقدار آلایش، x ، تناسب اتمهای Mn را در حالت اکسیداسیون Mn^{4+} کنترل می کند. علاوه بر کشف اثر مقاومت مغناطیسی شدید (CMR)، دو پدیده جالب دیگر، نظم بار (CO)^۵ و نظم اوربیتالی (OO)^۶ مشاهده شده است .

تغییر ظرفیت Mn با افزودن حفره به سیستم به حامل های بار می افزاید، حال آنکه کاتیون های کوچکتر تمایل به بروز رفتار نارسانایی دارند. هنگامی که ظرفیت Mn در ناحیه بین Mn^{3+} و Mn^{4+} است،

^۱ - Manganite
^۲ - Strongly Correlated Electronic Systems
^۳ - Kusters
^۴ - Von Helmolt
^۵ charge Ordering
^۶ Orbital Ordering

حالات های متفاوتی از ماده و چندین گذار فاز مرتبه اول مشاهده می شود، شامل فرومغناطیس (FM)، آنتی فرومغناطیس، (AFM) پارامغناطیس (PM) و حالت CO . ما این مساله را برای یکی از این



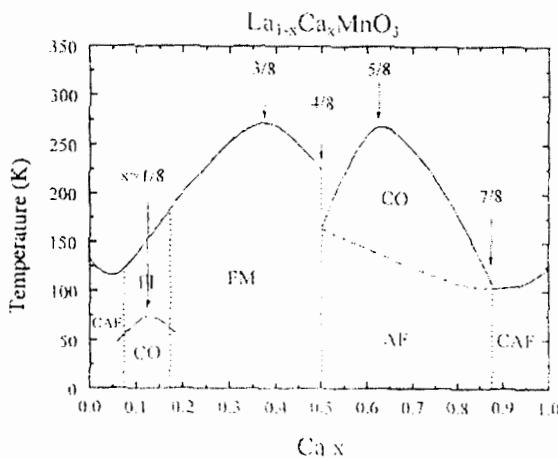
شکل ۳-۱: طرح شماتیک ساختار پروسکایت و هشت وجهی های MnO [۱۰]

منگنایت ها به تفصیل شرح می دهیم. در حالت فرومغناطیس الکترون ها متحرکند و چگالی بار در هر طرف Mn یکسان و برابر است. الکترون های متحرک فرومغناطیس را با هم خط کردن اسپین های مغزی^۱ در یون های Mn گسترش می دهد. این فرایند هم خط کردن اسپین ها، تبادل دوگانه^۲ (DE) نام دارد (بخش ۳-۵ را ببینید) با جداسازی بارها تناوبی بین موقعیت های متفاوت Mn^{3+} و Mn^{4+} اتفاق می افتد که یک حالت نظم بار است (و همچنین عایق). این یدیده اولین بار توسط ولان و کوهلر^۳ مشاهده شد [۱۱]. آزمایشات بسیاری نشان داده اند که خواص الکتریکی، مغناطیسی و ساختاری

^۱ - Core Spins
^۲ - Double Exchange
^۳ - Wollan & Kohler

منگنایت ها با تغییر در غلظت حامل های بار، تغییر می کند. اثر دما، اندازه کاتیون سه ظرفیتی و فشار بر روی خواص فیزیکی سیستم بطور وسیع مورد بررسی قرار گرفته است. نمودار فازی سیستم $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ بر حسب مقدار آلایش و دما در شکل ۲-۳ نشان داده است.

در غلظت های نزدیک به تناسب یکسان ($x \approx 0.5$) ناینجاری های مشاهده می شود که حالت الکترونی می تواند به سرعت و ناگهانی تغییر کند. رفتار این سیستم تقریبا در تمام گستره آلایش تحت مطالعه قرار گرفته است. این ترکیب و دیگر ترکیب ها هنگامی که در حالت بدون آلایش حفره ای قرار داشته باشند ($x=0$) مثل $NdMnO_3$ ، $CaMnO_3$ ، $PrMnO_3$ ، $LaMnO_3$ همگی در همه دماها عایق هستند. برای میزان آلایش $x=0.5$ در کمتر از $T=250K$ ، ماده حالت فرومغناطیس دارد یعنی تمام اسپین ها هم جهت شده اند. حالت فرمغناطیس در آلایش $x=0.875$ دارای بیشترین دمای گذار است.

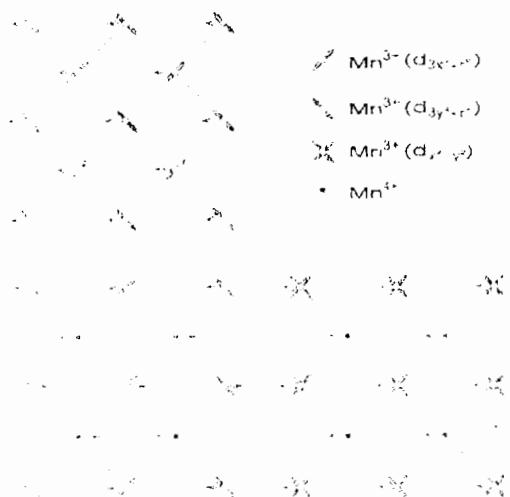


شکل ۲-۳: دیاگرام فازهای متغیر $La_{1-x}Ca_xMnO_3$ بر حسب غلظت های متغیر Ca [۱۲]

با سرد کردن نمونه گذار از پارامغناطیس به فرمغناطیس اتفاق می افتد. همزمان با این انتقال فاز، تغییراتی در پارامترهای شبکه، افزایش در مغناطیدگی و کاهش شدید در مقاومت مشاهده می شود [۱۲]. برای آلایش $x=0.875$ یک حالت نظم بار انتی فرمغناطیس گونه در کمتر از دمای گذار

وجود دارد. در حوالی $x=0.5$ حالت فرومغناطیس رو به ناپایداری می‌گذارد، گویا که یک حالت رقابت بین حالت‌های فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس وجود دارد. با تغییر آلایش ساختار اسپینی نیز تغییر می‌کند که در شکل ۳-۳ مشاهده می‌شود.

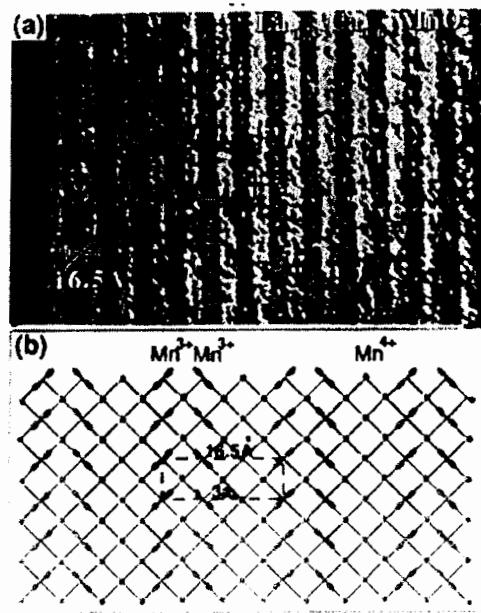
در آلایش $x=0$ ، نمونه آنتی فرومغناطیس عایق است و نوع A می‌باشد. در صفحه اسپین‌ها آرایش فرومغناطیس دارند و همگی در یک جهت یکسان قرار گرفته‌اند. اما در صفحات مجاور اسپین‌ها در جهت مخالف قرار دارند و لذا دارای آرایش آنتی فرومغناطیس بین صفحات مجاور است. نظم بار وجود ندارد چرا که تنها یون‌های Mn^{3+} در شبکه موجود هستند. اما نظم اوربیتال وجود دارد. در آلایش $x=0.5$ یون‌های Mn^{4+} به شبکه وارد شده و رو به افزایش می‌نمایند و دیگر امکان نظم بار فراهم می‌گردد. چرا که همه اوربیتال‌های e_g اشغال شده نیستند. در آلایش $x=0.5$ میزان حضور یون‌های Mn^{3+} و Mn^{4+} یکسان است و نظم بار پایدار می‌تواند تشکیل گردد. قسمت چپ پایین شکل ۳-۳ نشان دهنده نظم بار آنتی فرومغناطیس CE است که حداکثر در $x=0.5$ شروع به شکل گیری می‌کند. مشاهده می‌شود که اسپین‌ها در صفحه جهت گیری آنتی فرومغناطیس گونه دارند. در مقدار آلایش $x>0.5$ احتمال حضور اوربیتال‌های t_{2g} بیشتر از اوربیتال‌های d_{xy} است که در قسمت راست پایین شکل ۳-۳ نشان داده شده است.



شکل ۳-۳: طرح شماتیک نظم بار، اسپین و اوربیتال در منگنات‌ها برای آلایش‌های $x=0.5$.

تصویری را که با استفاده از پراش الکترونی از نوارهای بار در این سیستم گرفته شده همراه با طرح شماتیک نظم بار و اوربیتال در شکل ۴-۳ مشاهده می کنید. این جفت نوارها (که تاکنون تصور می شد که تک نوار هستند) بطور تناوبی در کنار یکدیگر قرار گرفته اند.

در منگنایت های با ساختار پروسکایت، دافعه کولنی، اثر اعوجاج یان-تلر^۱ بر روی ترازهای انرژی^{۴,۵} اغتشاشات شبکه برخاسته از برهم کنش های الکترون-شبکه، و برهم کنش تبادل دوگانه (DE) نقش بسیار مهمی را در بسیاری از حالت های متفاوت ماده، مخصوصا در ثبات حالت نظم بار بازی می کنند [۱۱] به عنوان مثال در حالت فرومغناطیس برهم کنش مغناطیسی غالب تبادل دوگانه (DE) ناشی از جفت شدن قوی هوند^۲ مربوط به الکترون سیار^{۶,۷} با الکترون های^{۸,۹} است. در حالی که در فاز نظم بار برهم کنش غالب، تبادل چندگانه^{۱۰} است.



شکل ۴-۳: تصویر به دست امده از $\text{La}_{1-x}\text{Sr}_x\text{MnO}_3$ با استفاده از برآکندگی الکترونی

^۱ - Jahn-Teller
^۲ - Hund
^۳ - Super Exchange

۴-۳ نظم بار و فاکتور پراکندگی غیر عادی^۱

الکترون ها بوسیله نیروهایی، که اندازه آن ها بستگی به قدرت میدان اتمی هسته و نیز به حالت کوانتومی الکtron دارد، به هسته مقید می شوند. بنابراین می توانیم آن ها را به عنوان نوسانگرهایی با یک فرکانس طبیعی در نظر بگیریم که اگر فرکانس پرتو تابیده به آن، بر این فرکانس طبیعی منطبق شود، تشديد اتفاق می افتد. «پراکندگی غیرعادی» عبارتست از آشکار سازی پرتو X مربوط به این اثرات. نزدیک به هر لبه جذب اتمی (در این مورد لبه K) فاکتور پراکندگی اتمی با معادله زیر نشان داده می - شود .

$$f(E) = f_0 + f'_0(E) + f''_0(E) \quad (4-3)$$

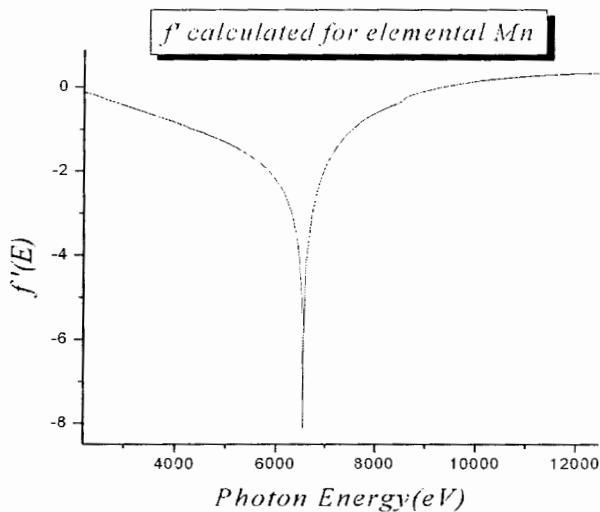
که در آن f فاکتور پراکندگی تامسون و f' و f'' قسمت های حقیقی و موهومی فاکتور پراکندگی غیرعادی است. f مستقل از انرژی است اما f' و f'' توابعی از انرژی هستند و اشکال ۳-۵ و ۶-۳ (داده ها از اینترنت گرفته شده اند) نشان می دهد که چگونه آن ها در لبه K ای منگنز تغییر می کنند. نمودارها یک تغییر تیز \downarrow مقادیر پراکندگی غیرعادی لبه K نشان می دهند و اگر اثرات جذب مشاهده شوند یک پیک تشید تیز \uparrow می رود. یک راه ساده برای پی بردن به رفتار فاکتور پراکندگی غیر عادی عبارت است از به یاد آوردن مطالعه دیفرانسیل کلاسیکی برای ذره ای با جرم m و بار e در یک میدان متناوب با شدت $E_{0i} \exp(i\omega t)$ این معادله دیفرانسیل عبارتست از [۱۳] :

$$\frac{d^2x}{dt^2} + g \frac{dx}{dt} + \omega_0^2 x = E_{0i} \exp(i\omega t) \quad (4-4)$$

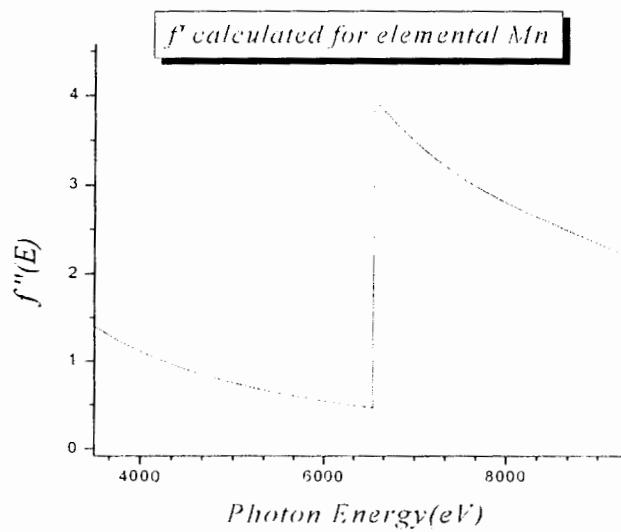
فرکانس طبیعی مربوط به ذره مرتعش و ω فرکانس پرتو فرودی و g نیروی میرایی متناسب با سرعت است. از حل معادله دیفرانسیل بالا چنین بدست می آید :

$$x(t) = \frac{cE_{0i}}{\omega_0^2 - \omega^2 + ig\omega} \exp(i\omega t) \quad (4-5)$$

^۱ Anomalous Scattering Factor



شکل ۳-۵: نمودار f' عنصر Mn بر حسب انرژی در حوالی لبه جذب



شکل ۳-۶: نمودار f'' عنصر Mn بر حسب انرژی در حوالی لبه جذب

گشتاور قطبیدگی هر دو قطبی از حاصلضرب ϵ در فاصله بدست می اید ($\epsilon\chi_{(i)}$). پذیرفتاری الکتریکی

یک مجموعه شامل // دوقطبی جفت نشده با رابطه زیر بدست می آید:

$$\chi = \frac{Zex_o}{E_{oi}} = \frac{Ze^2}{m} \frac{1}{\omega_o^2 - \omega^2 + ig\omega} \quad (4-3)$$

این یک تابع مختلط از پرتو فرودی است. میدان الکتریکی تولید شده با این دوقطبی نوسانگر اندازه ای

مساوی با $\frac{\omega^2}{rc^2}$ برابر گشتاور دوقطبی اش دارد، و این میدان با رابطه زیر به دست می آید :

$$E_d = E_{od} \exp(i\omega t) = \frac{\omega^2}{rc^2} ex(t) = \frac{\omega^2 e^2}{mrc^2} E_{oi} \frac{\exp(i\omega t)}{\omega_o^2 - \omega^2 + ig\omega} \quad (5-3)$$

برای یک الکترون آزاد و نامیرا $g = \omega_0 = \omega$ است و میدان الکتریکی تولید شده توسط گشتاور دوقطبی برابر است با :

$$E_d = (E_d)_{Th} = \frac{-e^2}{mrc^2} E_{oi} \exp(i\omega t) = \frac{e^2}{mrc^2} E_{oi} \exp[i/\omega t + \pi] \quad (6-3)$$

این شبیه به همان چیز است که برای پراکندگی تشید نیافته تامسون صادق است و نشان می دهد که یک تاخیر فاز π بین پرتو پراکنده و فرودی وجود دارد. اگر $g < \omega$ باشد شکل E_d خیلی متفاوت با آن چیزی که در مورد الکترون آزاد بکار می رود نیست، بنابراین پراکندگی تامسون فقط دور از لبه جذب وجود دارد. فاکتور پراکندگی برای یک الکترون می تواند با نسبت

$$f_e = \frac{E_{od}}{(E_{od})_{Th}} \text{ تعريف شود :}$$

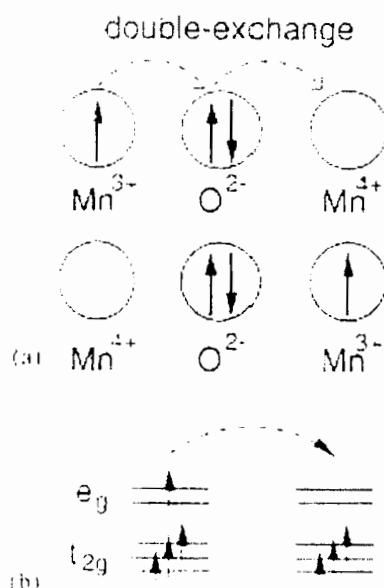
$$f_e = \frac{E_{od}}{(E_{od})_{Th}} = \frac{\frac{\omega^2 e^2}{mrc^2 (\omega_o^2 - \omega^2 + ig\omega)}}{\frac{-e^2}{mrc^2}} = \frac{\omega^2}{\omega^2 - \omega_o^2 - ig\omega} = \frac{\omega^2 [\omega^2 - \omega_o^2 + ig\omega]}{(\omega^2 - \omega_o^2)^2 + g^2 \omega^2} \quad (7-3)$$

$$= \frac{\omega^2 (\omega^2 - \omega_o^2)}{(\omega^2 - \omega_o^2)^2 + g^2 \omega^2} + i \frac{g\omega^3}{(\omega^2 - \omega_o^2)^2 + g^2 \omega^2} = f' + if''$$

شکل شدت پیک های ناشی از نظم بار و اوربیتال وابسته به پراکندگی غیرعادی هستند .

۳-۵ مکانیسم های بر هم کنش در منگنايت ها

یکی از برهم کنش های تاثیرگذار بر روی ویژگی های الکتریکی و مغناطیسی چنین موادی مکانیسم تبادل دوگانه^۱ (DE) می باشد. این برهم کنش به دو حالت ظرفیت Mn^{3+} و Mn^{4+} کاتیون ها نیاز دارد. این مکانیسم مسئول برقراری حالت فرومغناطیس در منگنايت ها است. بین اسپین الکترون های جایگزیده تراز $3d$ (یعنی الکترون های t_{2g}) یک جفت شدگی فرومغناطیس وجود دارد و در عین حال تبادل انرژی جنبشی از طریق الکترون غیر جایگزیده $3d$ (یعنی الکترون e_g) صورت می گیرد. تبادل دوگانه به الکترون اجازه انتقال بین دو اتم مجاور Mn^{3+} و Mn^{4+} را می دهد. این کار را الکترون غیر جایگزیده e_g انجام می دهد، البته به شرط آنکه اسپین الکترون های تراز d دو یون Mn بصورت موازی یا تقریباً موازی قرار گرفته باشد. تصویر شماتیک این مکانیسم را در شکل ۷-۳ مشاهده می کنید.



شکل ۳-۷: تصویر شماتیک مکانیسم تبادل دوگانه. پرش الکترون e_g بین دو اتم Mn از طریق بین O [۱۴].

این دو حالت $O-Mn^{3+}-O$ و $O-Mn^{4+}-O$ نشان داده شده در شکل تبیهکن هستند. بنابر این در کمتر از دمای کوری T_c الکترون e_g ازاد است که بین اتم های Mn^{3+} و Mn^{4+} از طریق اوربیتال اکسیژن

- Double exchange

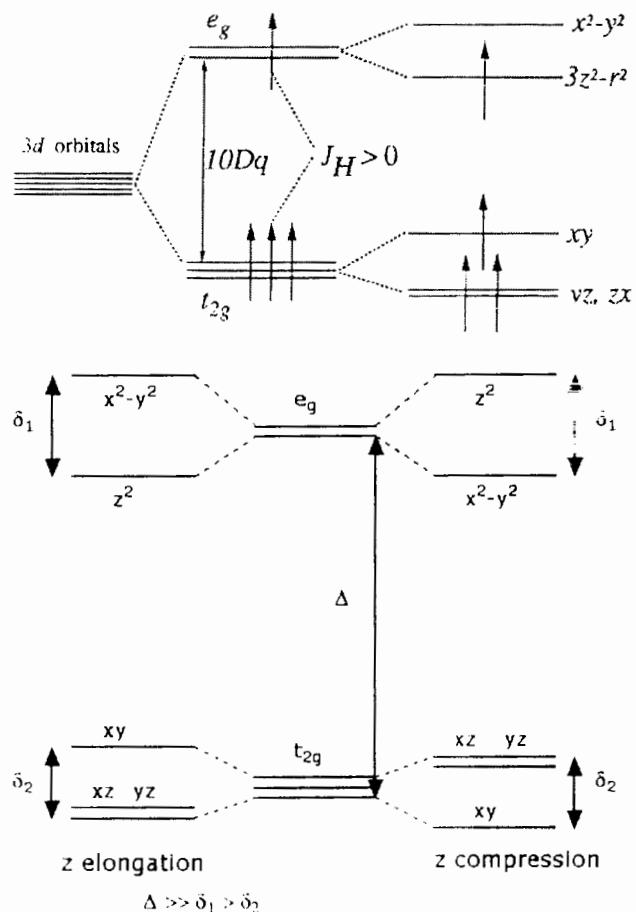
که در وسط دو یون واقع شده، براساس مکانیسم تبادل دوگانه منتقل شود. اما هنگامی که Mn^{3+} و Mn^{4+} در یک طرح نظم یافته قرار گرفتند شرایط برای تبادل دوگانه تغییر می کند. زیرا در این حالت دیگر آن دو تبهگن نیستند. بنابراین بین تبادل دوگانه (که مسئول برقراری فرومغناطیس است) و نوارهای نظم بار، اوربیتال یک حالت رقابت وجود دارد. چرا که نظم بار نیازمند جایگزینی بارهاست در حالی که مکانیسم DE نیازمند پرش الکترون از یون Mn^{3+} و Mn^{4+} از طریق یون O^{2-} می باشد. بنابراین دلیل می توان توضیح داد که چرا در یک مقدار آلایش خاص فقط می تواند یکی از دو حالت فرومغناطیس فلزی یا نظم بار آنتی فرومغناطیس را مشاهده کرد.

مکانیسم مهم دیگر برهم کنش یان-تلر^۱ (J-T) است. بر طبق این تئوری کاملاً شناخته شده، تبهگنی اوربیتالی منجر به ناپایداری سیستم شده و تغییر ساختار الکترونی شبکه را به همراه دارد. یون هایی که اثر J-T در آن ها قدرت بیشتری دارد عبارتند از Cu^{3+} (d^9 یک حفره در اوربیتال e_g با تبهگنی دوگانه)، Ni^{3+} (d^8 با یک اوربیتال e_g)، Mn^{3+} (d^5 با یک اوربیتال e_g) و Cr^{3+} (d^4 با یک اوربیتال e_g). این یون ها، یون های J-T نامیده می شوند زیرا تبهگنی اوربیتالی مورد بحث در اوربیتال هایی وجود دارد که قسمت پهن و گرد آنها^۲ به سمت جلوی لیثاند ها (اوربیتال های اکسیژن) جهت گرفته اند لذا آنها هیبریداسیون شدیدی با لیثاند های مجاور دارند. (هیبریداسیون بستگی بسیار زیادی به فاصله کاتیون-آنیون دارد).

یون Mn^{3+} چهار الکترون در تراز $3d$ خود دارد. این چهار الکترون بر طبق قانون هوند بخارط کاهش نیروی دافعه هم جهت شده اند [۱۱]. برهم کنش های الکترونی بین این چهار الکترون و میدان بلوری (ناشی از یون های اکسیژن مجاور) باعث شکافتمن این ترازهای $3d$ با تبهگنی پنج گانه به دو زیرلایه انرژی می شود. سه تا از این الکترون ها تراز انرژی پایین تر^۳، با تبهگنی سه گانه، را اشغال می کنند و الکترون باقیمانده تراز انرژی بالاتر^۴، با تبهگنی دوگانه، را اشغال می کنند. این حالت بسیار ناپایدار است و این منجر به اثر شناخته شده یان-تلر (J-T) می شود که سیستم انرژی خود را از طریق شکافتمن

^۱- Jahn Teller
^۲- lobes

این حالت دوگانه به دو زیر لایه انرژی کاهش می‌دهد. شکل ۳-۸ این اثر را نشان می‌دهد. بر هم کنش J-T باعث دگر شکلی هشت وجهی MnO_6^4 می‌شود. در ترکیب $LaMnO_3$ با جانشین کردن یک عنصر قلیایی خاکی دو ظرفیتی مانند کلسیم یا استرنسیوم به جای بعضی از اتم‌های لانتانیوم ظرفیت از Mn^{3+} حالت کلی Mn^{4+} به آمیزه ای از Mn^{3+} و Mn^{4+} تغییر می‌یابد و حفره‌هایی در تراز انرژی eg ایجاد می‌گردند.



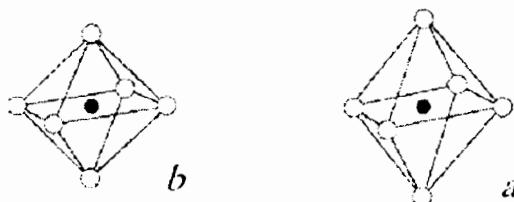
شکل ۳-۸: طرح شماتیک شکافتنی ترازهای ۳d با تجهیزی پنج گانه، ناشی از اثر بان تلر [۱۴]

deformation

۳-۶ اعوجاج های^۱ هشت وجهی MnO_6

اعوجاج ساختمان هشت وجهی MnO_6 به علت اثر $J-T$ نقش مهمی در گذار مرتبه اول فلز- نارسانا^۲

(MI) در اکسید های منگنز بازی می کنند. اعوجاج $J-T$ اثر زیادی در طبیعت عایق گونه و خواص مغناطیسی ناهمسانگرد این سیستم ها دارد. به طور کلی سه نوع اعوجاج در منگنایت ها وجود دارد [۱۵]. یکی کج شدن هشت وجهی MnO_6 (یکسان نبودن زوایا) ناشی از ناجور بودن شعاع اتمی است. شکل ۹-۳ این اعوجاج را نشان می دهد. اعوجاج دیگر هشت وجهی به علت اثر $J-T$ (به خاطر وجود یون Mn^{+3}) بوده و باعث کوتاه و بلندشدن باند $Mn-O$ می شود. شکل ۴-۵ را ببینید. این اعوجاج باعث شکافتن باند e_{F} شده و یک گاف نواری در تراز فرمی ایجاد می کند.

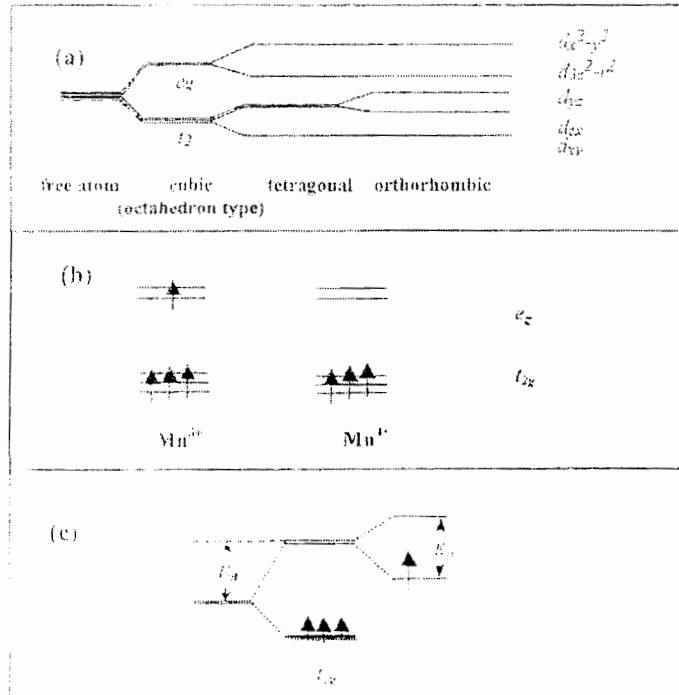


شکل ۹-۳: a) هشت وجهی اعوجاج یافته Mn^{+3} و b) اعوجاج نیافته Mn^{+3} [۱۴]

آلایش حفره ای (افزودن Mn^{+3} به سیستم) این اعوجاج را کاهش می دهد. حضور Mn^{+3} دو نقش اساسی در منگنایت ها بازی می کند: امکان مکانیسم تبادل دوگانه لازم برای رفتار فرومغناطیسی فلزی را تامین می سازد و نیز به از بین رفتن اعوجاج یان- تلر مربوط به یون های Mn^{+3} کمک کرده و ساختار را بد مکعبی نزدیک تر می سازد. اعوجاج دیگر که به «Breathing» موسوم است که به هشت وجهی ایجاد شده توسط یون های اکسیژن حول یک یون Mn بر می گردد و بستگی به وجود یا عدم وجود چتالی بار ε_{H} در این هشت وجهی دارد. همانطور که در قسمت ۱۰-۳ مشاهده می شود، اگر اوربیتال ε_{H} اشغال نشده باشد اعوجاج Breathing رخ می دهد و می تواند انرژی اوربیتال دوگانه ε_{H} را به اندازه ε_{H} کاهش دهد [۱۵].

^۱- distortion

^۲- Metal-Insulator Transition



شکل ۳-۱(a): طرح شماتیک ترازهای انرژی اوربیتالهای $3d$ در منگنایت‌ها

(b) حالت‌های الکترونی Mn^{3+} و Mn^{4+}

(c) تأثیر اعوجاج‌های *Breathing* و بان-تلر در منگنایت‌ها

۷-۳ نظم بار (CO) و نظم اوربیتال (OO)

نظم بار پدیده‌ای است که در گستره وسیعی از مواد شامل عناصر مغناطیسی مشاهده شده است و به معنای جایگزینی حامل‌های بار الکتریکی در موقعیت‌های خاصی در شبکه بلور می‌باشد. این در دمایی کمتر از T_{co} اتفاق می‌افتد و نظمی را در بلور به وجود می‌آورد که البته بستگی به میزان آلایش حفره‌ای سیستم دارد. از نظر تاریخی مشاهده نظم بار در منگنایت‌ها برای اولین بار توسط ولان و کوهلر^۱ صورت گرفت [۱]. همان طور که در بالا ذکر گردید، برهم کنش‌های رقابتی عمدۀ در منگنایت‌هایی که در آن‌ها اثر MR مشاهده شده عبارتند از برهم کنش $J-T$ که به بروز رفتار

^۱ Wollan & Koehler

نارسانایی کمک می کند و تبادل دوگانه که به رفتار فلزی می انجامد. نظم بار با تبادل دوگانه در توافق نیست و بیشتر به بروز رفتار نارسانایی و آنتی فرو مغناطیس گونه می انجامد. در ترکیباتی با فرم کلی $Ln_{1-x}A_xMnO_2$ بسته به یون های Ln و A , نظم بار در گستره متغیری بسته به نوع ترکیب مشاهده می شود. در $x = 0.5$ حضور یون های Mn^{3+} و Mn^{4+} به تعداد یکسان می رسد اما با افزایش x میانگین اعوجاج MnO_2 کاهش می یابد زیرا Mn^{4+} در اثر $J-T$ فعال نیست. بنابراین باید برهم کنش های بلند برد کولنی مسئول برقراری نظم بار باشد. اما در محدوده دماهای پایین باید علاوه بر این برهم کنش ها، مسائل دیگری را نیز در نظر گرفت.

با ایجاد نظم بار به شکل نوارهای منظم، در حقیقت جداسازی میکروسکوپیک حامل های الکترونیکی دیده می شود. در ترکیباتی که با Ca آلایش یافته اند، نظم بار در غلظتی بین $0.5 - 0.875$ دیده می شود (شکل ۲-۳ را ببینید). همانطور که در شکل ۲-۳ مشاهده می شود، دمای کوری T_c در مقدار $x=3/8$ ماکزیمم و پیک T_{co} در $x=5/8$ قرار دارد. نظم بار در $x=1/8$ نیز مشاهده می شود، جایی که سیستم یک گذار مرتبه اول از پارامغناطیس به فرومغناطیس و سپس به حالت نظم بار از خود نشان می دهد. این بی قاعده گی در غلظت نشان می دهد که جفت شدگی الکترون- شبکه^۱ نیز نقش مهمی در منگنایت ها بازی می کند.

همان طور که ذکر شد اعوجاج یان- تلر باعث می شود که فاصله بین یون Mn و آنیون های O^{2-} در حالتی که ظرفیت یون $+3$ و $+4$ است، با هم متفاوت باشد. که در هشت وجهی ای که در مرکز آن Mn^{3+} قرار دارد این فاصله از همه طرف یکسان است و یک هشت وجهی متقارن داریم، در حالی که در هشت وجهی ای که در مرکز آن Mn^{4+} قرار گرفته، فاصله دو تا از یون ها بیشتر از چهارتای بقیه است. (شکل ۹-۳) بنابراین هشت وجهی ای داریم که از دو طرف کشیده شده است. در منگنایت ها همه این هشت وجهی های کشیده در شرایط خاصی که به نظم اوربیتال موسوم است. با هم بطور موازی قرار می کیرند. تبیکنی دوگانه برای الکترون ψ بدین معنی است که دو اوربیتال برای اشغال کردن دارد، اوربیتال ψ_{-x} و اوربیتال ψ_r (شکل ۳-۱۰). این، دو درجه ازادی اسپینی و اوربیتالی را ناشی می

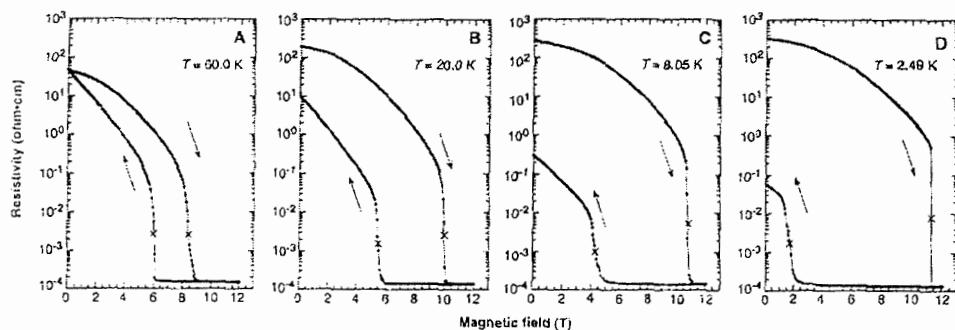
^۱ - electron-lattice coupling

۸-۳ انحلال حالت نظم بار

در اثر اعمال میدان مغناطیسی با شدت کافی، به تدریج نظم بار از بین می‌رود. هنگامی که حالت نظم بار در یک میدان مغناطیسی شروع به انحلال می‌نماید، مقاومت ویژه جسم نیز تغییر می‌کند. این می‌تواند ناشی از تحرک، r_A ، و یا چگالی حامل‌های آزاد، n و یا هر دو باشد. حساسیت حالت نظم بار به یک میدان مغناطیسی اعمال شده، بستگی به اندازه کاتیون آلایشی، r_A (یا به عبارت دیگر زاویه $Mn-O-Mn$) دارد. میدان لازم برای از بین بردن نظم بار، با r_A تغییر می‌کند. منگنایت‌های با r_A کوچکتر حتی تحت اعمال میدان مغناطیسی بالا نیز، حالت نظم بار در آنها از بین نمی‌رود. بستگی دمایی مقاومت ویژه بلور $Nd_{\text{--}}Sr_{\text{--}}MnO_2$ تحت اعمال میدان مغناطیسی نشان می‌دهد که دمای بحرانی انتقال نظم بار، با افزایش میدان مغناطیسی کاهش می‌یابد و به تدریج به سوی فرومغناطیس پیش می‌رود. اما بطور کلی حالت نظم بار نوع آنتی فرومغناطیس عایق، در تمام گستره دمایی، با اعمال میدان مغناطیسی بزرگتر از $77^\circ K$ از بین می‌رود. تاثیر میدان مغناطیسی بر مقاومت ویژه $Nd_{\text{--}}Sr_{\text{--}}MnO_2$ در دماهای مختلف را در شکل ۱۱-۳ مشاهده می‌کنید [۲۱].

برای $Nd_{\text{--}}Ca_{\text{--}}MnO_2$ با $r_A = 1.17$ یک میدان $77^\circ K$ بر مقاومت ویژه تاثیرگذاشته و ماده را در کمتر از $120^\circ K$ فلزی می‌کند. اما میدان مغناطیسی هیچ تاثیری بر مقاومت ویژه $Sm_{\text{--}}Ca_{\text{--}}MnO_2$ با $r_A = 1.16$ نمی‌گذارد. همچنین این مساله در مورد $Gd_{\text{--}}Ca_{\text{--}}MnO_2$ ($r_A = 1.143$) و $Dy_{\text{--}}Ca_{\text{--}}MnO_2$ ($r_A = 1.16$) و $K_{\text{--}}Ca_{\text{--}}MnO_2$ ($r_A = 1.127$) نیز صادق است [۲۲]. بنابراین می‌توان نتیجه گیری کرد که در کمتر از آن میدان‌های مغناطیسی بالاتر از $77^\circ K$ هیچ تاثیری بر نظم بار منگنایت‌ها نمی‌گذارد. بنابراین حالت نظم بار در منگنایت‌هایی که از $77^\circ K$ نیز هیچ تاثیری بر نظم بار منگنایت‌ها نمی‌گذارد. بنابراین (دما انتقال فاز نظم بار) بیشتر از $240^\circ K$ باشد پایدار است. مقادیر بالای $77^\circ K$ (دما انتقال فاز نظم بار) بیشتر از 1.17 با r_A با $La_{\text{--}}Cu_{\text{--}}MnO_2$ (با کمتر از $1.17^\circ K$ رخ می‌دهد [۲۳]). اما هنگامی که r_A بزرگتر از 1.24 می‌شود $77^\circ K$ صفر می‌گردد (به عبارت دیگر نظم بار برای چنین موادی مشاهده نمی‌شود). بنابراین می‌توان گفت که مقادیر 1.17 و 1.24 به عنوان حدود بالا و پایین r_A برای نظم بار در منگنایت‌ها تعریف می‌شوند.

با جانشین کردن O^{18} به جای O^{16} نیز می توان حالت نظم بار را به فاز فرومغناطیس تبدیل کرد. این مطلب دلالت بر این دارد که انرژی های حالت پایه این دو فاز، با وجود تغییرات وسیع در ترکیب بسیار نزدیک به یکدیگر باقی می ماند. جایگذاری Cr^{3+} و Ni^{3+} یا Mn^{3+} نیز حالت نظم بار را در $Ln\cdot A\cdot MnO_2$ از بین می برد. وانیتا^۱ و همکارانش در مقاله خود متذکر شده اند [۲۴] که پرش الکترون بین یون فلز واسطه با اوربیتال های e_g خالی (یعنی عناصر جانشین شده در ترکیب) و یون



شکل ۱۱-۳: تغییرات مقاومت ویژه بر حسب میدان مغناطیسی اعمالی در دماهای متفاوت [۲۵]

Mn^{3+} می تواند شرط کافی برای از بین رفتن حالت نظم بار در این مواد باشد. Co و Ni هر دو در این نوع ترکیبات در وضعیت $3+$ قرار دارند. اگر آن ها در وضعیت $2+$ قرار گیرند تغییری در آن ها ایجاد می شود مشابه آنچه که در تبدیل Mn^{3+} به Mn^{2+} اتفاق می افتد.

۳-۹ تاثیر پهنهای نوار انرژی

سه الکترون جایگزیده اوربیتال $3d$ یون منگنز، که در موقعیت $\frac{1}{2}z$ قرار دارند از نظر انرژی در کف تراز $3d$ قرار دارند. هر کدام از اکسیژن های هشت وجهی سهمی از الکترون $\frac{5}{2}z$ منگنز می برنند و لذا یک نوار انرژی برای این الکترون وجود خواهد داشت. عرض این نوار انرژی (W) بستگی به مقدار همپوشانی^۲ اوربیتال های منگنز و اکسیژن دارد و تاثیر بسیار زیادی بر روی حرکت حامل های بار دارد. این پارامتر

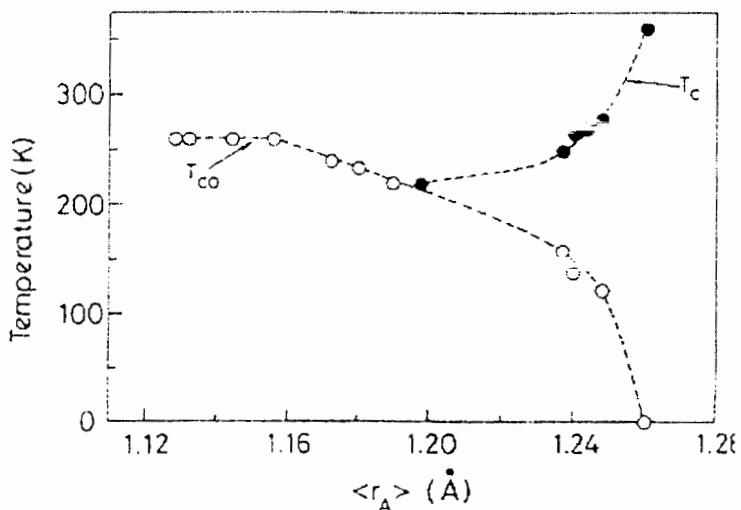
^۱- Vanitha
^۲-Overlap

و میزان پر شدن این نوار (یا همان میزان غلظت آلایش) دو کمیت مهم در ساختار پروسکایت هستند. این دو پارامتر تعیین کننده انرژی جنبشی الکترون های رسانش هستند و این الکترون ها نیز نقش اساسی در گذار فلز نارسانا و همچنین برهم کنش های رقابتی مغناطیسی یعنی فرومغناطیسی و آنتی فرومغناطیسی دارند. تغییر در ترکیب شیمیایی منگنایت ها می تواند منجر به تغییر در پهنهای نوار و نحوه پرشدن آن شود.

در یک پروسکایت ایده آل زاویه $Mn - O - Mn$ 180° است و همپوشانی اوربیتال های منگنز-اکسیژن بیشینه می باشد. اگر چه در یک سیستم واقعی همچون $Nd_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ این مقدار کاهش زیادی می یابد و زاویه مذکور به $166/13^\circ$ می رسد و یا در $La_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ مقدار $176/73^\circ$ می باشد [۲۵]. این، همپوشانی بین اوربیتال ها و پهنهای نوار انرژی را افزایش می دهد. افزایش انرژی جنبشی الکترون های رسانش سبب پایداری حالت فرومغناطیسی می گردد. به همین دلیل در $Nd_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ یک نظم بار- اسپین نوع CE مشاهده می شود اما $La_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ با نوار انرژی پهن تر، در کمتر از $T_c = 340K$ فرومغناطیس باقی می ماند. با افزایش \mathcal{W} زمینه برای مکانیسم تبدیل دوگانه و رسانش فلزی در لایه های فرومغناطیس مربوط به ساختار آنتی فرومغناطیسی گونه نوع A . از طریق افزایش انرژی جنبشی الکترون های e_g فراهم می گردد [۲۶]. با افزایش تدریجی \mathcal{W} ، قبل از پایداری فرومغناطیس، نظم بار نوع CE کم کم متوقف شده و فاز آنتی فرومغناطیس نوع A تشکیل می گردد. به عبارت دیگر با کاهش \mathcal{W} جایگزینی حامل ها بیشتر می شود و زمینه ایجاد نظم بار- اوربیتال فراهم می گردد. بنابراین گذار نظم بار تحت تاثیر پهنهای نوار الکترون های e_g قرار دارد. کنترل پهنهای نوار به وسیله شعاع کاتیون های A ، یعنی r_A صورت می گیرد، کوچکتر منجر به کاهش پهنهای نوار e_g شده و شرایط نظم بار- اوربیتال مساعد می گردد.

کاهش پهنهای نوار \mathcal{W} الکترون های e_g را از حالت سیار بد حالت جایگزینی متمایل می سازد و این منجر به افزایش r_A می گردد [۲۸]. برای مثال $La_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ با $r_A = 1.26$ در $r_{e_g} = 1.24$ تحت خنک سازی در حوالی $160^\circ C$ فرومغناطیس شده و بد سوی کذار فلز- نارسانا پیش می رود. در حالی که $Nd_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ با مقدار اندکی کوچکتر 1.236 در $160^\circ C$ بد فاز نظم بار آنتی فرومغناطیس

گذار می یابد. دمای گذار نظم بار T_{CO} در $Nd_{0.5}Ca_{0.5}MnO_2$ با $\langle r_A \rangle = 1.17\text{\AA}$ تقریباً $250K$ است و در تمام دماها عایق می باشد. فرومغناطیس و نظم بار در منگنایت ها بستگی بسیار زیادی به شعاع متوسط کاتیون های A دارد. بستگی دماهای گذار فرومغناطیس و نظم بار به شعاع متوسط کاتیون A را در شکل ۱۲-۳ مشاهده می کنید. بنابراین می توان نتیجه گرفت که زاویه باند $Mn - O - Mn$ شدیداً تحت تاثیر شعاع متوسط کاتیون A قرار دارد و بالطبع پهنهای نوار انرژی الکترون e_g بستگی زیادی به r_A دارد. نظم بار اثر زیادی بر مقاومت ویژه منگنایت ها دارد و معمولاً مقاومت ویژه یک افزایش شدید در دمای T_{CO} نشان می دهد که بخاطر قوت گرفتن ویژگی نارسانایی است که در تضاد با حضور فاز فرومغناطیس است [۲۹].



شکل ۱۲-۳: تغییرات دمای گذار نظم بار T_{CO} و دمای گذار فرومغناطیس T_C ، بر حسب شعاع متوسط کاتیون A .

[۲۹]

مراجع

- [١] J.Bernors, K.A Muller, Zeitsch for physics B-Condensed Matter ٦٤, ١٨٩ (١٩٨٦)
- [٢] R.von Helmolt, J.Walker, B.Holzapfel, et al Physical Rev Letters ٧١, ٢٣٣ (١٩٩٣)
- [٣] A. Bianconi, S.Dellalonga, et al Physical Rev B ٤٤, ١٠١٢ (١٩٩١)
- [٤] C.H.Chen, S.W.Cheong, A.S.Cooper.Physical Rev Letters ٧١, ٢٤٦ (١٩٩٣)
- [٥] J.H.Cho, F.C.Chou, D.C.Johnston, Physical Rev Letters ٧٠, ٢٢٢ (١٩٩٣)
- [٦] J.M.Tranquada, B.J.Sternlieb, J.D.Axe, et al Nature ٣٧٥, ٦٥ (١٩٩٥)
- [٧] "Third-Generation Hard X-ray Synchrotron Radiation Sources". Dennis M.Mills
- [٨] R. M. Kusters, J. Singleton, D. A. Keen, et al., Physica B ١٥٥, ٣٦٢ (١٩٨٩).
- [٩] R. Vonhelmolt, J. Wecker, B. Holzapfel, et al., Physical Review Letters ٧١, ٢٣٣ (١٩٩٣).
- [١٠] Y. Tokura, in Colossal magnetoresistive oxides, edited by Y. Tokura (Gordon and Breach Science publishers, Vol ١, p. ١).
- [١١] E. O. Wollan and W. C. Koehler, Phys. Rev. ١٠٠, ٥٤٥ (١٩٥٥).
- [١٢] S.-W. Cheong, in Colossal magnetoresistive oxides, edited by Y. Tokura (Gordon and Breach Science publishers, ٢٠٠٠), Vol ١, p. ٢٣٧.
- [١٣] Fundamental of crystallography, C.Giacovazzo, et al. Oxford science publication ١٩٩٥
- [١٤] E. Dagotto, T. Hotta, and A. Moreo, Physics Reports ٣٤٤, ١ (٢٠٠١).
- [١٥] P. Dai, J. D. Zhang, H. A. Mook, et al., Physical Review B ٥٤, R٣٦٩ (١٩٩٦).
- [١٦] L. Pinsard, J. RodriguezCarvajal, A. H. Moudden, et al., Physica B ٢٣٤, ٨٥ (١٩٩٧).
- [١٧] Y. Murakami, J. P. Hill, D. Gibbs, et al., Physical Review Letters ٨١, ٥٨ (١٩٩٨).
- [١٨] Y. Murakami, H. Kawada, H. Kawata, et al., Physical Review Letters ٨١, ١٩٣ (١٩٩٨).
- [١٩] K. Nakamura, T. Arima, A. Nakazawa, et al., Physical Review B-Condensed Matter ٦٠, ٢٤٢٥ (١٩٩٩).
- [٢٠] J. P. H. Zimmermann M. v, Doon Gibbs, M.Blume, D. casa, B. Kimer, Y. Murakami, Y. tomioka, and Y. Tokura, Rev. Lett. ٨٣, ٤٨٧ (١٩٩٩).
- [٢١] Y. Tokura, H. Kuwahara, Y. Moritomo, et al., Physical Review Letters ٧٦, ٣١٨ (١٩٩٦).
- [٢٢] A. Arulraj, R. Gundakaram, A. Biswas, et al., Journal of Physics-Condensed Matter ١١, ٤٤٤ (١٩٩٨).

- [۲۳] N. Kumar and C. N. R. Rao, Journal of Solid State Chemistry ۱۲۹, ۳۶۳ (۱۹۹۷).
- [۲۴] P. V. Vanitha, R. S. Singh, S. Natarajan, et al., Solid State Communications ۱۰۹, ۱۳۰ (۱۹۹۹).
- [۲۵] H. Kuwahara, Y. Tomioka, A. Asamitsu, et al., Science ۲۷۰, ۹۶۱ (۱۹۹۰).
- [۲۶] A. Llobet, C. Ritter, C. Frontera, et al., Journal of Magnetism and Magnetic Materials ۱۹۷, ۵۴۹ (۱۹۹۹).
- [۲۷] H. Kawano, R. Kajimoto, H. Yoshizawa, et al., Physical Review Letters ۷۸, ۴۲۰۳ (۱۹۹۷).
- [۲۸] N. Kumar and C. N. R. Rao, Journal of Solid State Chemistry ۱۲۹, ۳۶۳ (۱۹۹۷).
- [۲۹] A. Arulraj, P. N. Santhosh, R. S. Gopalan, et al., Journal of Physics-Condensed Matter ۱۰, ۸۴۹۷ (۱۹۹۸).

فصل چهارم:

تحلیل پراکندگی تشدید یافته پرتو X در لبه جذب K منگنز در



۴-۱ ترکیبات نیمه آلاییده ($x=1/2$)



۴-۳ محاسبه فاکتورهای پراکندگی و شدت پرتوهای بازتاب

۴-۴ نمودارها و نتایج بدست آمده

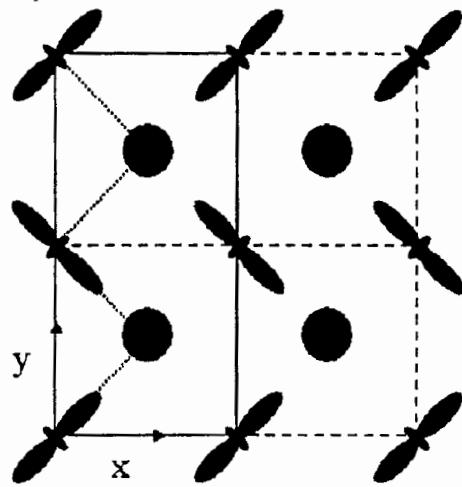
۴-۵ نتیجه گیری

مراجع

۴-۱ ترکیبات نیمه آلاسیده ($x=1/2$)

در منگنایت ها با فرمول کلی $A = Sr, Ca, Ln = La, Pr, Nd, Sm$) $Ln_{\text{.}}_A MnO_{\text{.}}_x$ (که در آنها آلاسید است میزان ۵۰٪ رسیده است یون های Mn^{3+} و Mn^{4+} به تعداد برابر وجود دارد و این می تواند منجر به تشکیل نظم بار، اوربیتال و اسپین گردد. هر چند که بروز چنین پدیده هایی فقط منحصر به این میزان آلاسید است و در ترکیبات دیگر نیز مشاهده می گردد. وقتی نسبت Mn^{3+}/Mn^{4+} برابر با یک می شود بلور از تعداد یکسان یون های فعال یان- تلر (Mn^{3+}) و یون های غیر فعال (Mn^{4+}) تشکیل می شود. این مواد به دفعات توسط فیلتران مورد مطالعه قرار گرفته اند و خواص مغناطیسی و الکتریکی بسیار جالبی از خود نشان داده اند همچون: گذار فلز- نارسانا بخاطر برهم کنش تبادل دو گانه (DE)، گذار از (به) حالت نظم بار ناشی از برهم کنش های دور برد کولنی بین حامل های بار، گذار آنتی فرومغناطیس ناشی از تبادل چندگانه^۱، که بروز هر کدام از موارد ذکر شده بستگی به ترکیب $Ln_{\text{.}}_A MnO_{\text{.}}_x$ دارد [۱]. در منگنایت های با نوار انرژی باریک مانند $La_{\text{.}}_A MnO_{\text{.}}_x$ و $Sr_{\text{.}}_A MnO_{\text{.}}_x$ فاز آنتی فرومغناطیس نوع CE در دمای پایین (شکل ۴-۲ را ببینید) پایدارتر است و نظم بار با یک طرح شطرنجی ظاهر می شود و نظم اوربیتال های $(37^{\circ}-25^{\circ})/(37^{\circ}-25^{\circ})$ نیز با این نظم بار همراه می گردد (شکل ۴-۱). در این طرح، نظم بار و اوربیتال در راستای محور٪ ساختار مشابه دارد، اما جفت شدگی اسپین های ۹۰٪ در راستای محور٪ آنتی فرومغناطیس کوئنده است [۲].

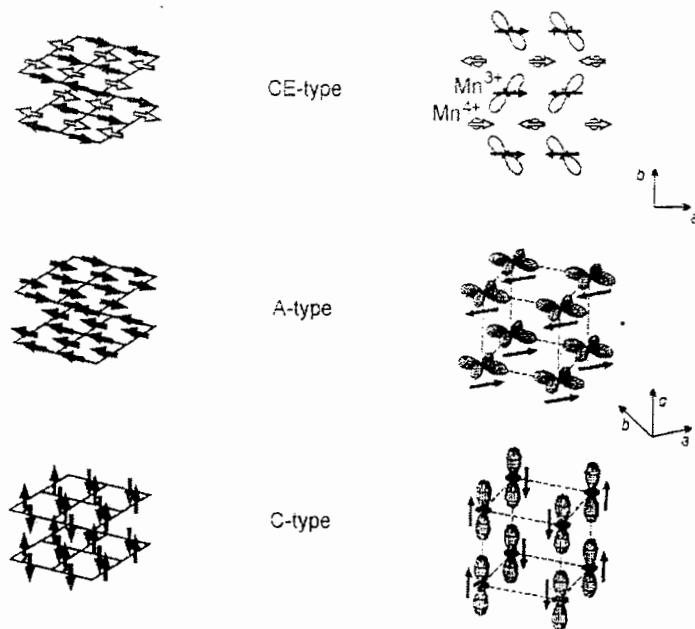
- Super Exchange
- Checker board pattern



شکل ۱-۴: طرح شماتیک نظم بارو اوربیتال نوع CE در منگنایتهای با آلایش نیمه. اوربیتالهای کشیده اوربیتالهای e_g یون Mn^{+3} و دایره ها یون Mn^{+4} هستند. طرح زیگ زاگی با نقطه چین مشخص شده است. [۲۲]

$Nd_{0.5}Cu_{0.5}MnO_3$ در تمام گستره دمایی بین $K_{CO}=250$ تا $K_{N}=160$ پایدار است [۳]. اما در این گستره دمایی، در یک محدوده خاص شکل پیک های برآگ از حالت عادی خارج می شود، که چن و چونگ^۱ این مساله را مربوط به گذار نظم بار از حالت متناسب با شبکه ^۲(C) به حالت نامتناسب با شبکه ^۳(AC) می دانند [۴]. رادالی^۴ و همکارانش در مورد چگونگی امکان تغییر پارامترهای شبکه یا حضور فازهای متفاوت با تغییر دما تحقیق کرده اند و نتیجه گرفته اند که اساسا این فازها، حوزه هایی با هشت وجهی های متفاوت از نظر اعوجاج یان-تلر هستند [۵]. نمودار مقاومت ویژه این نمونه بر حسب دما، در شکل ۳-۴ نشان داده شده است. تغییر سریع مقاومت ویژه در حوالی $250K$ ناشی از گذار فاز مرتبه اول نظم بار است. ضمن این که میدان مغناطیسی بالاتر از $7/7$ اثر کمی بر مقاومت ویژه این دارد [۶].

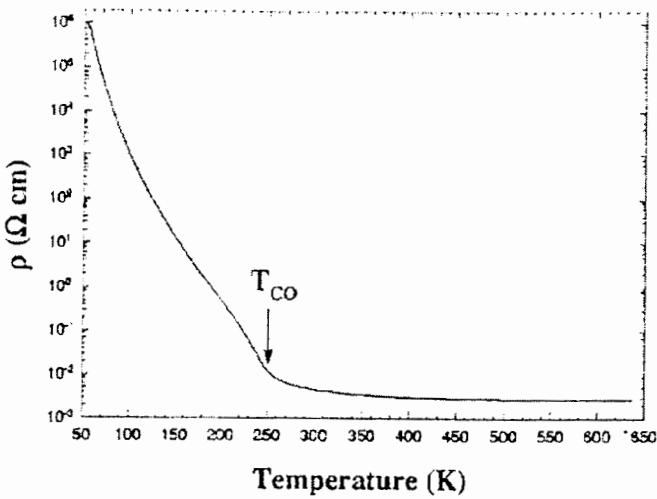
^۱ - Chen & Cheong
^۲ - Commensurate
^۳ - Incommensurate
^۴ - Radalli



شکل ۴-۲: طرح شماتیک نظام اسین (چپ) و اوربیتال (راست) در حالت‌های آنتی فرومغناطیس نوع A، CE و C [۷]

در $Pr_0.5Ca_0.5MnO_3$ یک گذار از حالت پارامغناطیس به آنتی فرومغناطیس نشان می دهد، اما هیچ نشانه ای از ویژگی های فرومغناطیس در تمام گستره غلظت Ca در آن مشاهده نشده است [۸]. آزمایشات پراش الکترونی در این نمونه نشان می دهد که در حوالی $260K$ نظم بار IC ، در حالی که ماده که پارامغناطیس است، شروع به شکل گیری می نماید و سپس در حوالی $180K$ که گذار به فاز آنتی فرومغناطیس رخ می دهد نظم بار C نیز ایجاد می گردد [۹].

$Bi_0.5Sr_0.5MnO_3$ در دمای اتاق نظم بار و اوربیتال نشان می دهد. پراکندگی نوترونی و اشعه X، بر روی این نمونه نشان می دهد که در تمام گستره دمایی بین $T = 1.5K$ تا $300K$ نظم بار و اوربیتال پایدار است. ضمن اینکه در یک محدوده دمایی، در این بازه، نظم اسپینی نیز مشاهده می شود [۱۰]. این واقعیت که میدان های مغناطیسی بزرگتر از $45/7$ نیز برای برهم زدن نظم بار در این ماده کافی نیست، نشان دهنده پایداری نظم بار در این ماده است.



شکل ۴-۳: تغییرات مقاومت ویژه بر حسب دما در $Nd_{0.5}Ca_{0.5}MnO_2$ [۶]

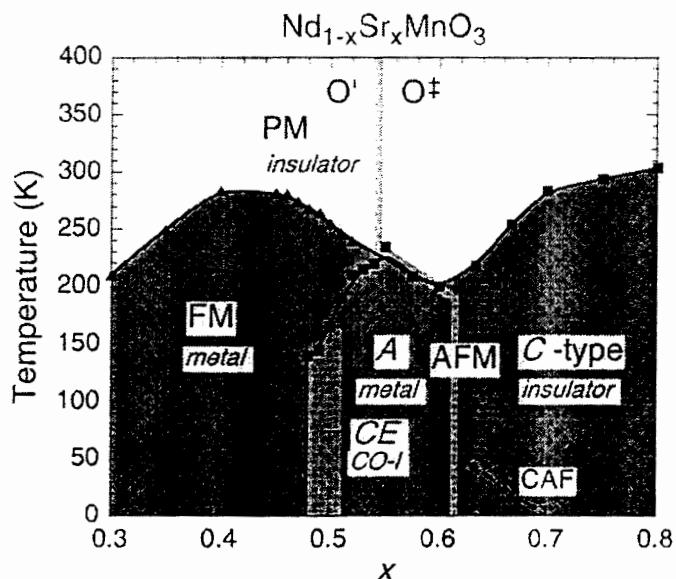
حضور تعداد مساوی بون های Mn^{+3} و Mn^{+4} الزاما منجر به نظم بار نمی شود. اندازه گیری های پراش نوترونی بر روی $Pr_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ نشان داده که این ترکیب با این غلظت، در دمای $T \sim 150K$ یک گذار از حالت فرومغناطیس به آنتی فرومغناطیس نوع A نشان می دهد (شکل ۲-۴) و هیچ نشانه ای از وجود نظم بار در آن دیده نمی شود [۱۱]. مقاومت ویژه این نمونه بر حسب تابعی از دما یک افزایش در T_N نشان می دهد، اما پس از آن تا دمای $5K$ در یک مقدار نسبتا پایینی باقی می ماند. کاوانو^۱ و همکارانش از این آزمایشات نتیجه گرفتند که عدم حضور نظم بار نوع CE در این ترکیب در مقایسه با $Nd_{0.5}Sr_{0.5}MnO_2$ به خاطر پهنه ای نوار انرژی بزرگتر است که ویژگی سیار بودن الکترون های e_g را افزایش می دهد [۱۱]. $La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_2$ در دمای $340K$ یک گذار از حالت پارامغناطیس به فرومغناطیس نشان می دهد و بعد از آن حتی تا دماهای خیلی پایین در همین حالت فرومغناطیس باقی می ماند. بنابراین این ماده از خود نظم بار نشان نمی دهد چرا که مشخصه حالت نظم بار عایق بودن است حال اندک در حالت فرومغناطیس، ماده خاصیت فلزی و رسانا دارد [۱۲].

^۱ Kawano

$Nd_{1-x}Sr_xMnO_2$ - ۴

نظم بار در این سیستم تنها به یک گستره محدود و غلظت Sr حوالی $x=1/2$ منحصر شده است. دیاگرام فازی $Nd_{1-x}Sr_xMnO_2$ بر حسب غلظت Sr در شکل ۴-۴ نشان داده شده است [۷]. این دیاگرام فازی، نشان دهنده ساختارهای مغناطیسی متفاوتی است. این ماده در دماهای بالا پارامغناطیس و عایق است و بسته به میزان غلظت x گذارهای مغناطیسی متعددی را نشان می‌دهد. در آلایش کم، نظم مغناطیسی حالت پایه سیستم، فاز فرومغناطیس است و با افزایش x به فاز نظم بار با آرایش اسپینی آنتی فرو مغناطیس (نوع CE) تبدیل می‌شود. با افزایش بیشتر Sr حالت آنتی فرومغناطیس نوع A بوجود می‌آید که خاصیت فلزی دارد و در نهایت به آنتی فرومغناطیس عایق نوع C ختم می‌شود. طرح شماتیکی از این نظم‌های اسپینی را در شکل ۲-۴ نشان داده شده است که حالت‌های آنتی فرومغناطیس ذکرشده و نظم اوربیتالی متناظر با آن را نشان می‌دهد. همان‌طور که در شکل مشاهده می‌گردد، در آنتی فرومغناطیس نوع CE ، اسپین‌یون‌های Mn^{3+} و Mn^{4+} هم در صفحه ab و هم در راستای محور c بصورت آنتی فرومغناطیس نظم یافته‌اند. نظم بار اسپین نوع CE تنها در $x=1/2$ پایدار است. در نظم نوع CE ، آنتی فرومغناطیس گونه ولی نظم اوربیتال فرومغناطیس گونه است. توزیع بار بصورت نظم نوع CE در یون‌های Mn^{3+} و Mn^{4+} تنها در صورت حضور الکترون‌های غیر جایگزیده e_g اتفاق می‌افتد. در نظم نوع A (شکل وسط) اسپین‌ها در صفحه ab بصورت فرومغناطیس، ولی در راستای محور c بصورت آنتی فرومغناطیس منظم شده‌اند. در نظم نوع C (شکل پایین) جهت گیری اسپین‌ها در راستای محور c فرومغناطیس گونه است اما اسپین‌های مجاور در صفحه ab بصورت آنتی فرومغناطیس جفت شده‌اند.

ترکیب $Nd_{1-x}Sr_xMnO_2$ در دمای $250-270^{\circ}K$ یک گذار از حالت پارامغناطیس به فرومغناطیس نشان می‌دهد. هرجند که این حالت فرومغناطیس در دماهای پایین پایدار نیست و در حوالی $160^{\circ}K$ یک گذار به حالت نارسانا مشاهده می‌شود. این حالت نارسانا یک نظم بار حاصل از زیرلایه‌های متنابض Mn^{3+} و Mn^{4+} است. این نظم بار که از نوع CE می‌باشد با نظم اسپین-اوربیتال توأم است. این گذار مرتبه اول با اعوجاجات زیاد شبکه همراه است [۱۳].



شکل ۴-۴: دیاگرام فازی $Nd_{1-x}Sr_xMnO_3$ بر حسب غلظت Sr [۷]

در دمای اتاق یک سلول واحد اتروموبیک با گروه فضایی $Imma$ دارد، که نسبت به $Nd_xSr_{1-x}MnO_3$ ساختار مکعبی پروسکایت بعلت کج کردن هشت وجهی MnO_3 حول [۱۰۱] اعوجاج یافته است. [۱۴] شکل ۴-۵-۴ یک سلول واحد این ترکیب را نشان می‌دهد. در این ساختار زاویه $Mn - O - Mn$ در صفحه ac به 180° نزدیک‌تر است تا در راستای محور a (یا همان محور بلند). این ناهمسانگردی باعث افزایش هم پوشانی اوربیتال‌های e_g یون Mn و $2p$ آنیون O و در نتیجه افزایش پهنهای نوار انرژی W می‌گردد. در این سیستم یون‌های Mn به وسیله شش یون اکسیژن احاطه شده‌اند در حالی که یون‌های Nd یا Sr در مرکز شبکه شبه مکعبی حاصل از هشت وجهی‌های MnO_3 قرار گرفته‌اند. مکان‌های Mn در شبکه به نسبت یکسان به وسیله یون‌های Mn^{3+} و Mn^{4+} اشغال شده‌اند [۱۵]. با اعمال یک میدان مغناطیسی گذار فاز نظم بار متوقف شده و ناحید فرومغناطیس به دماهای پایین تر توسعه پیدا می‌کند. با افزایش میدان به بیشتر از 77 حالت نظم بار آنتی فرومغناطیس عایق، به کلی محو شده و ترکیب به فرومغناطیس تبدیل می‌شود [۱۶]. در $Nd_xSr_{1-x}MnO_3$ بر 77 منطبق است و دلالت بر این

موضوع دارد که هم برهم کنش های کولنی (که برای ایجاد نظم بار ضروری هستند) و هم تبادل چندگانه (که باعث ایجاد خاصیت آنتی فرومغناطیس می گردد) برای شکل گیری و پایداری حالت آنتی فرومغناطیس نوع CE ضروری هستند [۱۳]. معمولاً حالت CE ، حالت زمینه این ترکیب و دیگر منگایت های پروسکایت با آلایش نیمه می باشد. در اندازه گیری های مقاومت ویژه و مغناطیدگی، به هنگام گذار نظم بار، نا بهنجاری هایی دیده شده است. شکل ۶-۴ که بستگی دمایی مغناطیدگی، پارامترهای شبکه و مقاومت ویژه را نشان می دهد، این واقعیت را بخوبی در دمای گذار نظم بار نمایان ساخته است.

منحنی بالایی شکل که مربوط به مغناطیدگی است، در $250K$ به دلیل گذار از حالت پارامغناطیس به فرومغناطیس شروع به افزایش می کند و سپس در حوالی $160K$ ناگهان کاهش می یابد. حالت فرومغناطیس بطور کامل از بین رفته و تمام ماده را حالت آنتی فرومغناطیس تسخیر می نماید. پارامترهای شبکه (منحنی وسط) نیز در این دما به دلیل گذار فاز مرتبه اول به حالت نظم بار تغییر چشم گیری می کنند. مقاومت ویژه جسم (منحنی پایین) در T_C بعلت کاهش پراکندگی مغناطیسی حامل های بار در فاز فرومغناطیس، که اسپین ها نظم گرفته اند، کاهش نشان می دهد. اما در T_{CO} که این ترکیب شروع به گذار از حالت فرومغناطیس فلزی به آنتی فرومغناطیس عایق می نماید، مقاومت ویژه در حدود 10^7 برابر افزایش می یابد.

بین حالت های آنتی فرومغناطیس نوع A و نوع CE (که در نسبت $Mn^{3+}/Mn^{4+} = 1$ پایدار و نظم بار دیده می شود) یک رقابت وجود دارد. نتایج آزمایشات نشان می دهد که در $Nd_{0.5}Sr_{0.5}MnO_3$ در دمای پایین، همزیستی دو فاز و یا بیشتر وجود دارد. مثلاً یوشیزاوا^۱ و همکارانش با مشاهده پیک های مغناطیسی خیلی ضعیف برآگ در کمتر از $200K$ ، همزیستی حالت های فرومغناطیس و آنتی فرومغناطیس نوع A را نتیجه گرفتند [۱۷]. اما وودوارد^۲ و همکارانش با استفاده از تکنیک پراکندگی نوترونی نتیجه گرفتند که: 25% فاز فرمغناطیس در گستره دمایی $160-220K$ به فاز آنتی

^۱ - Yoshizawa
^۲ - Woodward

فرومغناطیس نوع *A* تبدیل می شود. سپس بیشتر فاز فرمغناطیس باقی مانده، در دمای $150K$ تا $100K$ به فاز آنتی فرمغناطیس نوع *CE* تبدیل می شود، اما در دمای $15K$ هنوز 15% فاز فرمغناطیس باقی ماند [۱۸]

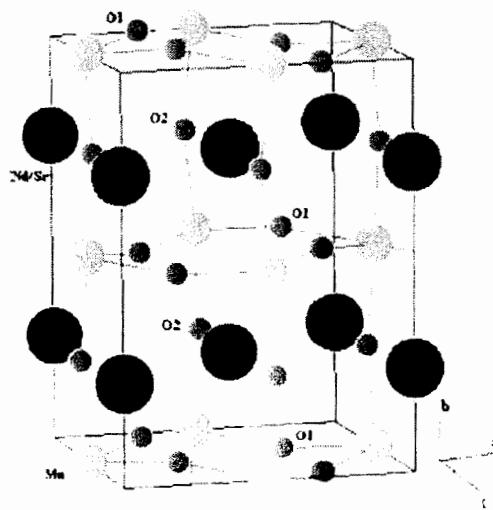
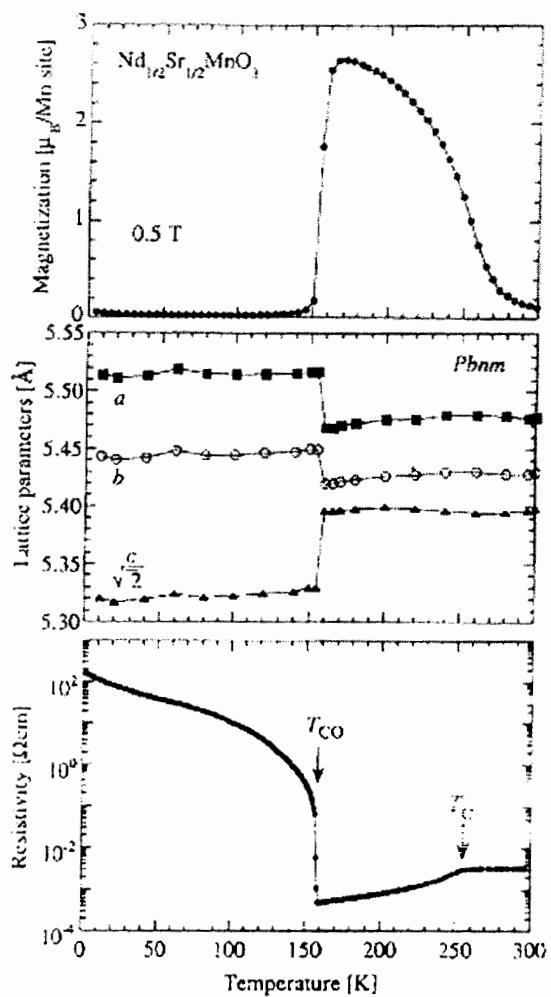


TABLE I. Lattice parameters and list of derived atomic positions and equivalent isotropic displacement parameters of the $Nd_{2.5}Sr_{3.5}MnO_7$ single crystal.

Lattice parameters:				
	$a = 5.420(3) \text{ \AA}$	$b = 7.666(7) \text{ \AA}$	$c = 5.453(10) \text{ \AA}$	
Atoms	x	y	z	$U(\text{eq})$
Nd	0	0.25	0.0039(3)	0.021(2)
Sr	0	0.25	0.0039(3)	0.021(2)
Mn	0	0	0.5	0.018(3)
O(1)	0	0.25	0.524(5)	0.044(7)
O(2)	0.25	0.0229(18)	0.75	0.037(5)

شکل ۴-۵: ساختار $Nd_{2.5}Sr_{3.5}MnO_7$ به همراه جدولی از پارامترهای شبکه [۲۳]



شکل ۴-۶: منحنی تغییرات مغناطیسی، پارامترهای شبکه و مقاومت ویژه بر حسب دما در $Nd_{1/2}Sr_{1/2}MnO_3$ [۱۳]

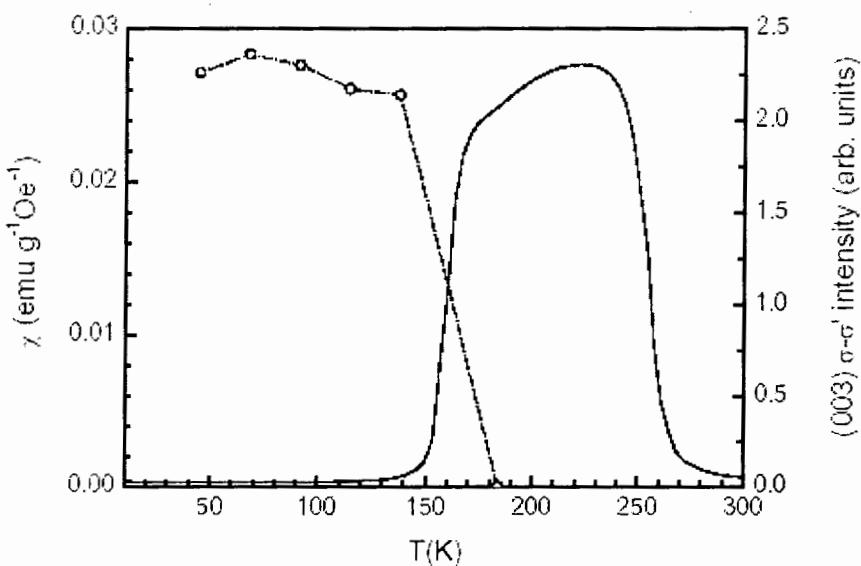
بنابراین مطالعات $Nd_{1/2}Sr_{1/2}MnO_3$ در دمای پایین به سه فاز ماکروسکوپیک جداگانه تقسیم می‌گردد: فاز دمای بالا، فرومغناطیسی فلزی^۱ (FMM) با ساختار $Imma$ ، فاز آنتی فرومغناطیس نوع A با نظم اوربیتال و ساختار $Imma$ و فاز آنتی فرومغناطیس نوع C با نظم بار، اوربیتال و ساختار $P\bar{2}1/m$. مشاهدات بعمل امده توسط میکروسکوب الکترونی بر روی این ماده وجود نظم بار IC را در فاز FMM

^۱ - Ferro Magnetic Metal

نشان می دهد. فوکوموتو^۱ و همکارانش از این نتایج آمیختگی حوزه های خیلی کوچک^۲ نظم بار را در فاز فرومغناطیس نتیجه گیری کردند [۱۹].

همانطور که قبلاً گفته شد، اعمال یک میدان مغناطیسی می تواند نظم بار را از بین ببرد. کواهارا^۳ و همکارانش برای اولین بار با اعمال میدان مغناطیسی کاهش چندین مرتبه ای را در مقاومت ویژه مشاهده کردند [۱۳]. آنها این مشاهدات را بعنوان انحلال نظم بار تحت اعمال میدان تعییر کردند. نتایج این اندازه گیری ها، تغییرات مقاومت ویژه بر حسب میدان مغناطیسی اعمال شده، در دماهای متفاوت را در شکل ۱۱-۳ مشاهده می کنید. این شکل، انحلال نظم بار در میدان را به وضوح نشان می دهد. از نظر تجربی ثابت شده است که جایگذاری O^{18} بدای O^{16} می تواند باعث افزایش دمای گذار نظم بار شود و در MnO_4^- و Sr^{2+} این افزایش در دمای گذار نظم بار در حدود ۲۱۸°C است [۲۰]. مطالعات اخیر انجام گرفته توسط پرتو X سینکروترونی، حضور یک ناهمسانگردی کوتاه برد به همراه اعوجاج ساختاری را در فاز پارامغناطیس عایق و فرومغناطیس فلزی نشان می دهد [۲۱]. چنین استدلال می شود که همبستگی های مشاهده شده نشان دهنده حضور لایه های نظم اوربیتالی موضعی در فازهای پارامغناطیس و فرومغناطیس می باشد. این مطالعات نشان می دهد که حالت پایه منگنایت ها بخارتر تمایل به جداسازی فازها، تقریباً ناهمگن است، شامل فرومغناطیس رسانا، حوزه های آنتی فرومغناطیس نارسانای نظم بار، اوربیتال، که باید در کارهای تئوری برای توصیف منگنایتها پروسکایت مورد ملاحظه قرار گیرد. شکل ۷-۴ وابستگی دمایی شدت بازتاب پیک /۰۰۳۰ که ناشی از نظم بار می باشد، را نشان می دهد. به وضوح مشخص است که در دمای بالاتر از ۱۵۰°C به دلیل از بین رفتن این نظم بار، شدت صفر می شود.

^۱- Fukumoto
^۲- mirodomain
^۳- Kuwahara



شکل ۷-۴: شدت بازتاب پیک نظم بار (۳۰۰) بر حسب دما در $Nd_{x}Sr_{1-x}MnO_3$ [۲۲]

۴-۳ محاسبه فاکتور سی پراکنده و شدت پرتوهای بازتاب

ابتدا به محاسبه فاکتور ساختار برای $Nd_xSr_{1-x}MnO_3$ می پردازیم. با استفاده از رابطه ۱-۲۹ این فاکتور را برای بازتابهای (h, k, l) و $(0, 0, 0)$ که بازتابهای ناشی از نظم بار هستند (h و k فرد هستند) و هم چنین بازتاب $(0, k/2, l/2)$ که ناشی از نظم اوربیتال است محاسبه می کنیم. با توجه به اینکه نتایج تجربی شدت بازتابهای $(0, 0, 0)$ و $(0, 3/2, 0)$ برای نظم بار و $(0, 5/2, 0)$ برای نظم اوربیتال را در اختیار داریم، ما نیز مبنای از همین ابتدا برای محاسبه همین بازتابها می گذاریم. سلول واحد مدل در نظر گرفته شده در شکل ۴-۴ دارای ابعاد $c \times b \times a = 26 \times 26 \times 10$ فضایی^۱ ثابت های شبکه می باشند. هشت اتم Mn در این سلول واحد سهیم می باشند، اما از آنجا که در راستای محور c اتمهای Mn هم ارز هستند، ما می توانیم بطور موثر بد جهار اتم اکتفا کنیم (که در شکل با شماره های ۱ تا ۴ شماره گذاری شده اند). لذا مکان اتم های Mn بد صورت زیر است:

^۱ space group

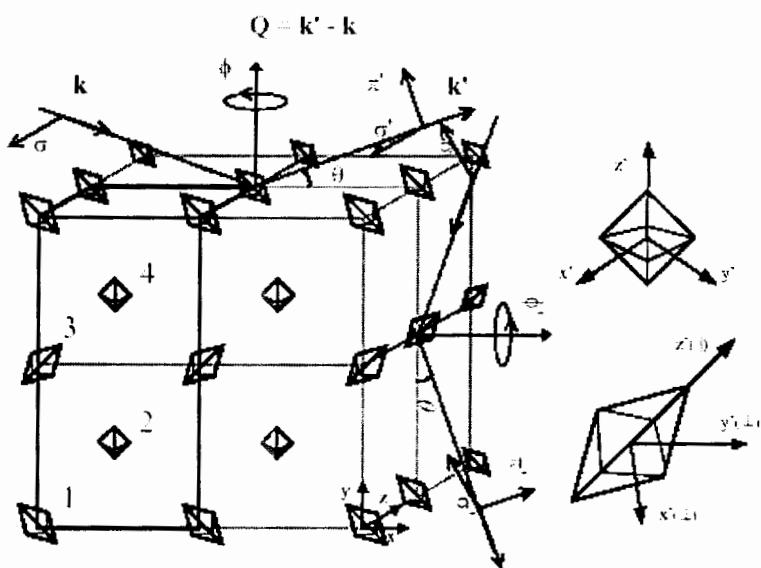
Mn⁺: (.....)

Mn²⁺: (1/2, 1/2, 1/2)

(1-۴)

Mn³⁺: (.., 1, ..)

Mn⁴⁺: (1/2, 3/2, 1/2)



شکل ۴: سلول واحد طرح شماتیک پراکندگی پرتو X اتمهای فرد Mn^{3+} و اتمهای زوج Mn^{4+} به همراه $Nd_2Sr_3MnO_7$ هستند. [۲۲]

پس فاکتور ساختار برای بازتاب های ذکر شده به شرح زیر می باشد:

$$F_{hkl} = \sum_{\lambda}^N f_{\lambda} e^{2\pi i(hu_n + kv_n + lv_n)}$$

$$\begin{aligned} F_{(0,k,0)} &= f_j \exp(\theta) + f_2 \exp(-2\pi i \frac{k}{2}) + f_3 \exp(2\pi i k) + f_4 \exp(2\pi i \frac{3k}{2}) \\ &= f_j [\lambda] + f_2 [-\lambda] + f_3 [\lambda] + f_4 [-\lambda] = f_j - f_2 + f_3 - f_4 \end{aligned} \quad (2-۴)$$

$$\begin{aligned} F_{(h,0,0)} &= f_j \exp(\theta) + f_2 \exp(-2\pi i \frac{h}{2}) + f_3 \exp(\theta) + f_4 \exp(2\pi i \frac{h}{2}) \\ &= f_j [\lambda] + f_2 [-\lambda] + f_3 [\lambda] + f_4 [-\lambda] = f_j - f_2 + f_3 - f_4 \end{aligned} \quad (3-۴)$$

$$F_{(0,k/2,0)} = f_1 \exp(0) + f_2 \exp(2\pi i \frac{k}{4}) + f_3 \exp(2\pi i \frac{k}{2}) + f_4 \exp(2\pi i \frac{3k}{4}) \quad (4-4)$$

$$= f_1[1] + f_2[i] + f_3[-1] + f_4[-i] = f_1 - f_3 + i(f_2 - f_4)$$

البته ذکر این مطلب ضروری است که سهم مربوط به پراکندگی تامسون کنار گذاشته و در نظر گرفته نشده است. در اینجا چون وابستگی شدت به انرژی فوتون فرودی (تشدید بررسی می گردد و پراکندگی تامسون مستقل از انرژی فوتون فرودی می باشد پس تنها اثر آن یک مقدار ثابت در شدت می باشد. هر ها فاکتور پراکندگی غیرعادی مربوط به امین اتم منگنز است. فاکتور پراکندگی غیرعادی برای هر اتم بصورت یک ماتریس است. در اینجا اتم های ۲ و ۴ که Mn^{4+} می باشند اتم های متقارنی (یا همسانگرد) هستند چون فاقد الکترون e_g می باشند و تنها دارای سه الکترون در تراز $3d_{t_{2g}}$ هستند، اما اتم های ۱ و ۳ که Mn^{3+} هستند (بعثت اعوجاج یان تلر) اتم های نا همسانگرد می باشند. فاکتور پراکندگی غیرعادی را برای اتم های زوج می توان به فرم یک ماتریس قطری با سه مولفه یکسان در نظر گرفت در صورتی که برای اتم های فرد این ماتریس در دستگاه $\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}$ ماتریس قطری با مولفه های، \hat{f}_1 : فاکتور پراکندگی جهت ناهمسانگردی و \hat{f}_2 : فاکتور پراکندگی عمود بر راستای ناهمسانگردی می باشد. یعنی در دستگاه متصل به هر هشت وجهی:

$$f_2 = f_4 = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} \quad f_1 = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 \\ 0 & f_1 & 0 \\ 0 & 0 & f_{11} \end{bmatrix} \quad f_3 = \begin{bmatrix} f_1 & 0 & 0 \\ 0 & f_1 & 0 \\ 0 & 0 & f_{11} \end{bmatrix} \quad (5-4)$$

در این مدل فرض شده است که راستای ناهمسانگردی با محورهای x, y, z بلور، زاویه 45° می سازد. پس ماتریس های فوق را می توانیم با استفاده از ماتریس های دوران در دستگاه متصل به سلول واحد x, y, z به فرم زیر بنویسیم:

$$f_1 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} f_1 + f_{II} & f_1 - f_{II} & 0 \\ f_1 - f_{II} & f_1 + f_{II} & 0 \\ 0 & 0 & 2f_1 \end{bmatrix} \quad f_3 = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} f_1 + f_{II} & f_{II} - f_1 & 0 \\ f_{II} - f_1 & f_1 + f_{II} & 0 \\ 0 & 0 & 2f_1 \end{bmatrix}$$

$$f_2 = f_4 = \begin{bmatrix} f & 0 & 0 \\ 0 & f & 0 \\ 0 & 0 & f \end{bmatrix} \quad (6-4)$$

با جایگذاری این تانسورها در معادلات (۲ - ۴) تا (۶ - ۴) فاكتورهای ساختار چنین به دست می آیند:

$$F(h,0,0) = F(0,k,0) = \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix} \quad (7-4)$$

$$F(0,\frac{k}{2},0) = \begin{bmatrix} 0 & f_{\perp} - f_{II} & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

شدت پراکندگی پرتو X تشدید یافته از این رابطه زیر بدست می آید [۲۳] :

$$\Lambda(\varphi, \varphi_A) = \sum_{\lambda_i} \left| \sum_{\lambda_f} M_{\lambda_i \lambda_f}(\varphi_A) \cdot A_{\lambda_i \lambda_f}(\varphi) \right|^2 \quad (8-4)$$

که در آن λ_i و λ_f نشان دهنده پلاریزاسیون پرتو X، فرودی و پراکنده شده هستند. $M(\varphi_A)$ ماتریس پراکندگی آنالیزور و A به صورت زیر می باشند [۲۳] :

$$M(\varphi_A) = F_A \begin{pmatrix} \cos \varphi_A & -\sin \varphi_A \\ \sin \varphi_A \cos \vartheta_A & \cos \varphi_A \cos \vartheta_A \end{pmatrix} \quad (9-4)$$

$$A_{\lambda_i \lambda_f}(\varphi) = \frac{e^2}{mc^2} \bar{e}_{k_f \lambda_f} \left[U(\varphi) V F V^+ U^+(\varphi) \right] \bar{e}^+_{k_i \lambda_i} \quad (10-4)$$

در روابط فوق هر یک از کمیت ها بدين صورت تعريف می شوند :

F : فاكتور پراکندگی ساختار مربوط به کریستال آنالیزور

V : فاكتور پراکندگی ساختار مربوط به بلور در مختصات متصل به بلور (x,y,z)

θ : زاویه پراکندگی آنالیزور که مقدار آن 90° گرفته می شود.

φ : زاویه سمتی آنالیزور که برای پراکندگی 0 صفر درجه و برای پراکندگی π نود درجه می باشد.

\mathcal{U} : ماتریس تبدیل دستگاه مختصات متصل به بلور^۱ (تحلیخ) به دستگاه مختصات آزمایشگاهی^۲

یعنی $(\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3)$

θ : زاویه پراکندگی بازتاب مورد نظر از بلور مورد آزمایش.

\mathcal{U} : ماتریس چرخش بلور حول بردار یکه پراکندگی (یعنی زاویه سمتی). با توجه به شکل ۹-۴ و انتخاب

راستای محور زرها در راستای بردار پراکندگی $(\vec{q} - \vec{k}_r)$, می‌توان \mathcal{U} را بدین صورت نوشت:

$$\mathcal{U}(\varphi) = \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \quad (11-4)$$

\vec{e}_{k_r} و \vec{e}_{k_s} : به ترتیب بردارهای قطبیدگی پرتوهای \mathcal{K} فرودی و پراکنده هستند که با توجه به شکل

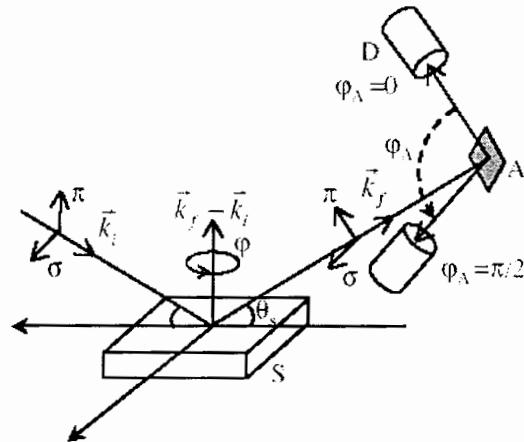
۹-۴ برای قطبیدگی‌های σ و π پرتوهای فرودی و پراکنده عبارتند از:

بردارهای یکه پرتو فرودی	بردارهای یکه پرتو پراکنده
<i>Incident x-ray</i>	<i>Scattered x-ray</i>
$\vec{e}_{k,\sigma} = (1 \ 0 \ 0)$	$\vec{e}_{k,\sigma} = (\gamma \ 0 \ 0)$
$\vec{e}_{k,\pi} = (\sin\theta_s \ \cos\theta_s \ 0)$	$\vec{e}_{k,\pi} = (-\sin\theta_s \ \cos\theta_s \ 0)$

جدول (۱۱-۴): بردارهای قطبیدگی پرتوهای \mathcal{K} فرودی و پراکنده در دستگاه مختصات آزمایشگاهی

حال به محاسبه روابط شدت پرتوهای پراکنده برای هریک از بازتاب‌های بار (۰,۰,۰), (۰,۰,۱), (۰,۱,۰) و (۱,۰,۰) اوربیتال اوربیتال $k/200$ می‌پردازیم.

- crystallographic axis
- laboratory system



شکل ۴-۴: طرح شماتیک آزمایش پراکندگی پرتو \mathcal{K} ، بلور مورد آزمایش S - بلور آنالیزور A - آشکار ساز D و \vec{k}_f و \vec{k}_i
پرتوهای \mathcal{K} فرودی و پراکنده شده هستند [۲۳]

۱-۳-۴ محاسبه شدت پراکندگی ازپیک نظم بار $(0, k, 0)$ در کانال $\sigma - \sigma$:

با استفاده از روابط ۷-۴ تا ۱۰-۴ برای پیک $(0, k, 0)$ داریم:

$$\vec{e}_{k_f\sigma} = (1 \ 0 \ 0), \vec{e}_{k_f\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, F(0, k, 0) = \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix}$$

$$A_{\sigma\sigma(\varphi)} = \frac{e^2}{mc^2} (0 \ 0 \ \lambda) \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (0 \ 0 \ \lambda) \begin{bmatrix} \cos\varphi(f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & -\sin\varphi(2f_{\perp} - 2f) \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ \sin\varphi(f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & \cos\varphi(2f_{\perp} - 2f) \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (\sin\varphi(f_{\perp} + f_{II} - 2f) - \theta \cos\varphi(2f_{\perp} - 2f)) \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{e^2}{mc^2} [\sin^2 \varphi (f_{\perp} + f_{II} - 2f) + \cos^2 \varphi (2f_{\perp} - 2f)] \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P_{(0k0)}^{\sigma\sigma} = \left[F_A \frac{e^2}{mc^2} \right]^2 [(f_{\perp} + f_{II} - 2f) \sin^2 \varphi + 2(f_{\perp} - f) \cos^2 \varphi] \quad (12-4)$$

۲-۳-۴ محاسبه شدت پراکندگی از پیک نظم بار (σ, k, θ) در کانال π :

بطور مشابه برای کانال π ، با جایگذاری مقادیر متناظر نتیجه می شود:

$$\vec{e}_{k,\pi} = (-\sin \theta \quad \cos \theta \quad 0) \quad \vec{e}_{k,\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$F(\theta, k, \theta) = \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix}$$

$$A_{\sigma\pi(\varphi)} = \frac{e^2}{mc^2} (-\sin \theta \quad \cos \theta \quad 0) \begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & -\sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos \varphi & 0 & \sin \varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin \varphi & 0 & \cos \varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (-\sin \theta \quad \cos \theta \quad 0) \begin{pmatrix} \cos \varphi (f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & -\sin \varphi (2f_{\perp} - 2f) \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ \sin \varphi (f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & \cos \varphi (2f_{\perp} - 2f) \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sin \varphi \\ 0 \\ \cos \varphi \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (-\sin \theta \cos \varphi (f_{\perp} + f_{II} - 2f) \quad \cos \theta (f_{\perp} + f_{II} - 2f) \quad \sin \varphi \sin \theta (2f_{\perp} - 2f)) \begin{pmatrix} \sin \varphi \\ 0 \\ \cos \varphi \end{pmatrix} =$$

$$= \frac{e^2}{mc^2} [-\sin \theta \sin \varphi \cos \varphi (f_{\perp} + f_{II} - 2f) + \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi (2f_{\perp} - 2f)]$$

$$A = \frac{e^2}{mc^2} (f_{\perp} - f_{II}) \sin \theta \sin \varphi \cos \varphi \quad M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P_{(0k0)}^{\sigma\pi} = \left[F_A \frac{e^2}{mc^2} \right]^2 [f_L - f_H \sin\varphi \cos\varphi \sin\theta]^2 \quad (13-4)$$

۳-۳-۴ محاسبه شدت پراکندگی از یک نظم بار (h, \dots) در کانال σ - σ :

$$\begin{aligned} \vec{e}_{k,\sigma} &= (1 \ 0 \ 0), \vec{e}_{k,\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, F(h,0,0) = \begin{bmatrix} f_L + f_H - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_L + f_H - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_L - 2f \end{bmatrix} \\ A_{\sigma\sigma(\varphi)} &= \frac{e^2}{mc^2} (0 \ 0 \ \lambda) \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_L + f_H - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_L + f_H - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_L - 2f \end{bmatrix} \\ &\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (0 \ 0 \ \lambda) \begin{bmatrix} \cos\varphi(f_L + f_H - 2f) & 0 & -\sin\varphi(2f_L - 2f) \\ 0 & f_L + f_H - 2f & 0 \\ \sin\varphi(f_L + f_H - 2f) & 0 & \cos\varphi(2f_L - 2f) \end{bmatrix} \\ &\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (\sin\varphi(f_L + f_H - 2f) \ 0 \ \cos\varphi(2f_L - 2f)) \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix} = \\ &= \frac{e^2}{mc^2} [\sin^2\varphi(f_L + f_H - 2f) + \cos^2\varphi(2f_L - 2f)] \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$P_{(h00)}^{\sigma\sigma} = \left[F_A \frac{e^2}{mc^2} \right]^2 [(f_L + f_H - 2f) \sin^2\varphi + 2(f_L - f) \cos^2\varphi]^2 \quad (14-4)$$

۴-۳-۴ محاسبه شدت پراکندگی از یک نظم بار (h, \dots) در کانال π - π :

$$\vec{e}_{k,\pi} = (-\sin\theta \ \cos\theta \ 0), \vec{e}_{k,\pi}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned}
F(h, \theta, 0) &= \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix} \\
A_{\sigma\pi(\varphi)} &= \frac{e^2}{mc^2} (-\sin\theta \cos\theta \ 0) \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 & 0 \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ 0 & 0 & 2f_{\perp} - 2f \end{bmatrix} \\
\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{e^2}{mc^2} (-\sin\theta \cos\theta \ 0) \begin{bmatrix} \cos\varphi(f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & -\sin\varphi(2f_{\perp} - 2f) \\ 0 & f_{\perp} + f_{II} - 2f & 0 \\ \sin\varphi(f_{\perp} + f_{II} - 2f) & 0 & \cos\varphi(2f_{\perp} - 2f) \end{bmatrix} \\
\begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix} &= \frac{e^2}{mc^2} (-\sin\theta \cos\theta / (f_{\perp} + f_{II} - 2f) \ \cos\theta / (f_{\perp} + f_{II} - 2f) \ \sin\varphi \sin\theta / (2f_{\perp} - 2f)) \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix} = \\
&= \frac{e^2}{mc^2} [-\sin\theta \sin\varphi \cos\varphi / (f_{\perp} + f_{II} - 2f) + \sin\theta \sin\varphi \cos\varphi / (2f_{\perp} - 2f)] \\
A_{\sigma\pi(\varphi)} &= \frac{e^2}{mc^2} (f_{\perp} - f_{II}) \sin\theta \sin\varphi \cos\varphi \quad M = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \\
F_{(h00)}^{\sigma\pi} &= \left[F_A \frac{e^2}{mc^2} \right]^2 [(f_{\perp} - f_{II}) \sin\varphi \cos\varphi \sin\theta]^2 \quad (15-4)
\end{aligned}$$

: $\sigma - \sigma$ ۵-۳-۴ محاسبه شدت پراکندگی از پیک نظم اوربیتال ($0, k/2, 0$) در کانال

$$\begin{aligned}
\vec{e}_{k/\sigma} &= (1 \ 0 \ 0) \quad \vec{e}_{k/\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad F(0, k/2, 0) = \begin{bmatrix} 0 & f_{\perp} - f_{II} & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
A_{(\theta, k/2, 0)}^{\sigma\sigma} &= \frac{e^2}{mc^2} (\theta \ 0 \ 0) \begin{bmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & f_{\perp} - f_{II} & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\
\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} &= \frac{e^2}{mc^2} (\theta \ 0 \ 0) \begin{bmatrix} 0 & \cos\varphi(f_{\perp} - f_{II}) & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & \sin\varphi(f_{\perp} - f_{II}) & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

$$A_{(0,k/2,0)}^{\sigma\sigma} = 0 \quad M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\Rightarrow I_{(0,k/2,0)}^{\sigma\sigma} = 0 \quad (16-4)$$

: $\sigma - \pi$ محاسبه شدت پراکندگی ازپیک نظم اوربیتال ($0,k/2,0$) در کانال

$$\vec{e}_{k/\pi} = (-\sin\theta \quad \cos\theta \quad 0) \quad \vec{e}_{k,\sigma}^+ = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad F(0,k/2,0) = \begin{bmatrix} 0 & f_{\perp} - f_{II} & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$A_{(0,k/2,0)}^{\sigma\pi} = \frac{e^2}{mc^2} (-\sin\theta \quad \cos\theta \quad 0) \begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & -\sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{bmatrix} 0 & f_{\perp} - f_{II} & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \cos\varphi & 0 & \sin\varphi \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\varphi & 0 & \cos\varphi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (-\sin\theta \quad \cos\theta \quad 0) \begin{bmatrix} 0 & \cos\varphi(f_{\perp} - f_{II}) & 0 \\ f_{\perp} - f_{II} & 0 & 0 \\ 0 & \sin\varphi(f_{\perp} - f_{II}) & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix} = \frac{e^2}{mc^2} (\cos\theta(f_{\perp} - f_{II}) - \sin\theta\cos\varphi(f_{\perp} - f_{II})) \begin{pmatrix} \sin\varphi \\ 0 \\ \cos\varphi \end{pmatrix}$$

$$A_{(0,k/2,0)}^{\sigma\pi} = \frac{e^2}{mc^2} [\sin\varphi\cos\theta(f_{\perp} - f_{II})] \quad M = \begin{pmatrix} 0 & -I \\ I & 0 \end{pmatrix}$$

$$I_{(0,k/2,0)}^{\sigma\pi} = \left[F_A \frac{e^2}{mc^2} \right]^2 \left[\sin^2\varphi \cos^2\theta(f_{\perp} - f_{II})^2 \right] \quad (17-4)$$

۴-۴ نمودارها و نتایج بدست آمده

تشدید اصلی در شدت ها در لبد جذب K اتم Mn اتفاق می افتد. مقدار ابرژی لبه جذب به دو عامل حساس است: یکی به حالت طرفیت اتم، و دیگری به شرایط محیط اطراف اتم (همسانگرد یا نا

همسانگرد)، برای قطبیدگی های متفاوت. عامل اول (تفاوت مقدار انرژی لبه جذب در ظرفیت های متفاوت اتم) بنام جابجایی شیمیایی^۱ خوانده می شود، که با آزمایشات جذب پرتو X بر روی نمونه های پودری (از طریق اندازه گیری میانگین ضریب جذب $f_{(E)} \mu$ در هر حالت) تعیین می گردد. در مورد دوم، موقعیت انرژی لبه جذب، (شناخته شده بنام جابجایی نا همسانگردی^۲، به زاویه بین بردار قطبیدگی پرتو X و جهت محور نا همسانگردی اتم بستگی دارد. محاسبات انجام شده توسط مارتین^۳ و همکارانش مقدار $V eV$ و $\delta_{anis} = 1.6$ و $\delta_{chem} = 0.7$ را به ترتیب برای جابجایی شیمیایی و نا همسانگردی در این نمونه نشان می دهد [۲۲]. روابط بین مولفه های تانسور پراکندگی غیر عادی به فرم زیر در نظر گرفته شده است :

$$\begin{aligned} f(E) &= f_{anis}(E + \delta_{chem}) \\ f_{\perp}(E) &= f_{//}(E + \delta_{anis}) \\ f_{anis} &= \frac{1}{3}(f_{//} + 2f_{\perp}) \end{aligned} \quad (18-4)$$

که $f(E)$ فاکتور پراکندگی یون Mn^{4+} است و f_{\perp} و $f_{//}$ به ترتیب مولفه های موازی و عمود تانسور پراکندگی یون Mn^{4+} می باشد. برای محاسبه روابط فوق از داده های تجربی بخش حقیقی "کرو موہومی" فاکتور پراکندگی برحسب انرژی، اندازه گیری شده بر روی نمونه $LaMnO_4$ و $CaMnO_4$ (ضمیمه ب) استفاده شده است [۲۵]. لازم به ذکر است که در نمونه اول یون های Mn^{4+} به فرم Mn^{4+} و در نمونه دوم به فرم Mn^{4+} می باشد. در این مدل فرض شده است که f_{\perp} برابر با $f_{//}$ اندازه گیری شده بر روی نمونه $LaMnO_4$ باشد که در آن منگنزها به فرم Mn^{4+} می باشند. f_{anis} به فرم میانگین از f_{\perp} و $f_{//}$ انتخاب شده است.

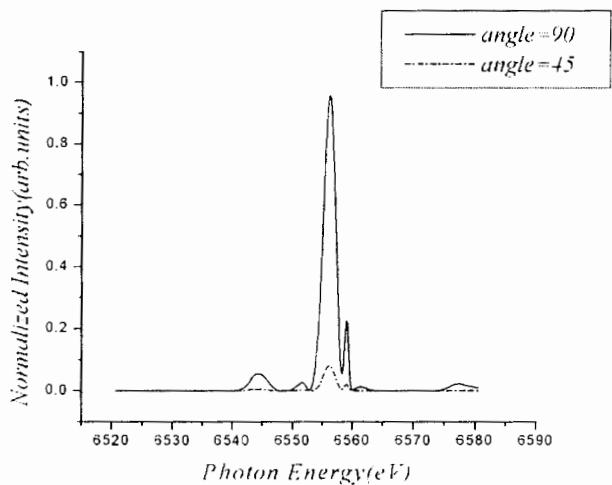
برای این منظور یک برنامه کامپیوتری با استفاده از نرم افزار *matlab* (پیوست الف) نوشته شده که با استفاده از روابط اخیر و نیز معادلات بخش ۳-۴ و مدل ذکر شده، شدت پراکندگی را برای پیک های ناشی از نظم بار و اوربیتال بر حسب انرژی محاسبه می نماید. در ادامه نتایج بدست امده ذکر می گردد.

- chemical shift

- anisotropic shift

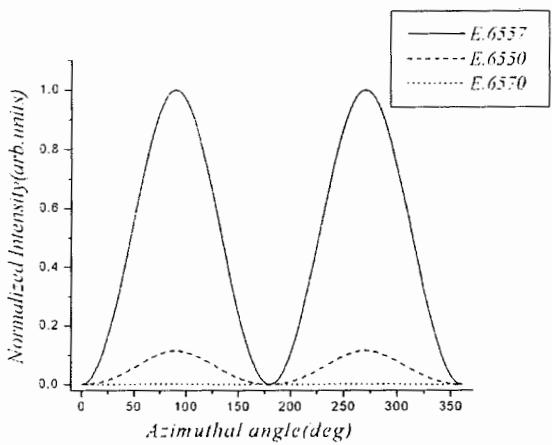
- Martin

شکل ۱۰-۴ شدت پراکندگی (نرمالیزه شده) ناشی از یک نظم بار (σ) در کانال $\sigma - \sigma$ بر حسب تغییر انرژی فوتون فرودی نشان می دهد که با استفاده از معادلات ۱۴-۴ و ۱۸-۴ بدست آمده است. شکل بر حسب دو زاویه سمتی متفاوت ϕ رسم گردیده است. تشدید در انرژی 6557 eV اتفاق می افتد که متناظر با لبه جذب K اتم منگنز می باشد. لازم به ذکر است که شدت بازتاب برآگ که ناشی از پراکندگی فوتون ها از بار می باشد مستقل از انرژی می باشد.



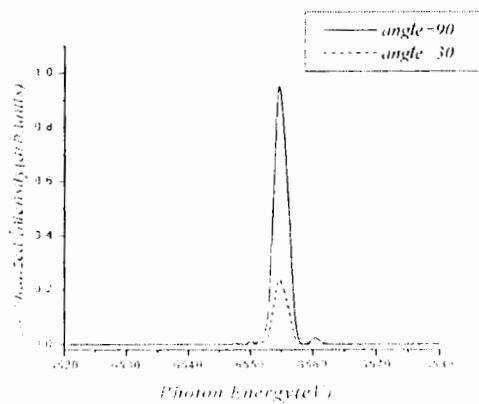
شکل ۱۰-۴: شدت پراکندگی بازتاب $\sigma - \sigma$ در کانال $\sigma - \sigma$ ناشی از نظم بار بر حسب انرژی پرتو X فرودی. خط ممتد به ازای زاویه سمتی $\phi = 90^\circ$ و خط چین به ازای زاویه سمتی $\phi = 45^\circ$ می باشد.

در شکل ۱۱-۴ بستگی شدت این یک بر حسب زاویه سمتی را نشان می دهد. همان طور که شکل نشان می دهد بستگی آن به زاویه سمتی دارای پریود حدود 360° می باشد که ناشی از شکل متقارن اوربیتال $c_{\sigma\sigma}$ منگنز می باشد. این شکل نیز به ازای انرژی های متفاوت رسم شده است. همان طور که ملاحظه می کردد وقتی از انرژی تشدید دور می شویم، شدت کاهش می یابد. تا این که در انرژی 6570 eV کد دور از لبه جذب می باشد تنت تقریباً ثابت و صفر می شود. لازم به ذکر است که شدت پراکندگی ناشی از نظم بار در کانال چرخیده $\pi - \sigma$ در مقابل $\sigma - \sigma$ خیلی کوچک و تقریباً صفر می باشد.



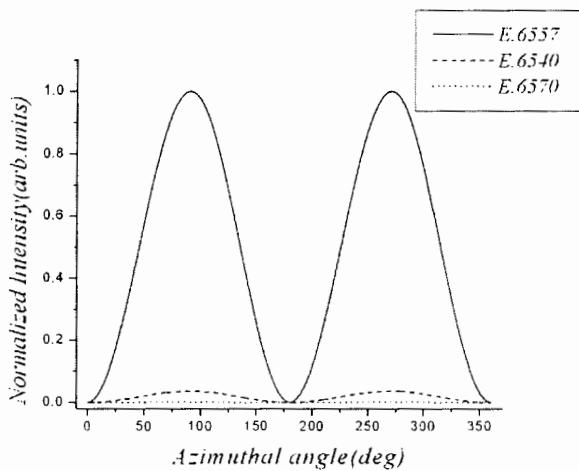
شکل ۱۱-۴: شدت پراکندگی بازتاب $\pi/2$ در کانال $\sigma - \sigma$ ناشی از نظم بار بر حسب زاویه سمتی. خط ممتد به ازای انرژی لبه جذب و خط های دیگر به ازای انرژی های دور از لبه جذب می باشد.

حال به بررسی نتایج حاصل از بازتاب ناشی از نظم اوربیتال می پردازیم. نمودار شدت بر حسب انرژی برای پیک $(k/2\pi, 0)$ در شکل ۱۲-۴ نشان داده شده است. تشدید در انرژی حدود 6557 eV اتفاق می افتد که به خوبی بستگی روت را نشان می دهد. همچنین شدت برای زاویه سمتی 90° بیشترین مقدار را دارد. لازم به ذکر است همان طور که معادله ۱۶-۴ نشان می دهد شدت این پیک در کانال $\sigma - \sigma$ صفر می باشد.



شکل ۱۲-۴: شدت پراکندگی بازتاب $k/2\pi, 0$ در کانال $\sigma - \sigma$ ناشی از نظم اوربیتال بر حسب انرژی برنتا، فرودی خط ممتد به ازای زاویه سمتی 90° و خط چین به ازای زاویه سمتی 30° می باشد.

شکل ۱۳-۴ وابستگی شدت بازتاب اوربیتال $/K_{200}, \sigma$ را به زاویه سمتی نشان می دهد که ماقریزم شدت در انرژی تشدید اتفاق می افتد و به طور مشابه وقتی از انرژی لبه جذب K اتم منگنز دور می شویم شدت تقریبا صفر خواهد شد. اگر جمله هر ناشی از پراکندگی تامسون را در نظر می گرفتیم یک مقدار ثابت غیر صفر بدهست می آمد.

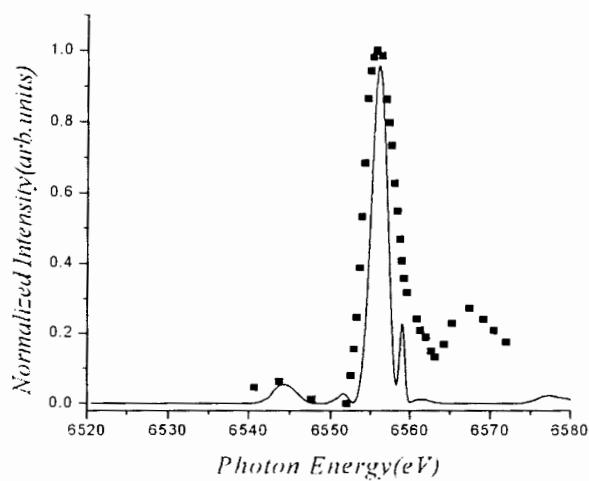


شکل ۱۳-۴: شدت پراکندگی بازتاب $/K_{200}, \sigma$ - ناشی از نظم اوربیتال بر حسب زاویه سمتی. خط ممتد به ازای انرژی لبه جذب و خط های دیگر به ازای انرژی های دور از لبه جذب می باشد.

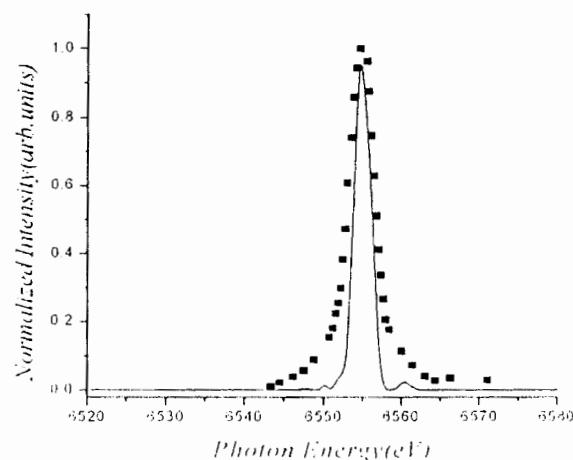
۵-۴ نتیجه گیری

مقایسه نتایج بدست آمده بر اساس این مدل و مقادیر اندازه گیری شده از بازتابهای نظم بار و اوربیتال در فاز دمای پایین MnO_2 ، $SrNd$ توسط مارتین و همکارانش [۲۲] و ناکامورا و همکارانش [۲۴] نشان می دهد که توافق نسبتاً خوبی وجود دارد که در شکل ۱۴-۴ تا ۱۷-۴ نشان داده شده است. در تمام شکل ها منحنی نشان داده شده توسط مربع های کوچک مربوط به داده های تجربی ذکر شده می باشد. در شکل های ۱۴-۴ و ۱۵-۴ شدت بازتاب های نظم بار و اوربیتال اندازه گیری شده از طریق تجربی را در کنار محاسبات انجام گرفته برای این یک ها در این پروژه، مشاهده می کنید. لازم به ذکر است که هر دو منحنی جهت مقایسه بهتر داده ها بد عدد یک نormalize شده اند. منحنی ها نشان می دهند که در مورد انرژی مربوط به تشدید و همچنین شکل عمومی منحنی ها، توافق خوبی بین این

نتایج و داده های تجربی وجود دارد.

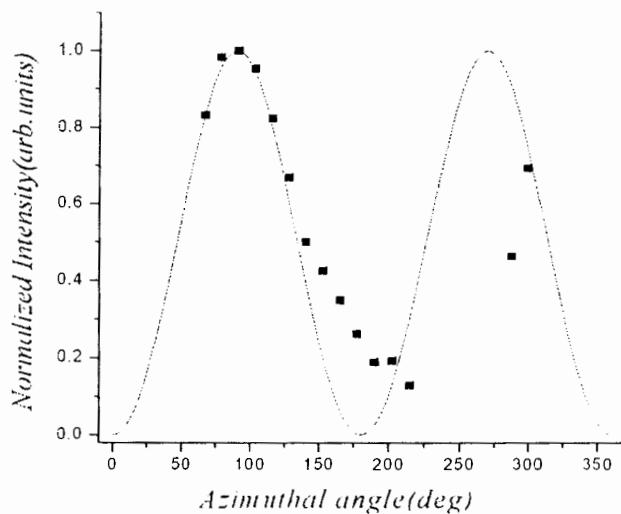


شکل ۱۴-۴: شدت بازتاب نظم بار σ - σ در کانال σ - σ بر حسب انرژی پرتو α . فروودی به ازای زاویه سمتی $\varphi = 90^\circ$ خط ممتد، بدست آمده از محاسبات و مریع ها نتیجه [۲۲] آزمایشات می باشد.



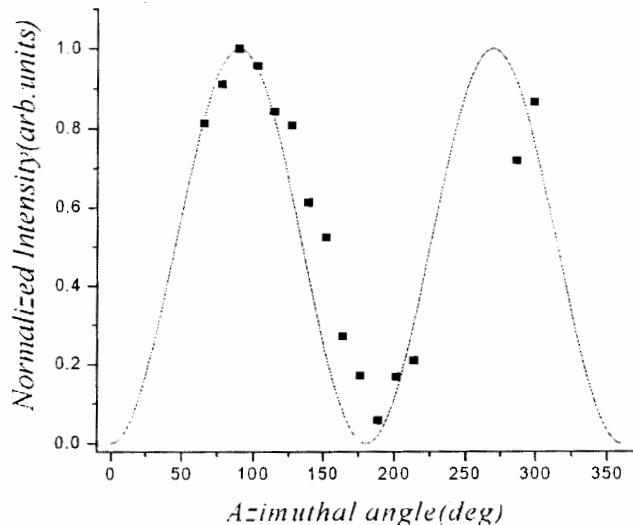
شکل ۱۵-۴: شدت بازتاب نظم اوربیتال π - π در کانال π - π بر حسب انرژی پرتو α . فروودی به ازای زاویه سمتی $\varphi = 90^\circ$. خط ممتد، بدست آمده از محاسبات و مریع ها نتیجه [۲۲] آزمایشات می باشد.

در شکل ۱۶-۴ و ۱۷-۴ تغییر شدت بر حسب زاویه سمتی برای بازتاب های ناشی از نظم بار به همراه نتایج تجربی (مربع ها) نشان داده شده است. در تجربه بعلت محدودیت هایی که در چرخش نمونه حول بردار پراکندگی وجود دارد که آن هم بدلیل دستگاه پراش سنج^۱ و آشکار سازها می باشد امکان دستیابی به تمام زوایای سمتی وجود ندارد. شکل ها نشان دهنده توافق نسبتاً خوبی با تجربه می باشند.



شکل ۱۶-۴: شدت بازتاب نظم بار / σ در کاتال σ -در انرژی لبه جذب، بر حسب زاویه سمتی. خط ممتد، بدست آمده از محاسبات و مربع ها نتیجه [۲۴] آزمایشات می باشد.

^۱ - diffractometer



شکل ۱۷-۴: شدت بازتاب نظم اوربیتال $(k/2.0, \pi - \sigma)$ در کanal در انرژی لبه جذب، بر حسب زاویه سمتی. خط ممتد، بدست آمده از محاسبات و مربع ها نتیجه [۲۴] آزمایشات می باشد.

نتایج بدست آمده در این پروژه بر اساس مدل انتخاب شده می تواند تاییدی بر وجود نظم شطرنجی^۱ در ترکیب MnO_r , $Sr..Nd..MnO_r$ بشد که دارای درصد آلایش ۵۰٪ یعنی حضور با نسبت مساوی Mn^{3+} و Mn^{4+} می باشد. بدین معنی که این یون های Mn با ظرفیت های $+3$ و $+4$ در دماهای پایین مطابق شکل ۱-۴ نظم می یابند که یکی از آنها Mn^{4+} فاقد الکترون در اوربیتال e_g و همسانگرد است و هشت وجهی منتظم دارد و دیگری Mn^{3+} با دارا بودن یک الکترون در اوربیتال e_g و داشتن آزادی اوربیتالی، ناهمسانگرد و هشت وجهی اعوجاج یافته دارد. همچنین نظم اوربیتالی الکترون های e_g نیز مطابق شکل ۲-۴ وجود دارد.

^۱ checkerboard pattern

مراجع

- [1] R. Kajimoto, T. Kakeshita, Y. Oohara, et.al., Physical Review B-Condensed Matter 58, R11837 (1998).
- [2] T. Hotta, Y. Takada, H. Koizumi, et.al., Physical Review Letters 84, 2477 (2000).
- [3] C. Frontera, J. L. Garcia-Munoz, A. Llobet, et.al., Physical Review B 62, 2002 (2000).
- [4] C. H. Chen and S. W. Cheong, Physical Review Letters 76, 4042 (1996).
- [5] P. G. Radaelli, D. E. Cox, M. Marezio, et.al., Physical Review Letters 75, 4488 (1995).
- [6] F. Millange, S. de Brion, and G. Chouteau, Physical Review B 62, 5619 (2000).
- [7] R. Kajimoto, H. Yoshizawa, H. Kawano, et.al., Physical Review B-Condensed Matter 60, 907 (1999).
- [8] S. Mori, T. Katsufuji, N. Yamamoto, et.al., Physical Review B-Condensed Matter 59, 12077 (1999).
- [9] R. Kajimoto, H. Yoshizawa, Y. Tomioka, et.al., Physical Review B 63 212407 (2001).
- [10] C. Frontera, J. L. Garcia-Munoz, A. Llobet, et.al., Journal of Physics-Condensed Matter 13, 1071 (2001).
- [11] H. Kawano, R. Kajimoto, H. Yoshizawa, et.al., Physical Review Letters 78, 4203 (1997).
- [12] H. Kuwahara, Y. Moritomo, Y. Tomioka, et.al., Physical Review B 56, 9381 (1997).
- [13] H. Kuwahara, Y. Tomioka, A. Asamitsu, et.al., Science 271, 971 (1995).
- [14] V. Caignaert, F. Millange, M. Hervieu, et.al., Solid State Communications 99, 173 (1996).
- [15] Y. Tomioka, A. Asamitsu, Y. Moritomo, et.al., Physical Review Letters 75, 5118 (1995).
- [16] Y. Tokura, H. Kuwahara, Y. Moritomo, et.al., Physical Review Letters 76, 3184 (1996).

- [17] H. Yoshizawa, R. Kajimoto, H. Kawano, et.al., Materials Science and Engineering B-Solid State Materials For Advanced Technology 63, 120 (1999).
- [18] P. M. Woodward, D. E. Cox, T. Vogt, et.al., Chemistry of Materials 11, 2028 (1999).
- [19] N. Fukumoto, S. Mori, N. Yamamoto, et.al., Physical Review B-Condensed Matter 60, 12917 (1999).
- [20] R. Mahesh and M. Itoh, Journal of Solid State Chemistry 144, 232 (1999).
- [21] V. Kiryukhin, B. G. Kim, T. Katsufuji, et.al., Physical Review B 63, 144406 (2001).
- [22] Javier Herrero-Martín, Joaquín García, et.al., Physical Review B 70, 024408 (2004).
- [23] Sumio. Ishihara, Sadamichi. Maekawa, Rep. Prog. Phys. 64, 0661 (2001)
- [24] K. Nakamura, T. Arima, A. Nakazawa, et.al., Physical Review B-Condensed Matter 60, 2420 (1999).
- [25] Stuart.W, PhD.thesis, 2007

ضمیمه الف)

این برنامه کامپیوتری که با استفاده از نرم افزار *Matlab* تهیه گردیده، این قابلیت را دارد که با گرفتن f' و f'' ماده، شدت بازتابهای ناشی از نظم بار و نظم اوربیتال را محاسبه نماید.

```
w=1;
%% this section of project open a file and read f'&f'' of material
%% and then calculated the fparallel and fperpendicular
for I = 1:121
    a\1(I)=data(I, 1);a\2(I)=data(I, 2);
end
%% a\1 is fparallel and a\2 is energy offparallel
a = a\1';
energya = a\2'
for I = 1:121
    b\1(I)=data(I, 1);b\2(I)=data(I, 2)+ 1.5;
end
%% b\1 is fperpendicular and b\2 is energy offperpendicular
b=b\1'
energyb = b\2'
%% then open a file and read f of MnF+
for I = 1:121
    d\1(I)=data(I, 1);d\2(I)=data(I, 2);
end
%% or calculate the f of MnF+ as below
for I = 1:121
    for j = 1:121
        if b\2(j) == a\2(I)
            c\1(j)=(a\1(I).1.*b\1(j))/2;c\2(j)=b\2(j);
            d\1(j)=c\1(j);d\2(j)=c\2(j).1;
        end
    end
end
```

```

    end
end
%% c\ is fanisotropy and c\ is its energy
%% d\ is f of Mn\+ and d\ is its energy
c = c\'
energyc = c\''
d = d\'
energyd = d\''
% .....
for I = 1:121
    m(I, 1) = a\*(I); m(I, 2) = a\*(I); m(I, 3) = b\*(I);
    m(I, 4) = b\*(I); m(I, 5) = d\*(I); m(I, 6) = d\*(I);
end
m
% .....
%% this section of project predicte the intensity of Charg Ordering(sigma to sigma)
%% the energy dependence of Intensity
x = pi/4;
for I = 1:121
    for j = 1:121
        if m(I, 1) == m(j, 4)
            y = (m(j, 1) + m(I, 2) - 2 * m(I, 3)) / z = 2 * (m(j, 1) - m(I, 3));
            in\*(I, 1) = ((y * sin(x)) ^ 2 + (z * cos(x)) ^ 2) ^ 0.5;
        end
    end
end
in\
save('e:\matlab\work\in\','in','ASCII','DOUBLE')
figure; plot(m(:, 1), in(:, 1)); xlabel('Photon Energy(eV)'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%% \-The azimuthal angle of Intensity
energyV = 2000;
for I = 1:121
    for j = 1:121
        if m(I, 1) == energyV
            if m(j, 1) == energyV
                y = (m(j, 1) + m(I, 2) - 2 * m(I, 3)) / z = 2 * (m(j, 1) - m(I, 3));
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
end
for x =.: (pi /%*);%*pi
    inr( w , \ )=(((y*(sin(x).^%*))+z*(cos(x).^%*))).^%*;w=w+1;
end
inr
save('e:\matlab\work\inr','inr','-ASCII','-DOUBLE')
x=.: (pi /%*);%*pi;
figure; plot(x,inr( : , \ )); xlabel('angle'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%
%%%% this section of project predicte the intensity of Charg Ordering(sigma to pi)
%%%% the energy dependence of Intensity
w=\;
x=pi/%;
teta=pi/%;
for i=\: \%1
    for j=\: \%1
        if m(I , \ )==m(j , % )
            y% = m(j , % )-m(I , % );
            inr( I , \ )=(y% *sin(x)*cos(x)*sin(teta)).^%*;
        end
    end
end
inr
save('e:\matlab\work\inr','inr','-ASCII','-DOUBLE')
figure;plot(m( : , % ),inr( : , \ )); xlabel('Photon Energy(eV)'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%%%% % -The azimuthal angle of Intensity
energy=%d%*;
for I =\: \%1
    for j =\: \%1
        if m(I , \ )== energy
            if m(j , % )== energy
                y% =m(j , % )-m(I , % );
            end
    end
end

```

```

        end
    end
end
y\pi
for x =.: (pi/\pi.):pi
    in\pi( w , \ )=(y\pi*sin(x)*cos(x)*sin(theta)).^pi;w = w+1;
end
in\pi
save('e:\matlab\work\in\pi','in\pi','-ASCII','-DOUBLE')
x=.: (pi / \pi.):pi;
figure; plot(x,in\pi( : , \ )); xlabel('angle'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%.....%
%% this section of project predicte the intensity of Orbital Ordering(sigma to pi)
%% the energy dependence of Intensity
w=\pi;
x = pi/\pi;
theta = pi/\pi;
for I = 1:100
    for j = 1:100
        if m(I, \ )==m(j, \ )
            y\pi=(m(j, \ )-m(I, \ )).^pi;
            in\delta( I , \ )=(y\pi*sin(x)*cos(theta)).^pi;
        end
    end
end
in\delta
save('e:\matlab\work\in\delta','in\delta','-ASCII','-DOUBLE')
figure; plot(m( : , \ ),in\delta( : , \ )); xlabel('Photon Energy(eV)'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%% \pi-The azimutal angle of Intensity
energy = 5000;
for I = 1:100
    for j = 1:100
        if m(I, \ )==energy
            if m(j, \ )==energy
                y\pi=m(j, \ )-m(I, \ );
            end
        end
    end

```

```
    end
end
end

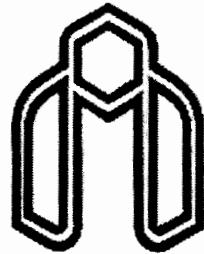
y=
for x = .:(pi / 8.):8*pi
    inr( w , \ )=(y* sin(x)*cos(theta)).^8;w =w+\;
end
inr
save('e:\matlab\work\inr','inr','-ASCII','-DOUBLE')
x=.:(pi / 8.):8*pi;
figure; plot(x,inr( : , \ )); xlabel('angle'); ylabel('Intensity(arb.unit)');
%.....
```

ضمیمه ب)

مربوط به $CaMnO_3$ و $LaMnO_3$ بر حسب انرژی

انرژی (eV)	f'' of $LaMnO_3$	f'' of $CaMnO_3$	انرژی (eV)	f'' of $LaMnO_3$	f'' of $CaMnO_3$
6020,0	11,1000,7	11,1371,7	6041	11,6928,8	11,7822
6021	11,1000,7	11,1371,7	6041,0	11,7181,0	11,8473,9
6021,0	11,1000,7	11,1371,7	6042	11,7537,4	11,9228,4
6022	11,1000,7	11,1371,7	6042,0	11,7767,8	12,0310,7
6022,0	11,1000,7	11,1371,7	6043	11,7974,8	12,1008,0
6023	11,1000,7	11,1372,8	6043,0	11,8111,8	12,1488,0
6023,0	11,1000,7	11,1371,0	6044	11,8248,7	12,1641,3
6024	11,1000,7	11,1371,0	6044,0	11,8381,7	12,1741,3
6024,0	11,1000,7	11,1371,0	6045	11,87	12,1879,1
6025	11,1000,7	11,1371,0	6045,0	11,91...71	12,1117,1
6025,0	11,1000,7	11,1371,0	6046	11,9238,9	12,0802,0
6026	11,1000,7	11,1371,0	6046,0	11,9819,8	12,002,2
6026,0	11,1372,1	11,7191,0	6047	11...	12,0292,2
6027	11,1372,1	11,7191,0	6047,0	12,0282,5	12,004,7
6027,0	11,1372,1	11,7191,0	6048	12,0914,9	12,004,7
6028	11,1372,1	11,7191,0	6048,0	12,0829,6	12,004,7
6028,0	11,1372,1	11,7191,0	6049	12,01...31	12,0424
6029	11,1372,1	11,7191,0	6049,0	11,8732,4	12,0161,1
6029,0	11,1372,1	11,7191,0	6050	11,9...972	12,1661,1
6030	11,1372,1	11,7191,0	6050,0	12,0358,2	12,2208,0
6030,0	11,1372,1	11,7191,0	6051	12,0998,3	12,2098,8
6031	11,1372,1	11,7191,0	6051,0	12,1176,8	12,2889,2
6031,0	11,1372,1	11,7191,0	6052	12,1102,7	12,200,5
6032	11,1372,1	11,7191,0	6052,0	12,4242,7	12,2212,4
6032,0	11,7179,2	11,7191,0	6053	12,6482,5	12,1066,2
6033	11,7179,2	11,7191,0	6053,0	12,8581,0	12,0626
6033,0	11,7179,2	11,7191,0	6054	12,0527	11,9293,9
6034	11,7179,2	11,7191,0	6054,0	12,2267,8	11,7502
6034,0	11,7179,2	11,7191,0	6055	12,4103,7	11,7911,4
6035	11,7179,2	11,7191,0	6055,0	12,5529,5	11,7378
6035,0	11,7179,2	11,7191,0	6056	12,6879,7	11,9973,9
6036	11,7179,2	11,7191,0	6056,0	12,7718,9	12,3827
6036,0	11,7179,2	11,7191,0	6057	12,8...27	12,8480,8
6037	11,7179,2	11,7191,0	6057,0	12,7932,8	12,4337,9
6037,0	11,5995,2	11,7191,0	6058	12,7611,3	12,111,97
6038	11,5995,2	11,7191,0	6058,0	12,7...472	12,6423,3
6038,0	11,5995,2	11,7191,0	6059	12,6173	12,6452,5

7029	11,71883	11,729+2	7059,0	11,0288	11,72993
7029,0	11,72293	11,72709	707+	11,47002	11,72993
703+	11,72791	11,72887	707+,0	11,414+2	11,72823
7070,0	11,72871	11,72902			
7077	11,72+77	11,72224			
7077,0	11,72172	11,72003			
7077	11,72018	11,72874			
7077,0	11,72871	11,72122			
7078	11,727+9	11,72122			
7078,0	11,72888	11,72891			
7079	11,72923	11,72891			
7079,0	11,72923	11,720197			
708+	11,72923	11,720227			
708+,0	11,72923	11,720227			
7081	11,72923	11,720227			
7081,0	11,729+17	11,720227			
7082	11,72721	11,720227			
7082,0	11,720078	11,72728			
7083	11,72320	11,72966			
7083,0	11,72+88	11,72928			
7084	11,72797	11,721107			
7084,0	11,724227	11,721107			
7085	11,72+21	11,721107			
7085,0	11,722776	11,721107			
7086	11,72+66	11,721107			
7086,0	11,721950	11,728872			
7087	11,72+18	11,720474			
7087,0	11,72993	11,72+428			
7088	11,72+199	11,725298			
7088,0	11,72+7297	11,72+720			
7089	11,72+0207	11,728+8			
7089,0	11,72+3387	11,72+22+47			
708+	11,72+192	11,72+122			



**Shahrood University of Technology
Faculty of physics**

Theoretical study of resonant X-ray scattering

By:

A.Mohammadi Tabar

Supervisor:

Dr. M.E.ghazi

Dr. H.Arabshahi

July 2005